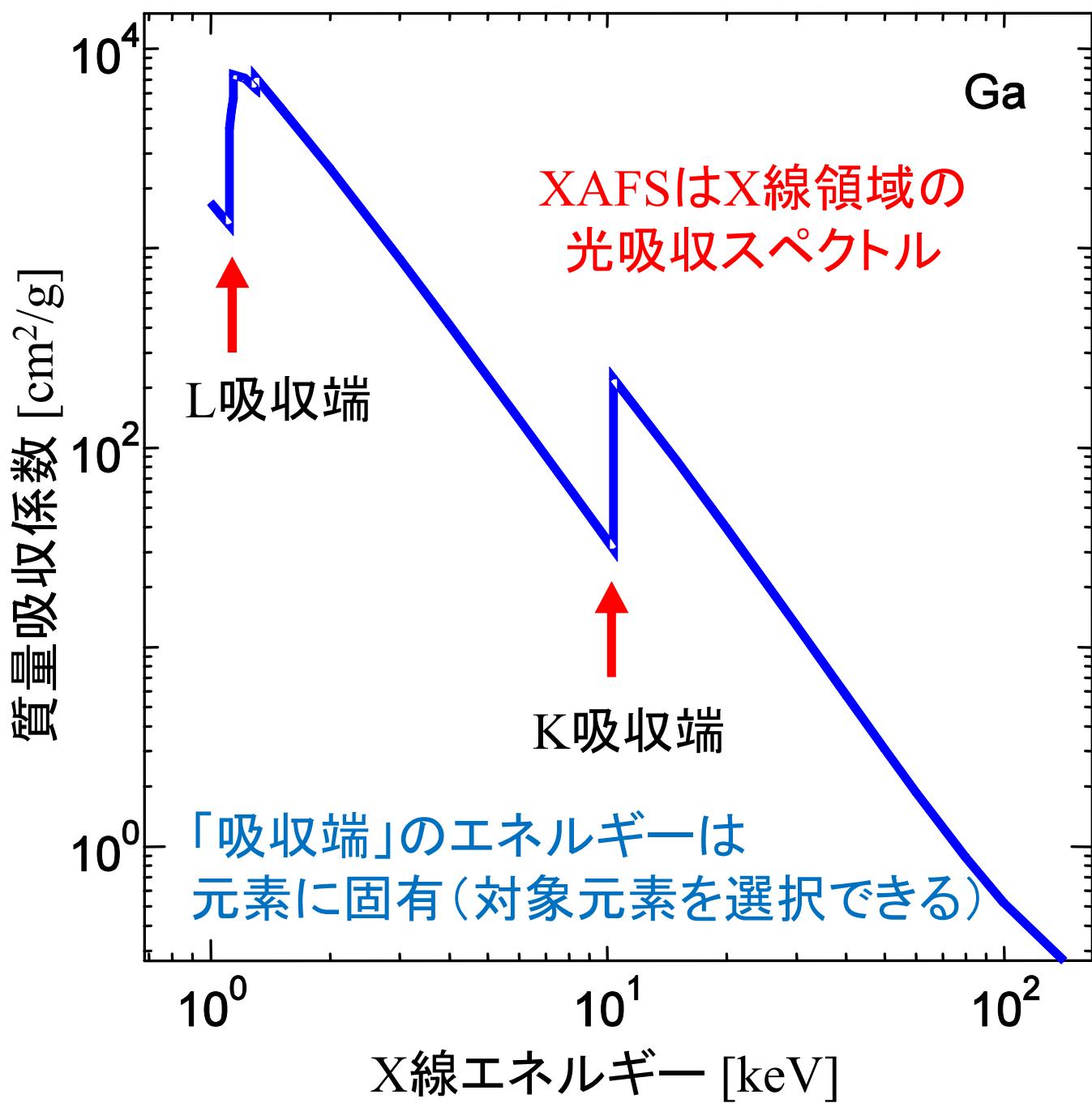
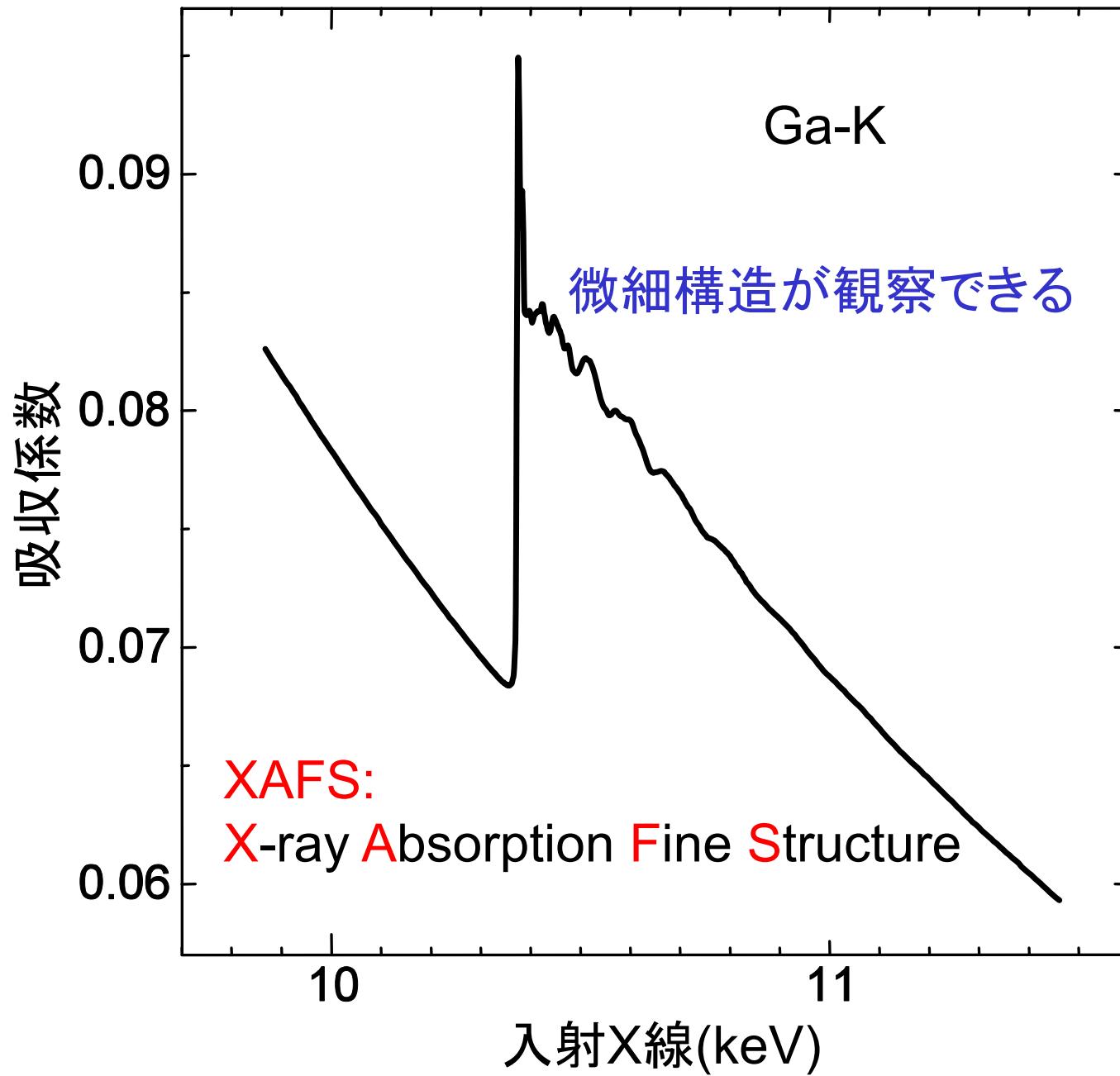


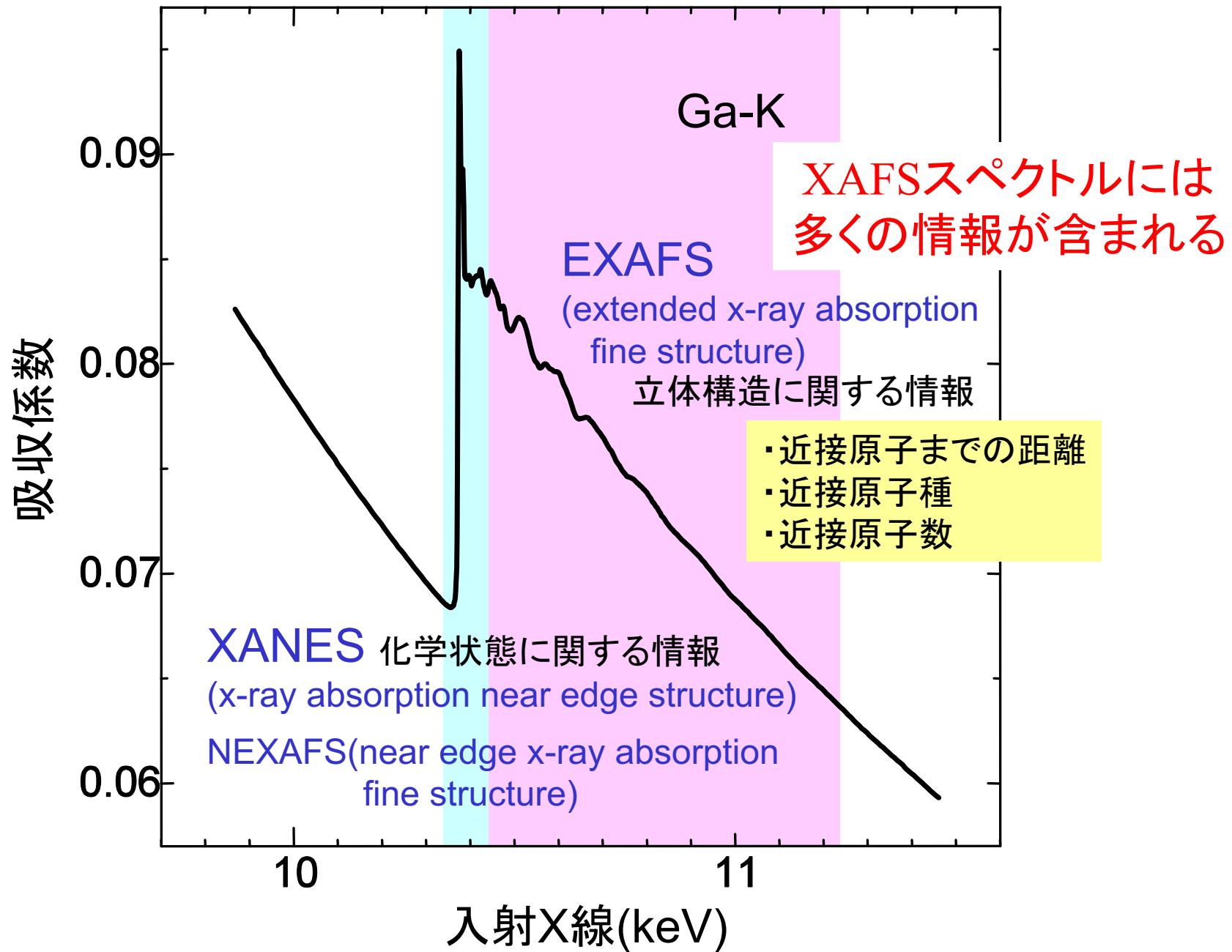
平成30年10月15日(月)
シンクロトロン光利用者研究会 入門講習会

XAFS測定入門

名古屋大学 シンクロトロン光研究センター
田渕雅夫



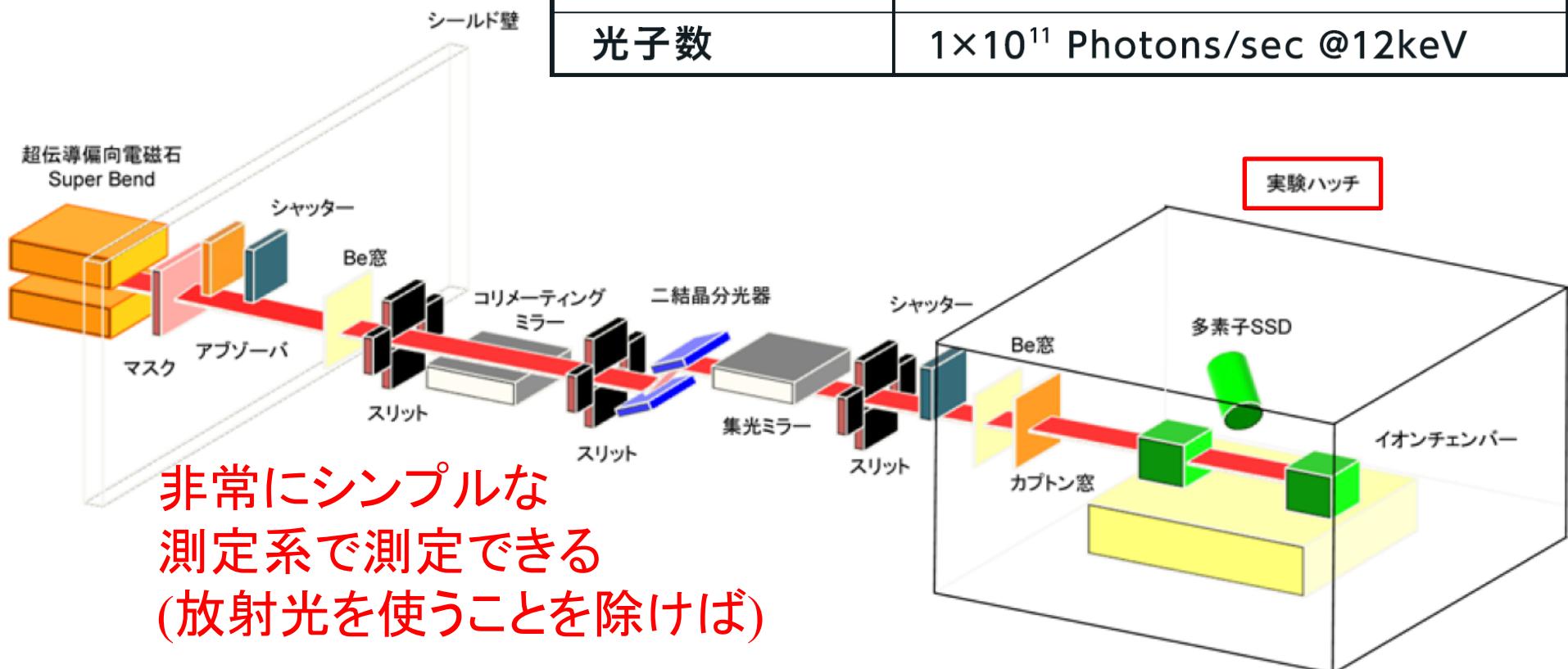




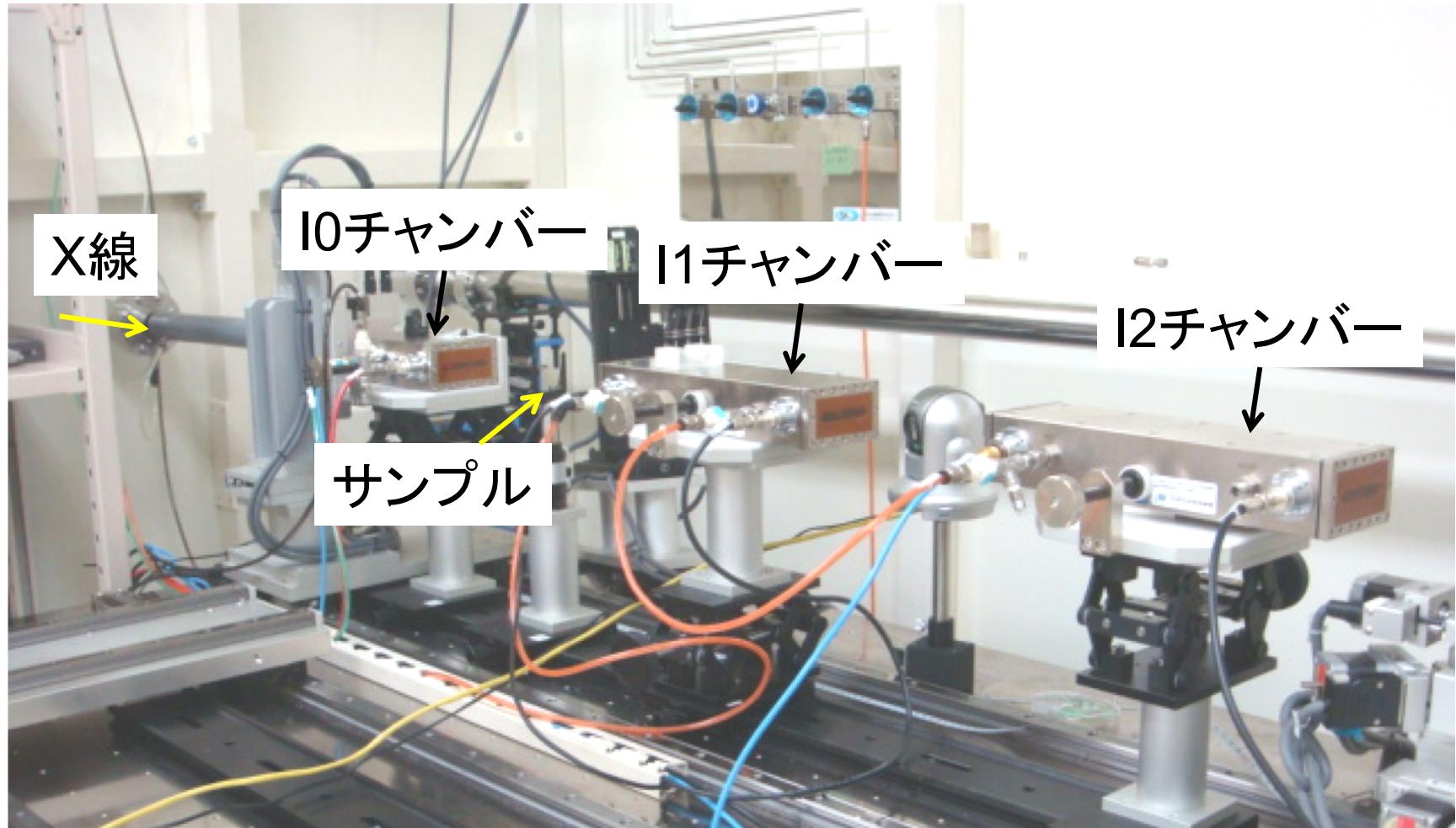
ビームライン概略図

1 BL5S1: 硬X線XAFS・蛍光X線

光エネルギー	5~20keV (0.25~0.06nm)
ビームサイズ[H×V]	0.5mm×0.3mm
分解能[E/ΔE]	7000 @12keV
光子数	1×10 ¹¹ Photons/sec @12keV

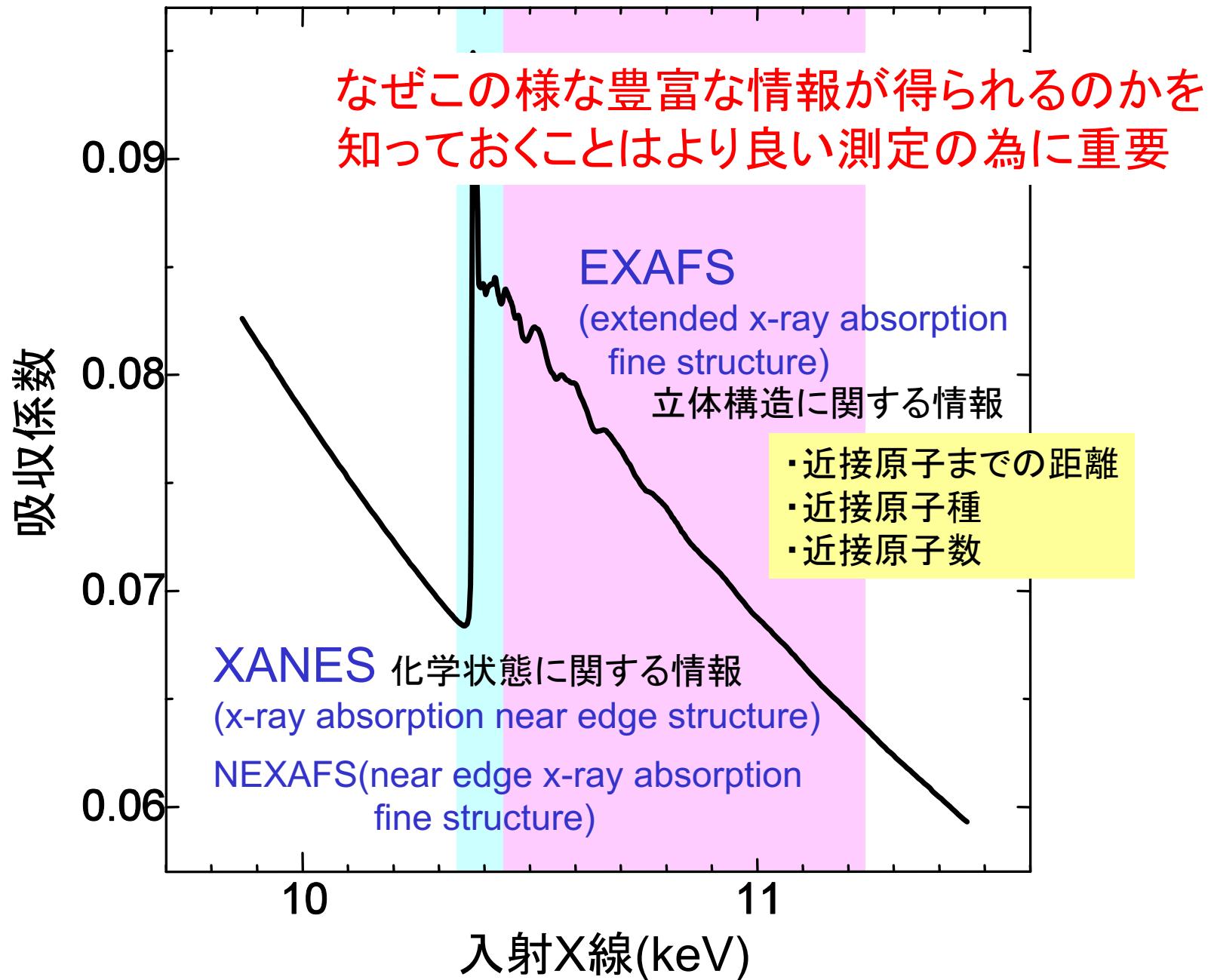


実験ハッチ内の様子

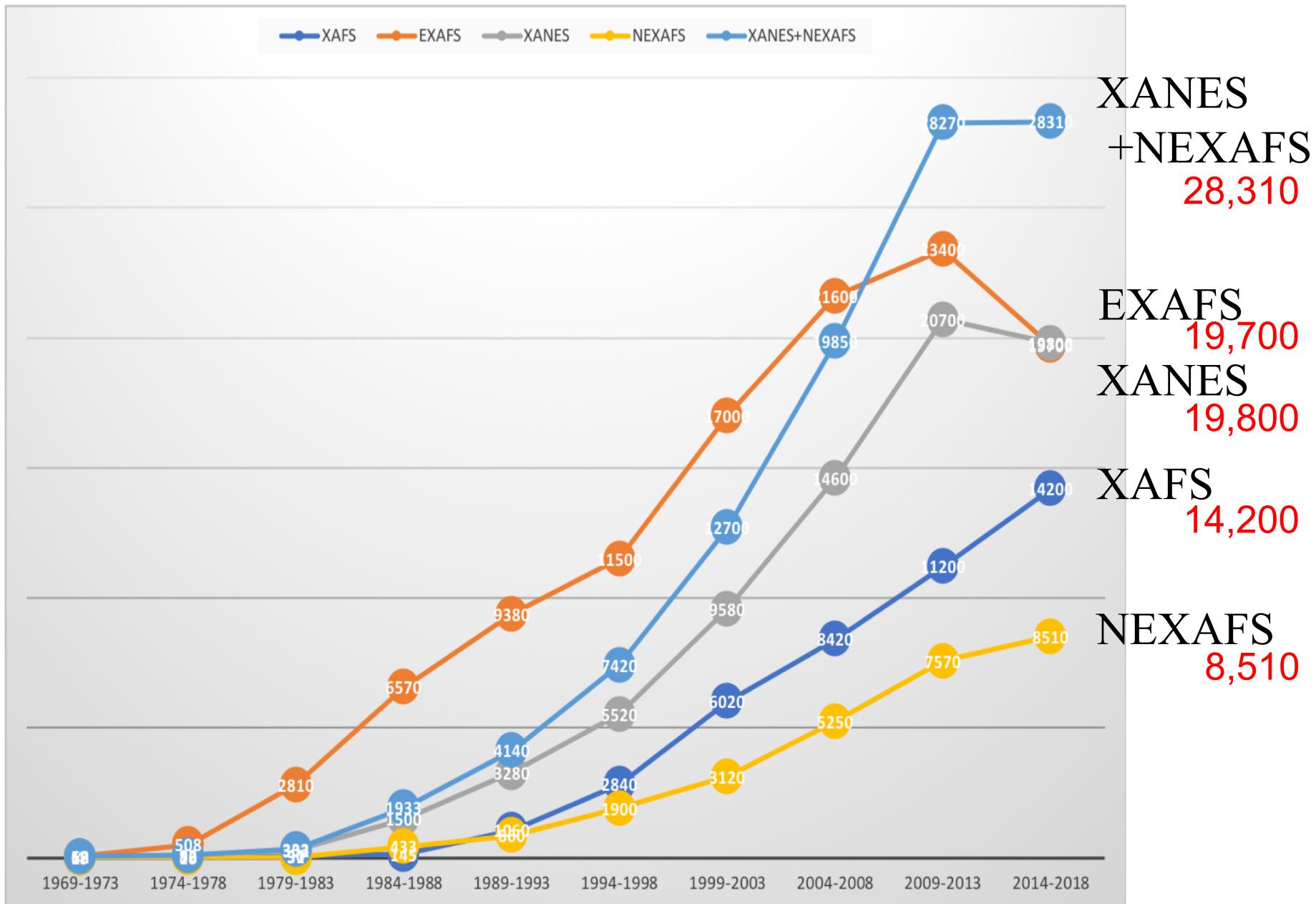


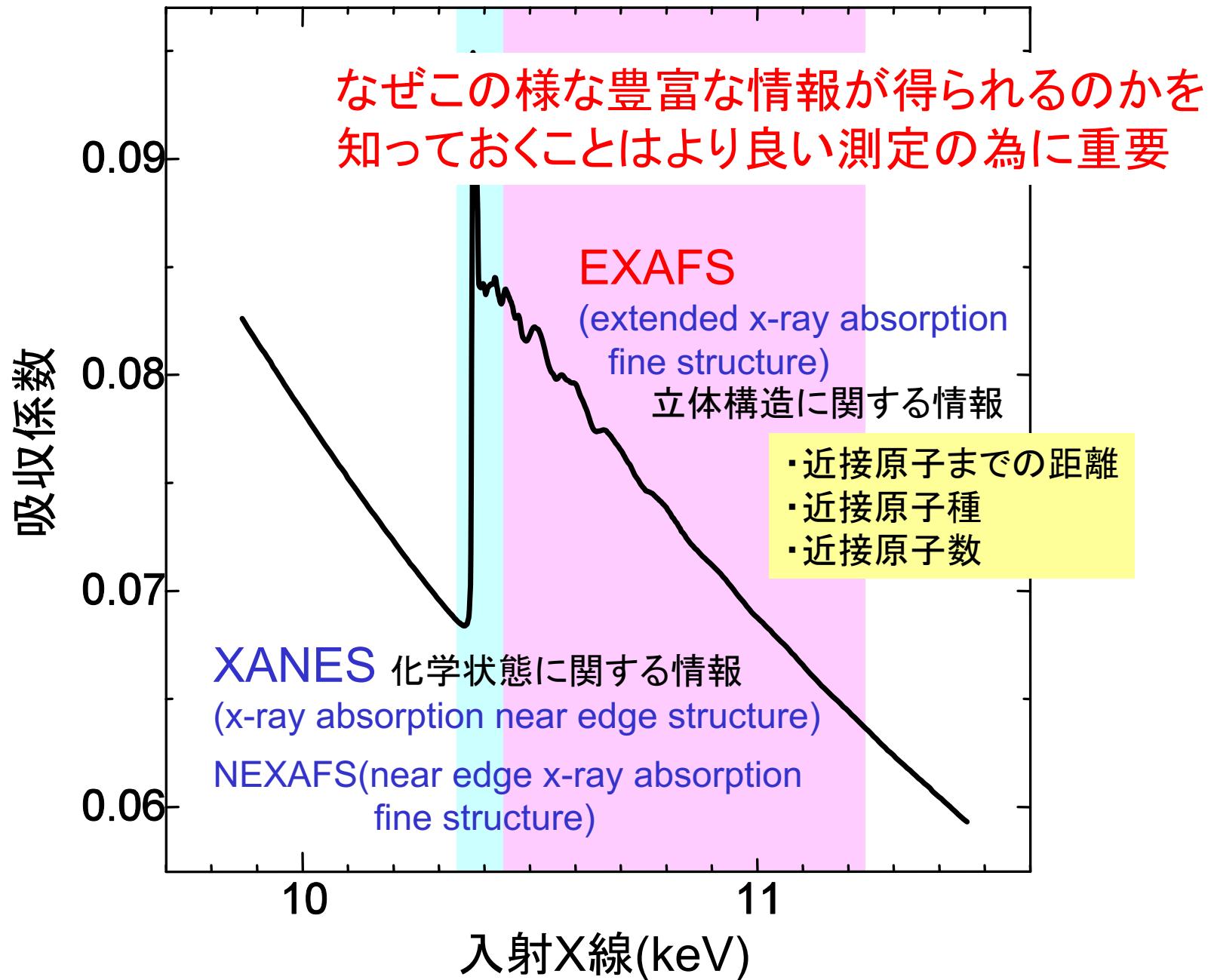
シンプルな測定系で測定できるので
試料周りが複雑であることが可能。

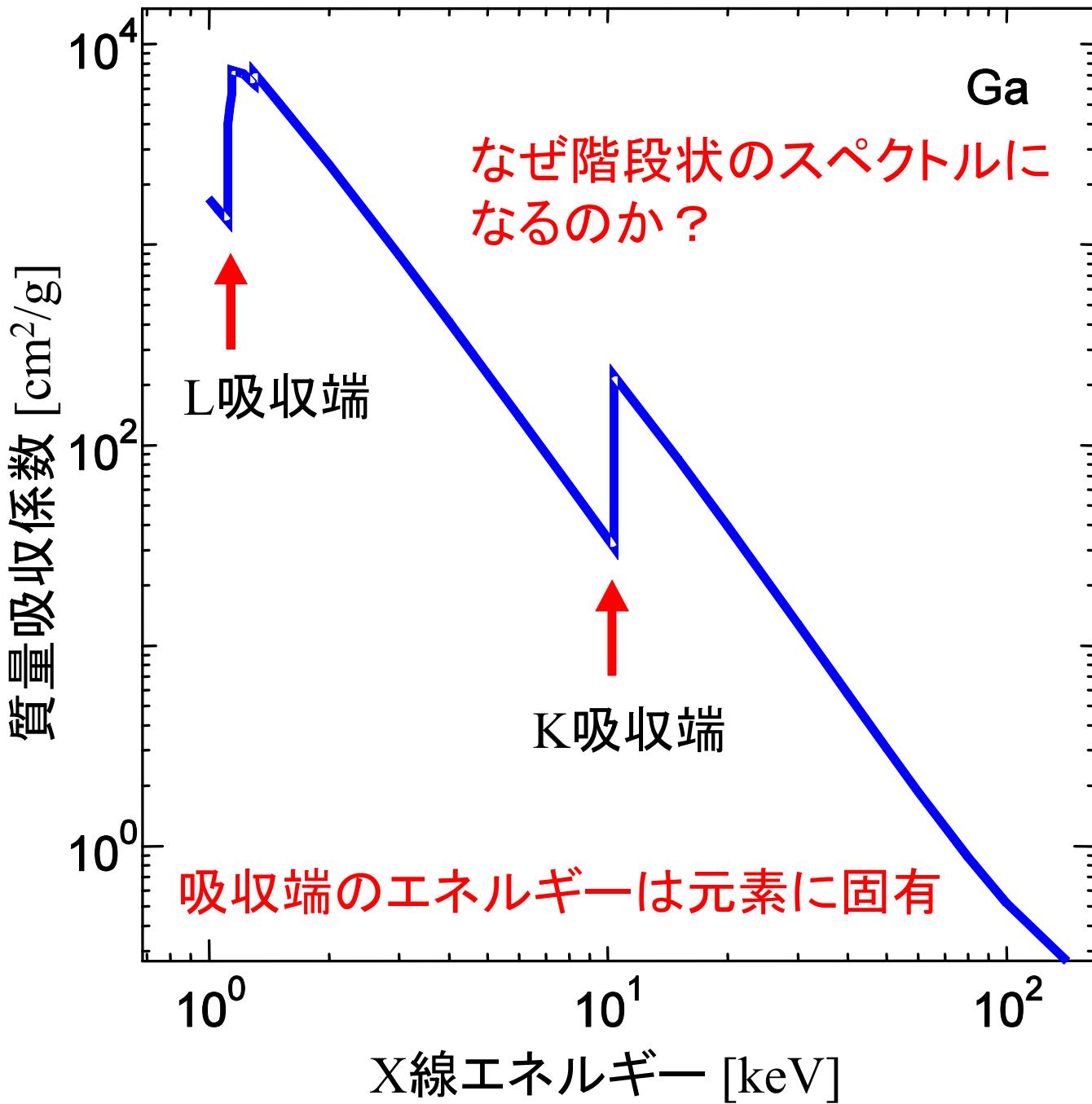
実環境測定、その場測定、運動させながらの測定...

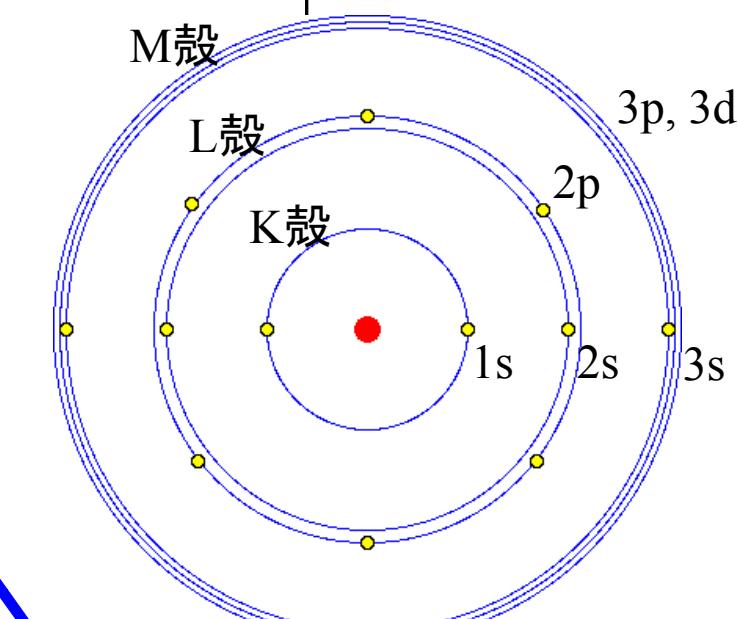
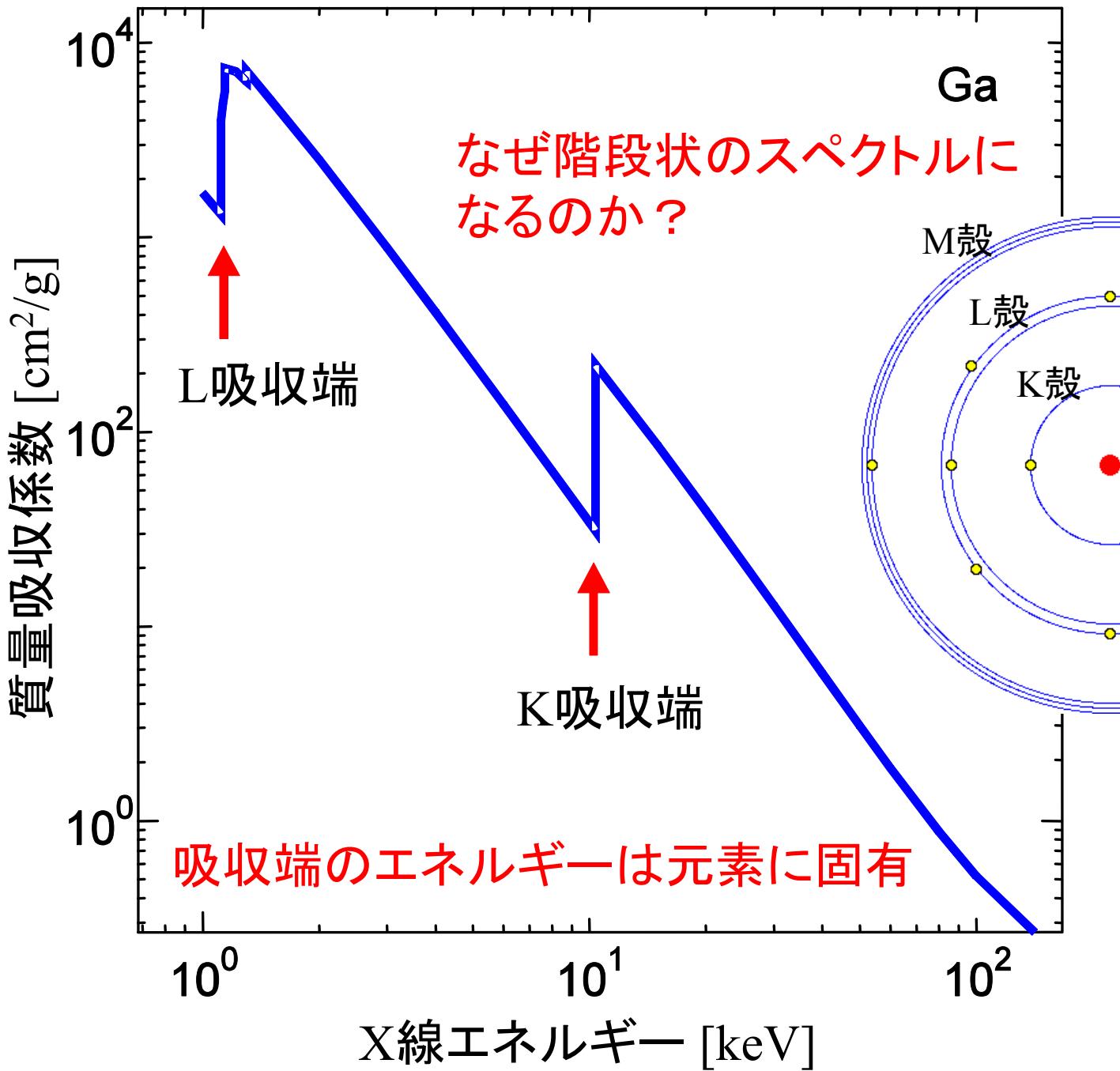


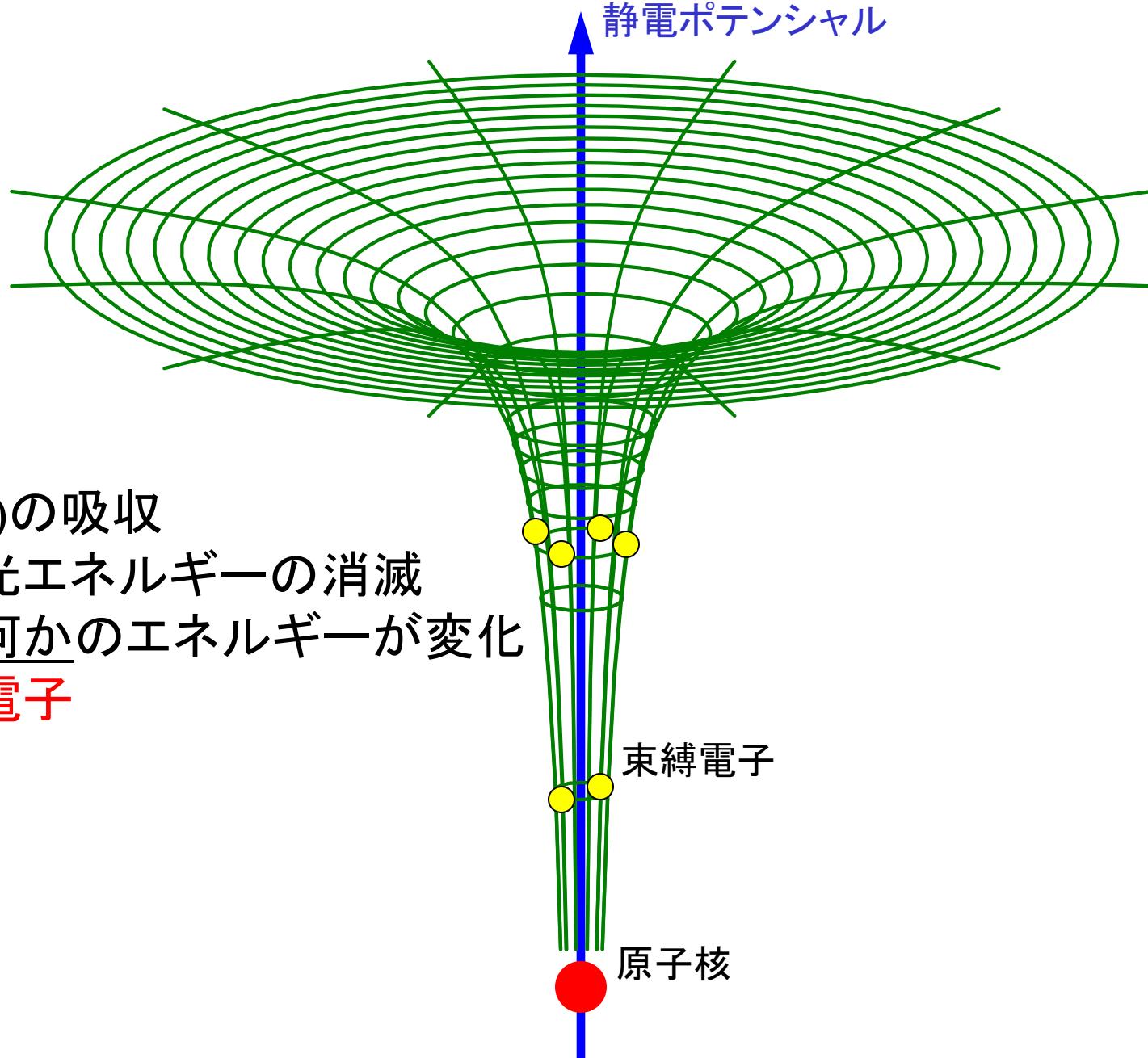
Google Scholar でのヒット件数

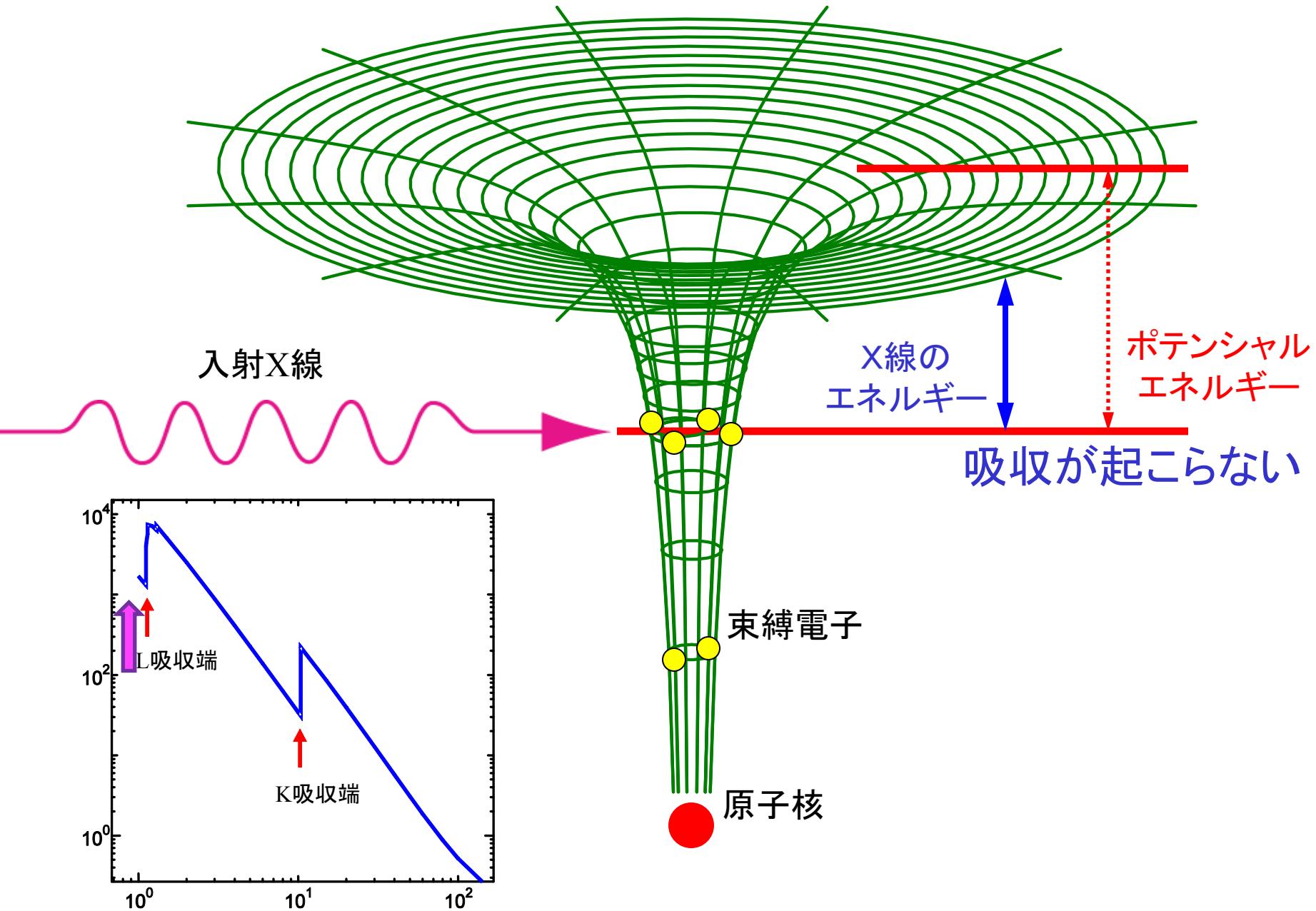


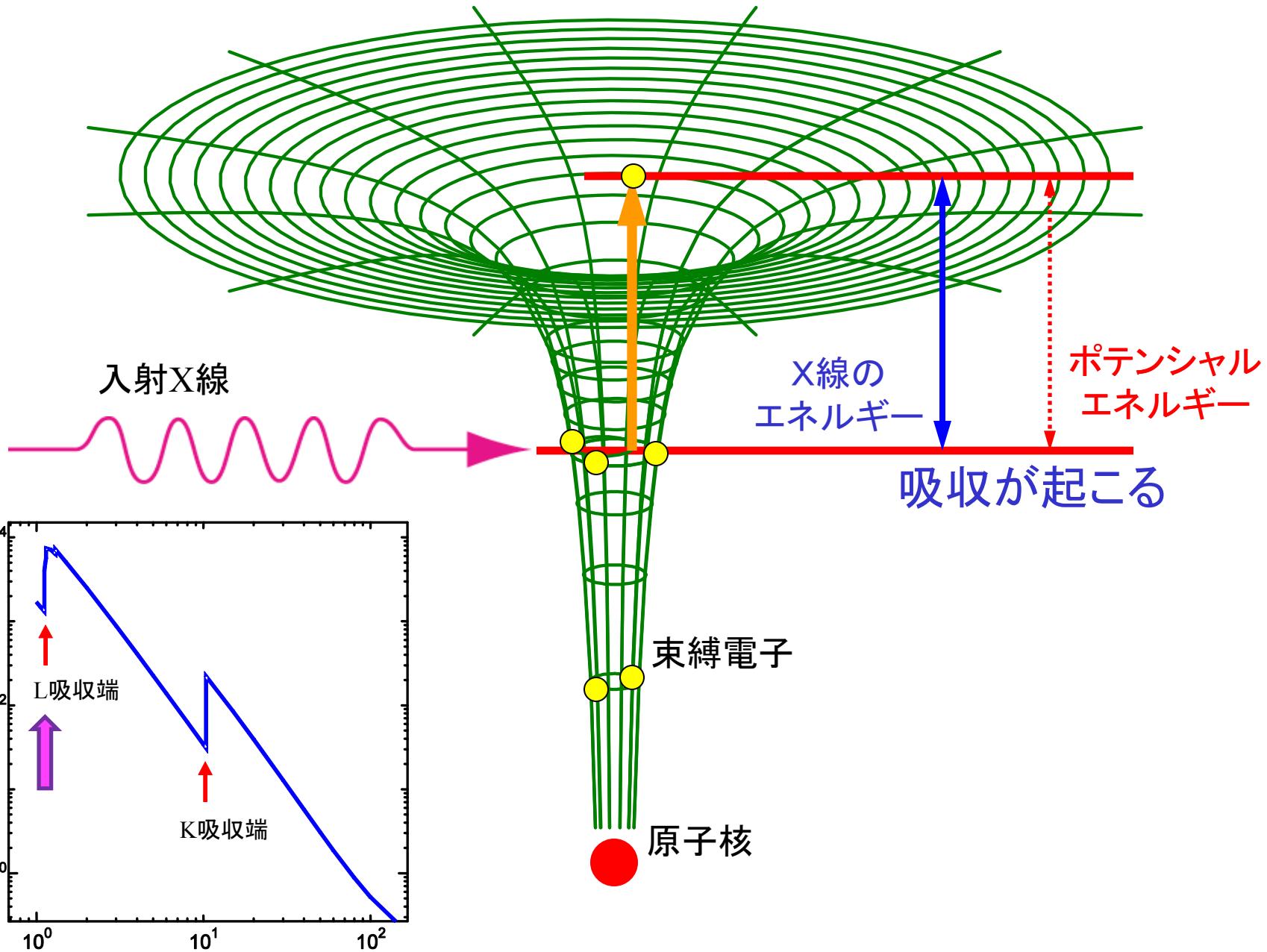


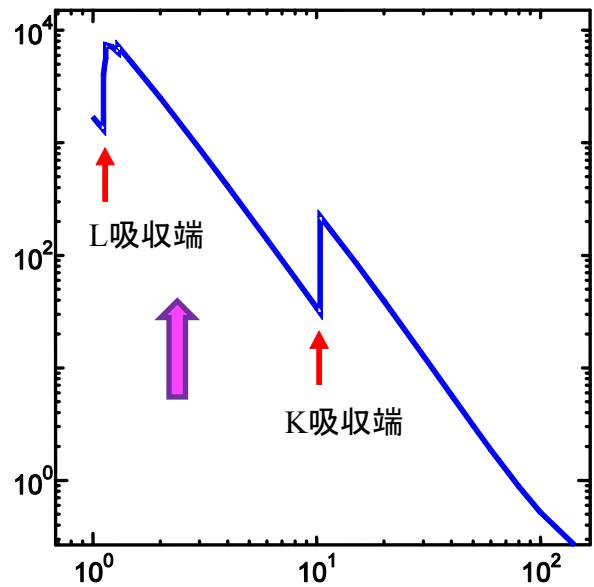
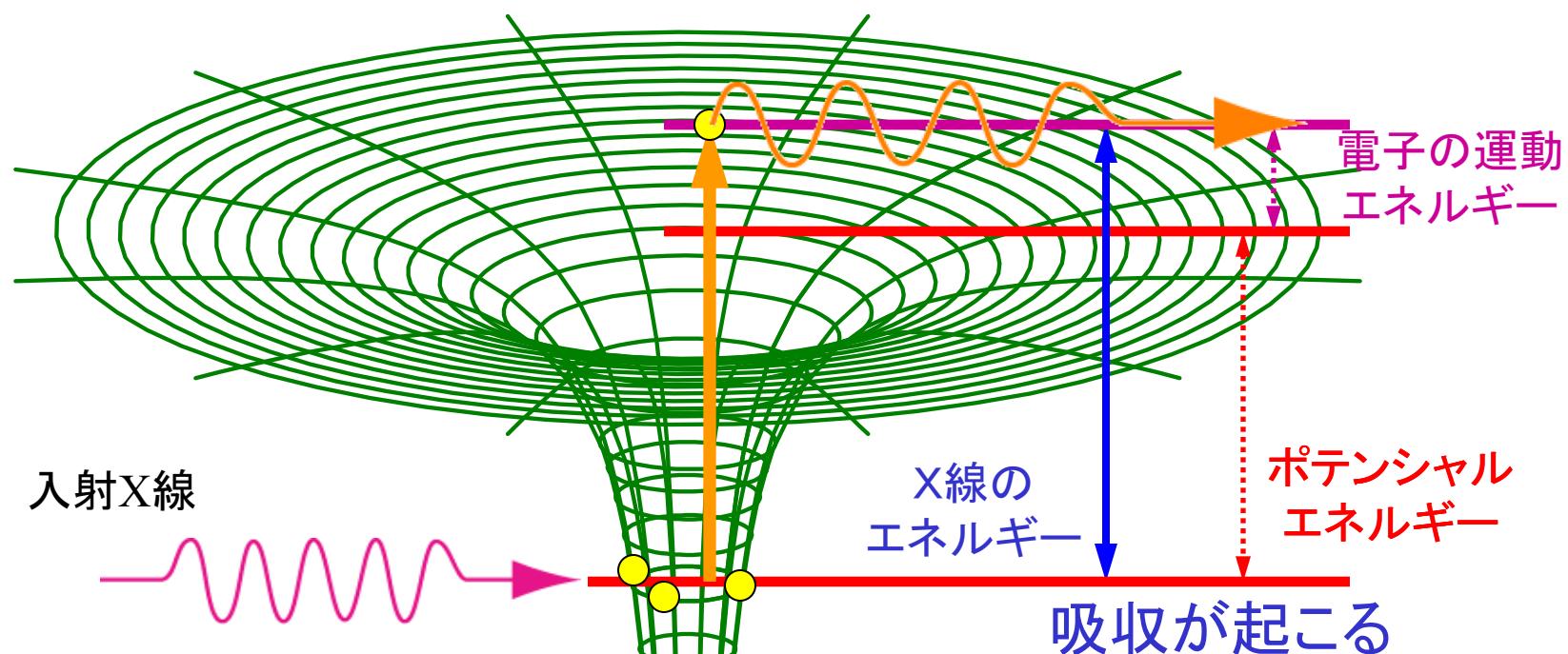


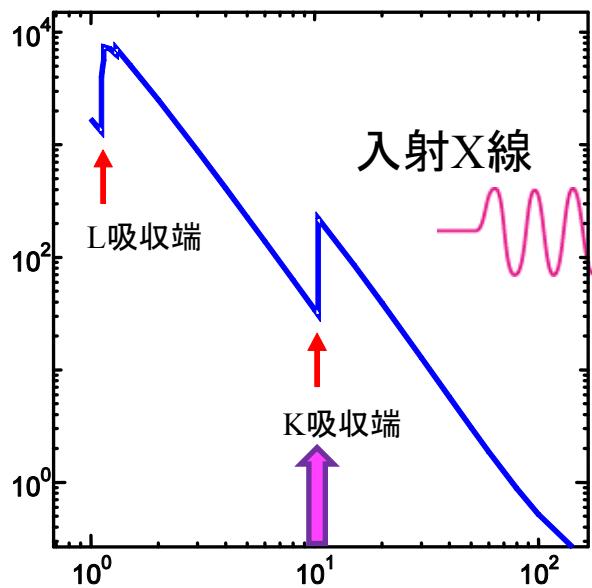
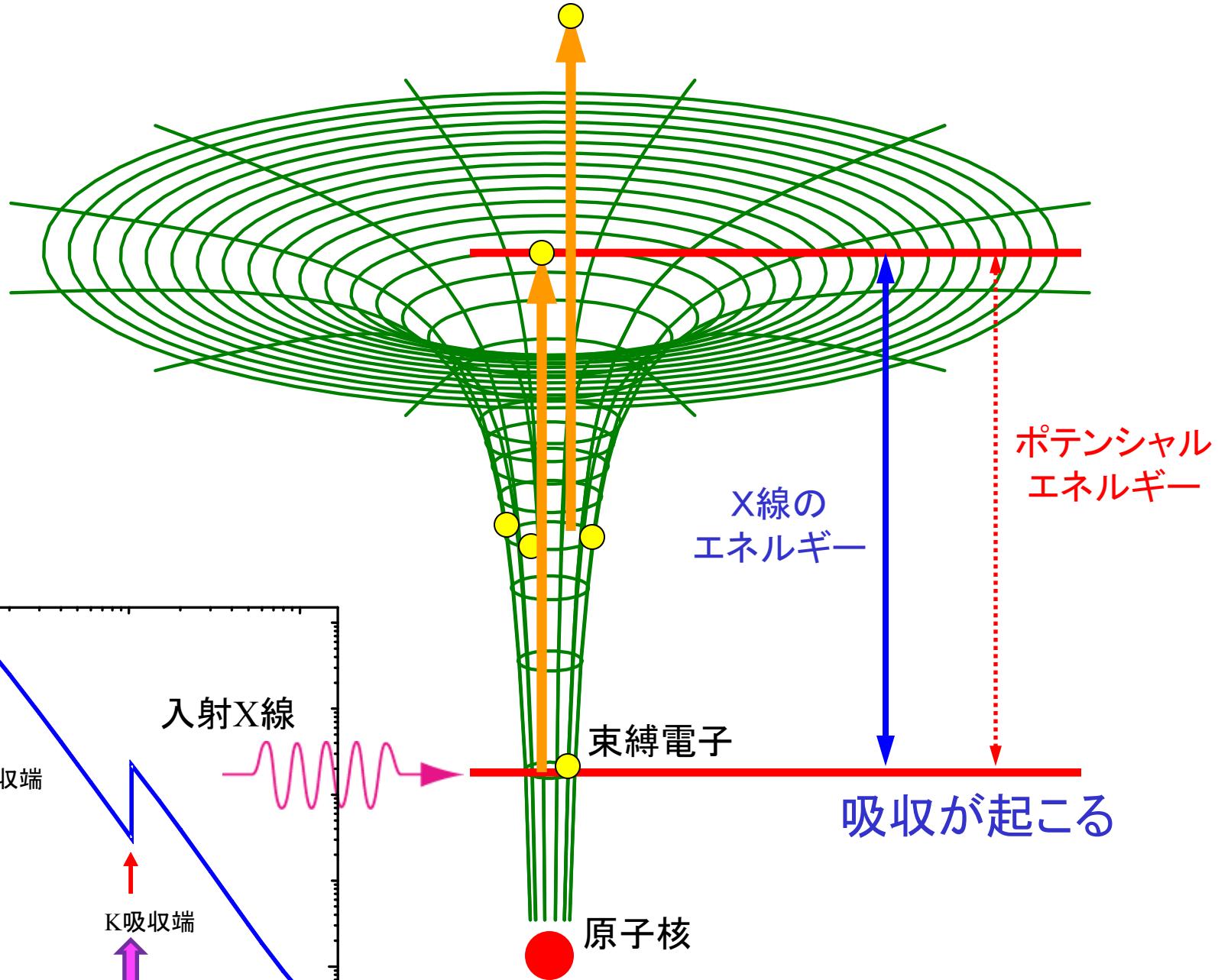


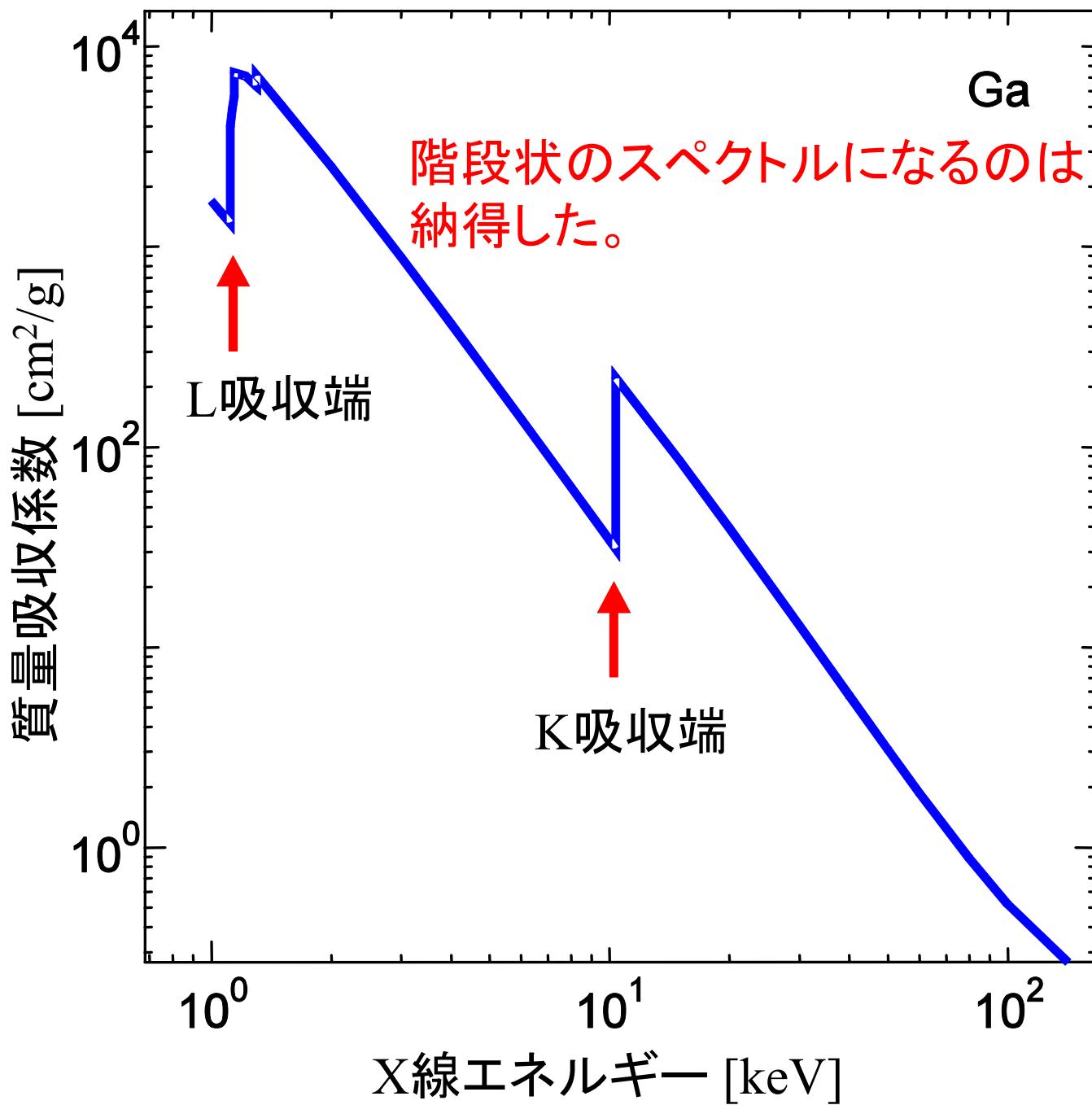


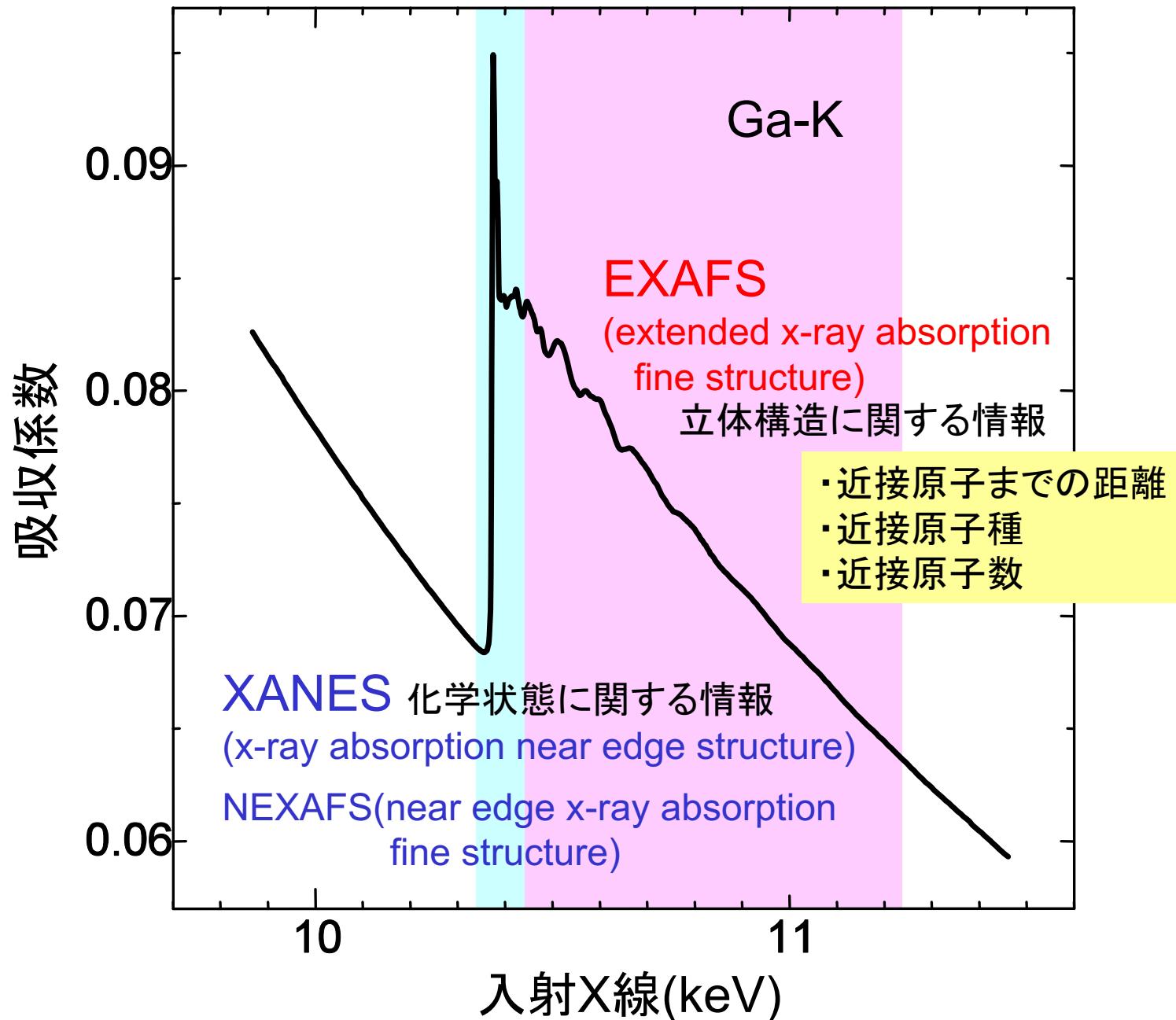








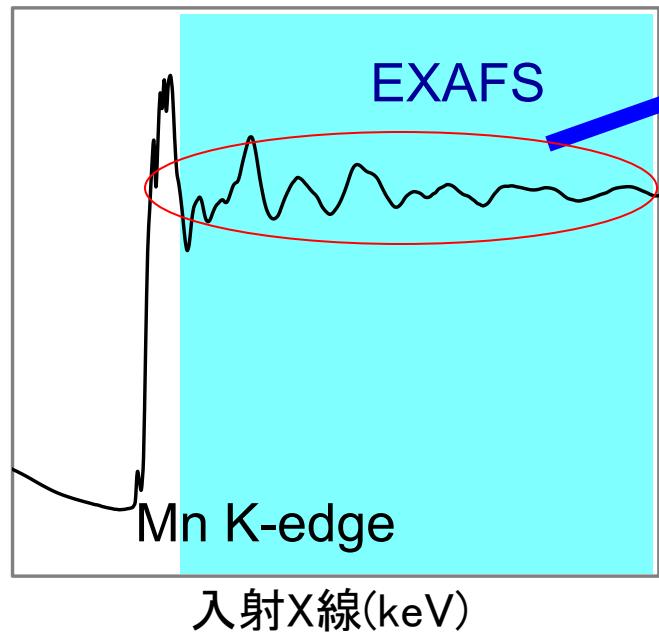




EXAFS(Extended X-ray Absorption Fine Structure)

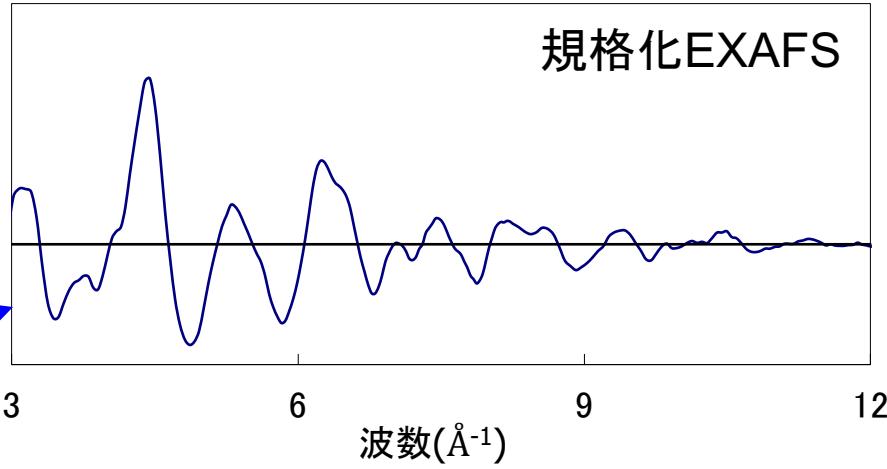
ZnGa₂O₄:Mn

蛍光X線強度



入射X線(keV)

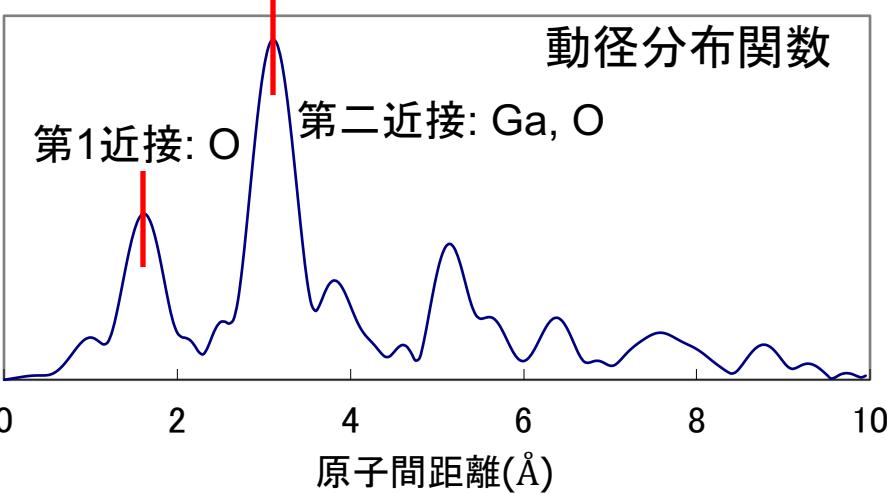
$K_X(k)$ [a.u.]



規格化EXAFS

フーリエ変換

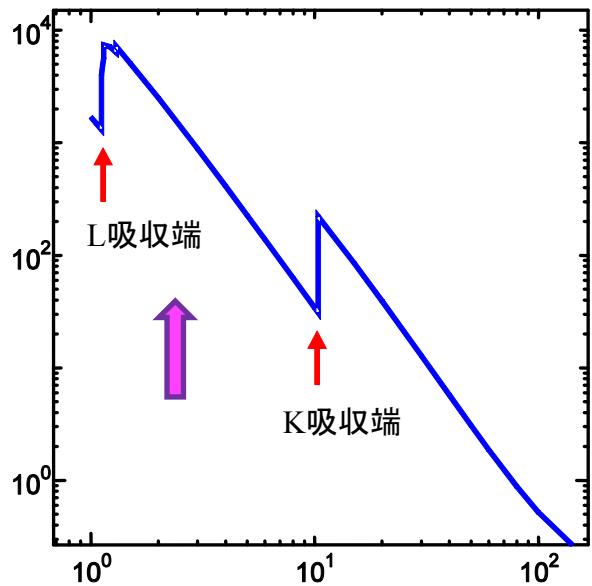
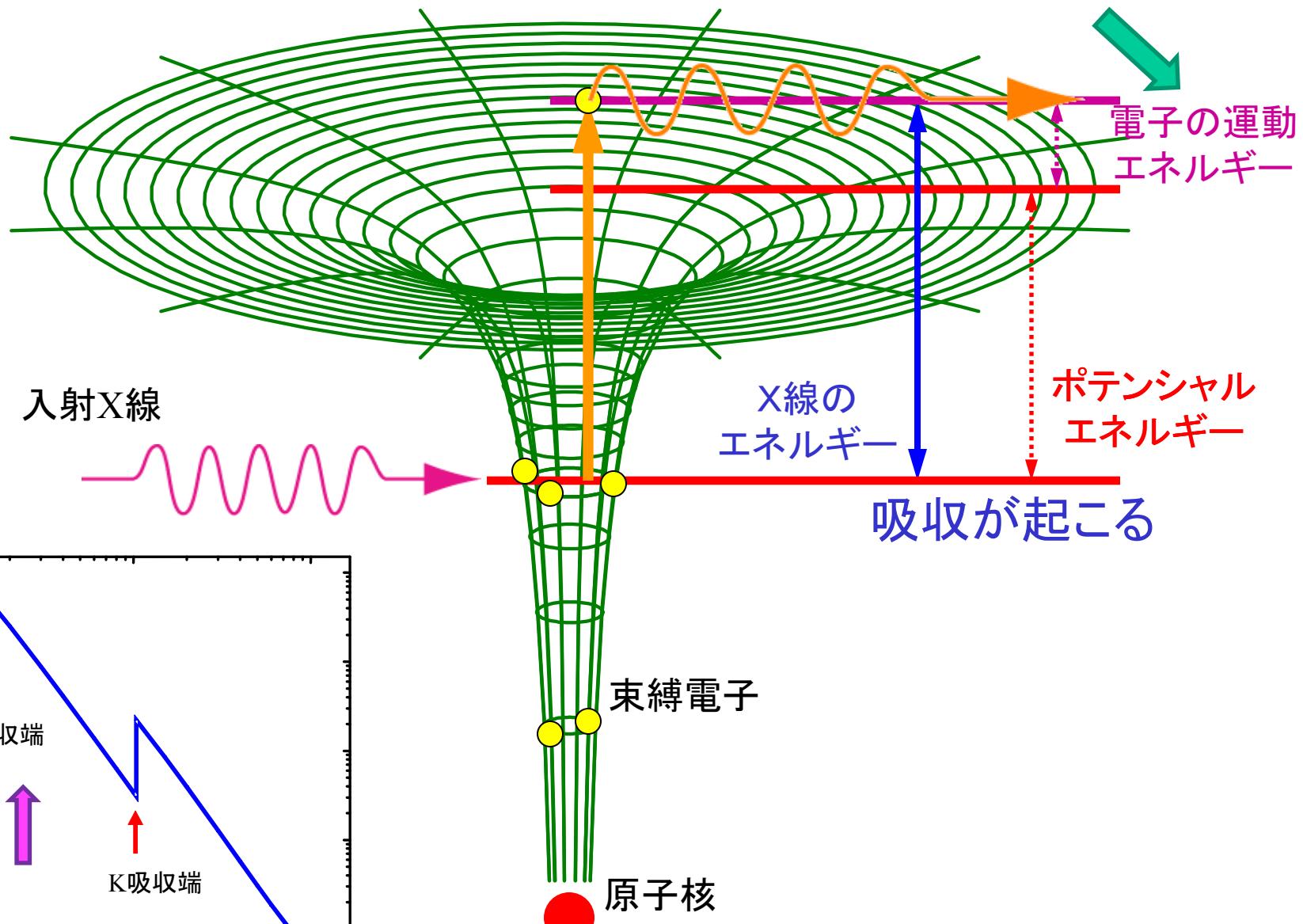
$F.T.\{K^2 X(k)\}$ [a.u.]



動径分布関数

特定原子種の局所構造(配位子の種類、数、距離)がわかる。
→ これはなぜかを納得したい！

これが大事!



電子は波でもある

運動量 $p = \hbar k$: k は波としての電子の波数 ($k = \frac{2\pi}{\lambda}$)

運動エネルギー $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$

入射X線のエネルギー E_X からポテンシャル V を引いた
残り (ΔE) が、運動エネルギーになるので、

$$\Delta E = E_X - V = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \rightarrow k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} \Delta E} \rightarrow \lambda = 2\pi \sqrt{\frac{\hbar^2}{2m \Delta E}}$$

電子は、
エネルギー (ΔE) が大きいほど、波長 (λ) が短い「波」になる。

入射X線のエネルギーが変わると、
電子波の波長が変わる

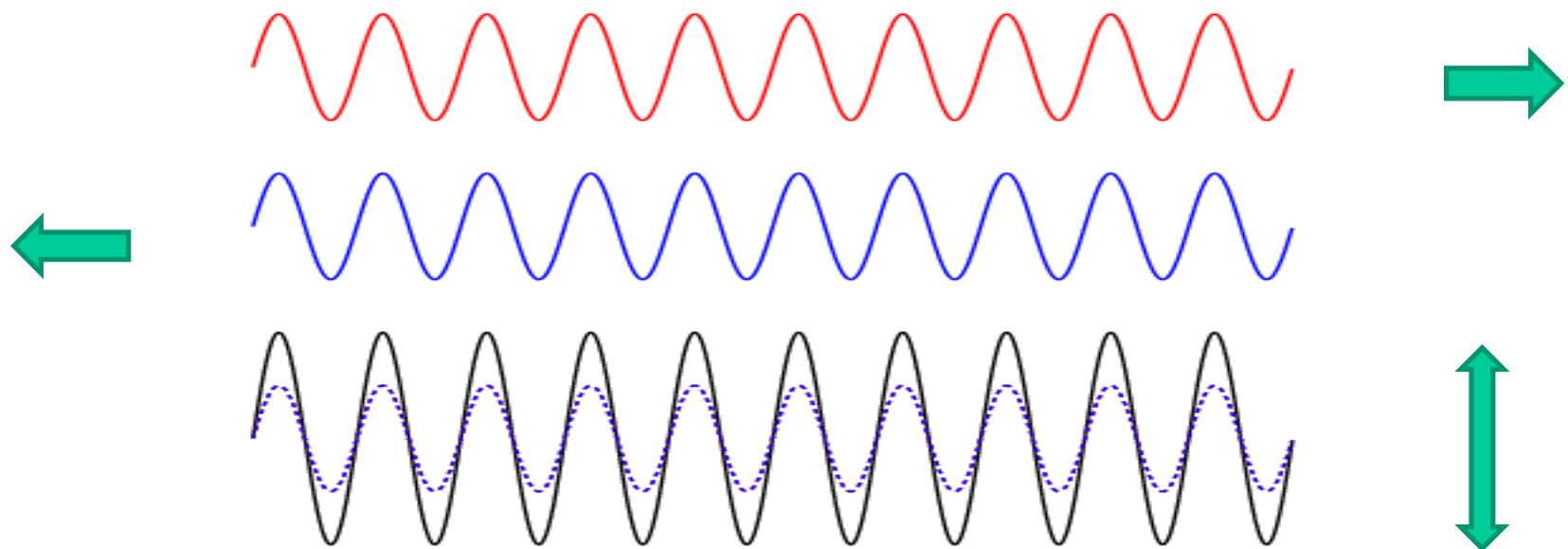
- 電子は波でもある
- 電子波の発生源(原子)を中心に周りに広がる(進行する)
- 周辺の原子によって散乱される

近傍の原子が
電子波を散乱する



X線を吸収した原子
(電子波の発生源)

- 電子は波でもある(エネルギーによって波長が変わる)
- 電子波の発生源(原子)を中心に周りに広がる(進行する)
- 周辺の原子によって散乱される
- 散乱されて、元の原子の場所に戻ってくる波(後退波)は進行波と干渉して、「定在波」を作る



進行波と後退波が干渉すると、動かずして振幅が変動する波になる。

電子波の(終状態の)波の形が変わると何が起こるか？

電子の遷移確率(遷移頻度)

エネルギー保存

$$|\langle \psi_f | V | \psi_i \rangle|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega)$$

変化する

遷移後の状態
(終状態)

遷移前の状態
(始状態)

フェルミの黄金律

これは変化しない

遷移の原因になる外乱 $V : A \cdot p$ X線が原因の電子遷移
= X線吸収

始状態：電子 E_i + 光子 $\hbar\omega$



終状態：電子 E_f

電子波の(終状態の)波の形が変わると何が起こるか？

電子の遷移確率(遷移頻度)

エネルギー保存

$$|\langle \psi_f | V | \psi_i \rangle|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega)$$

変化する

遷移後の状態
(終状態)

遷移前の状態
(始状態)

フェルミの黄金律

これは変化しない

遷移の原因になる外乱 $V : A \cdot p$ X線が原因の電子遷移
= X線吸収

$$V : A \cdot p \propto \hat{e} \cdot r$$

例えば $\hat{e} = (1, 0, 0)$ なら

光の偏光方向の単位ベクトル。

$$V : A \cdot p \propto \hat{e} \cdot r = x$$

双極子近似による吸収係数

$$\mu \propto \sum_f |\langle \psi_f | \hat{e} \cdot \mathbf{r} | \psi_i \rangle|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega)$$

$$\langle \psi_f | x | \psi_i \rangle = \int \psi_f^* x \psi_i dx$$

↓
「終」状態の波動関数 「始」状態の波動関数

「始」状態が原子に束縛された状態なら、

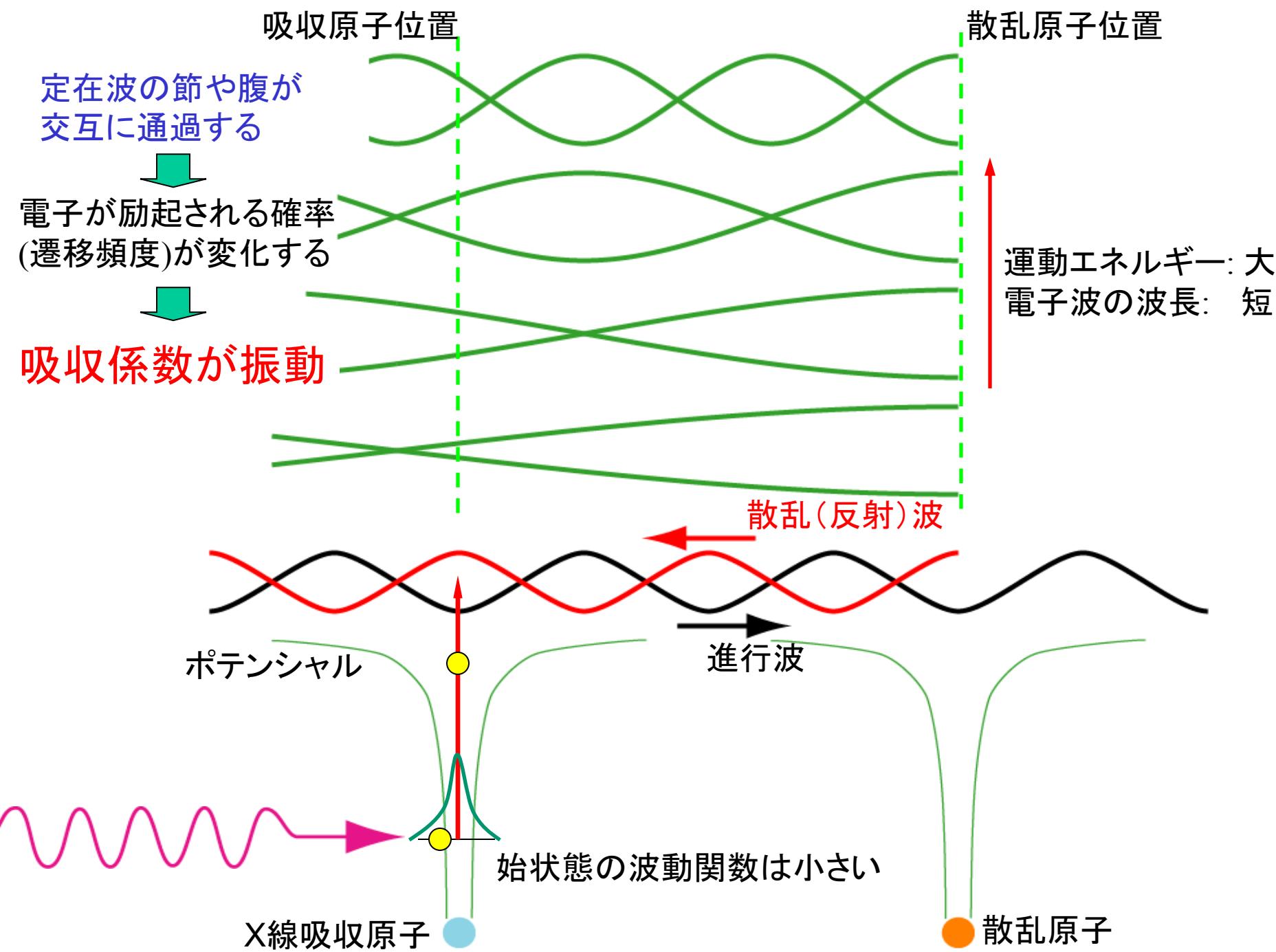
1) その波動関数は小さな範囲でだけ値を持つので、

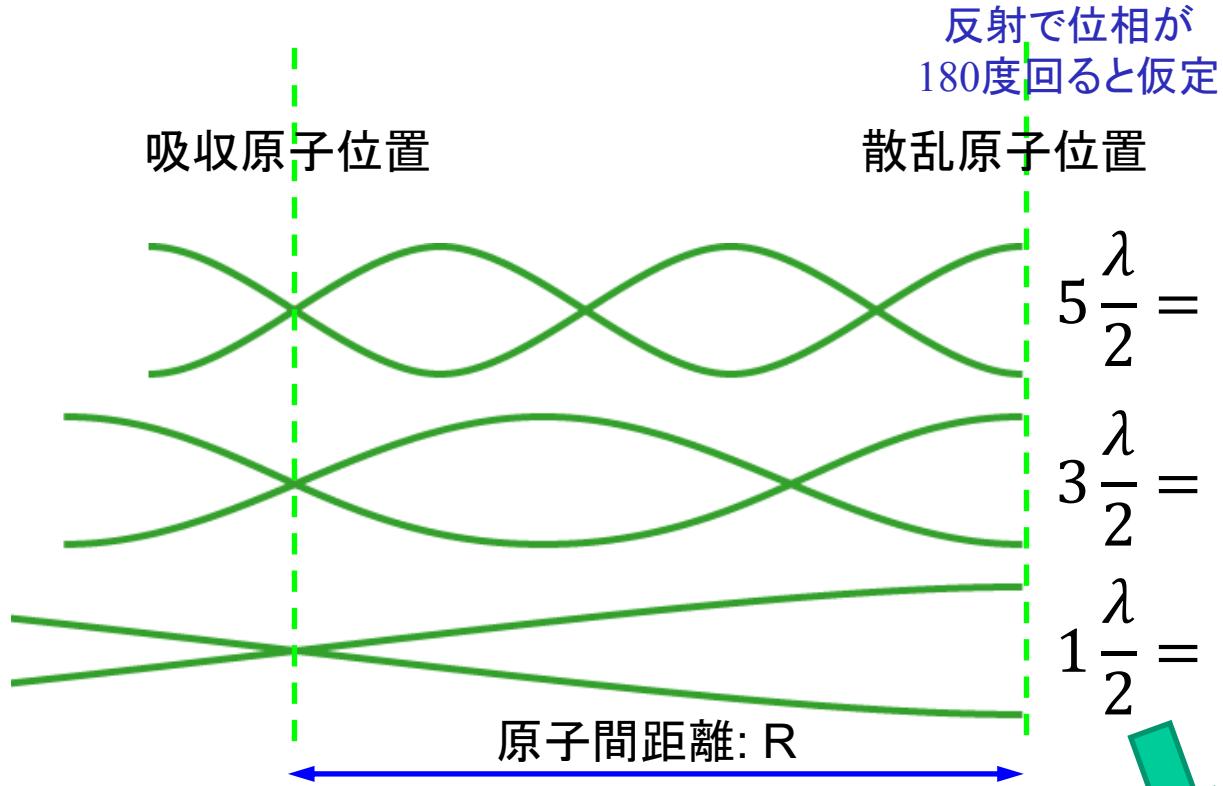
終状態の波動関数の吸収原子の位置での大きさが重要

「始」状態が S 軌道、外乱部分が x (直線偏向の光) なら、

2) 「終」状態の平面波は x 方向に進行する。

3) 「終」状態が、x 方向の奇関数の時、吸収が大きくなる
偶関数の時、小さくなる。





全て $\Delta k = \frac{\pi}{R}$

$$5 \frac{\lambda}{2} = 2R$$

$$3 \frac{\lambda}{2} = 2R$$

$$1 \frac{\lambda}{2} = 2R$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} = k = 1 \frac{2\pi}{4R}$$

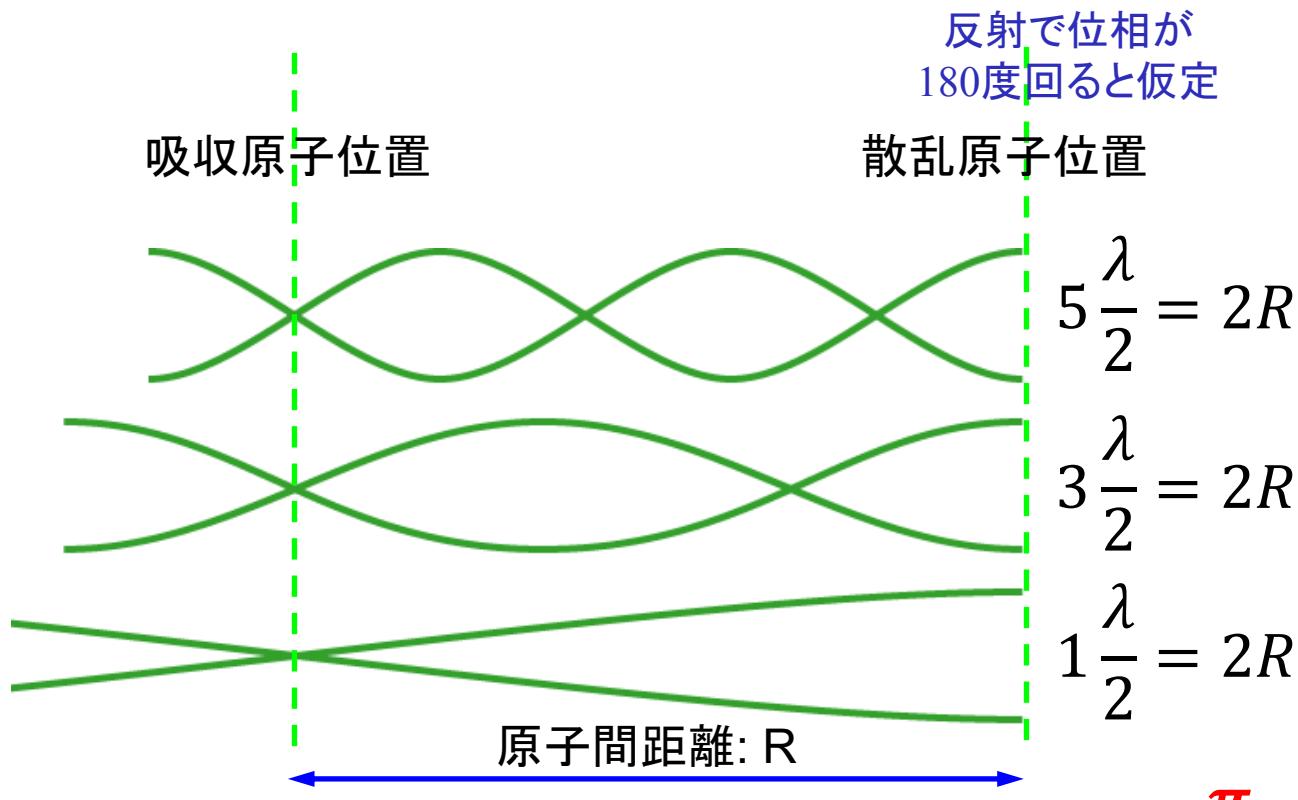
$$\lambda = \frac{4}{5}R$$

$$\lambda = \frac{4}{3}R$$

$$\lambda = \frac{4}{1}R$$

$$k = 5 \frac{2\pi}{4R}$$

$$k = 3 \frac{2\pi}{4R}$$

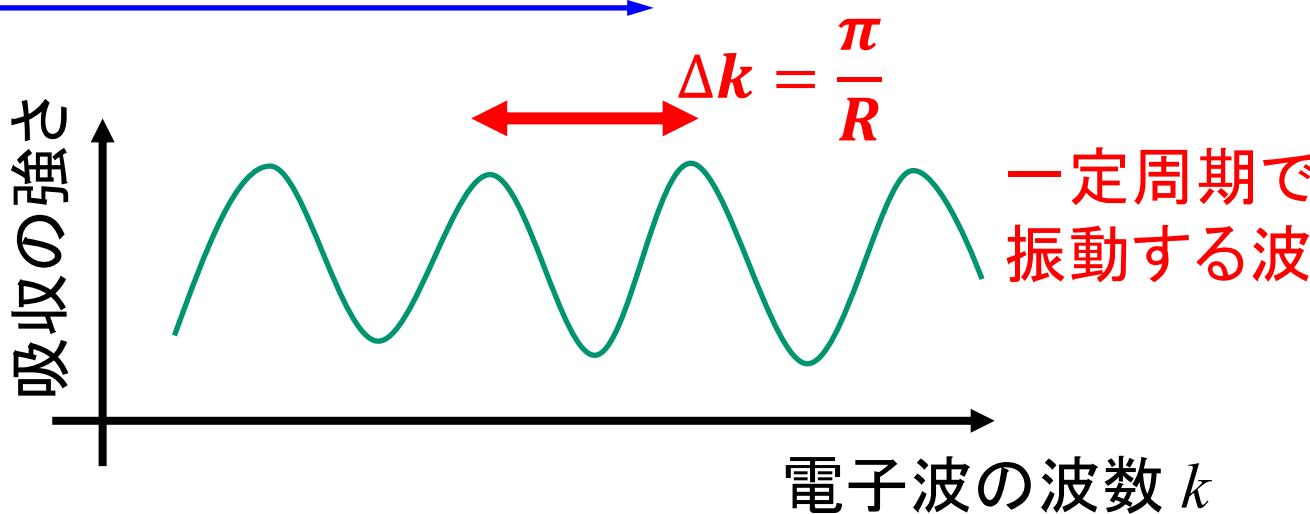


全て $\Delta k = \frac{\pi}{R}$

$$k = 5 \frac{\pi}{2R}$$

$$k = 3 \frac{\pi}{2R}$$

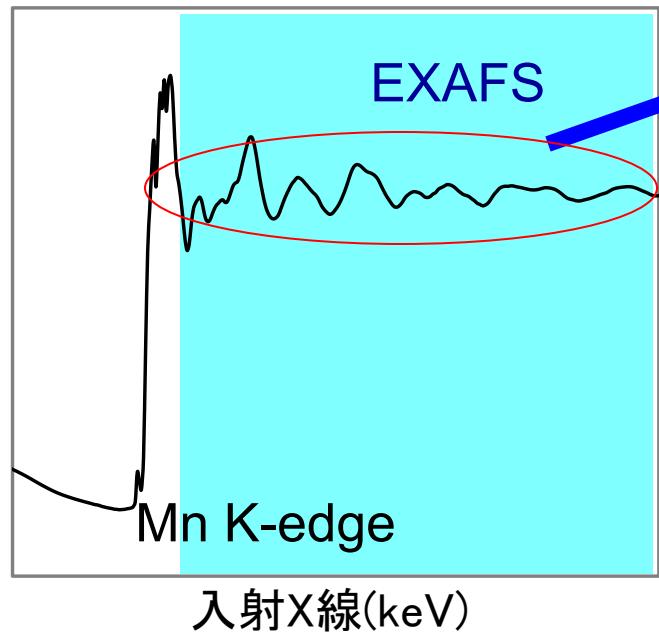
$$\frac{2\pi}{\lambda} = k = 1 \frac{\pi}{2R}$$



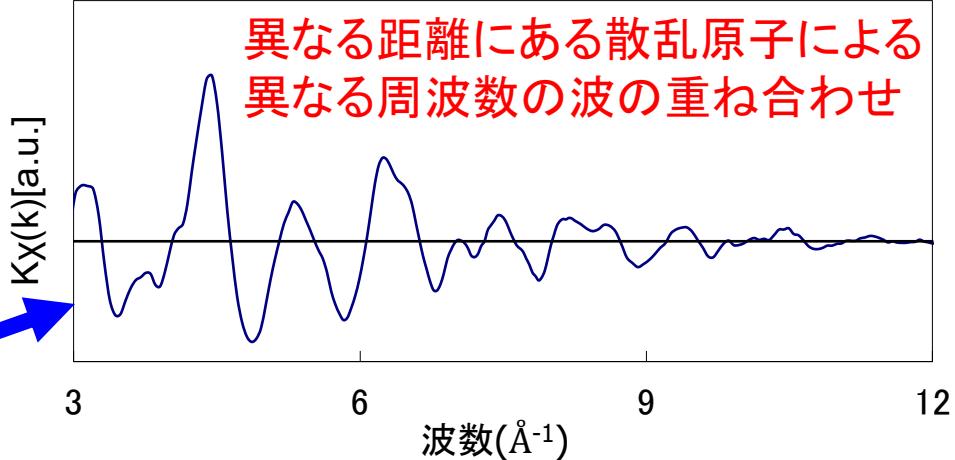
EXAFS(Extended X-ray Absorption Fine Structure)

ZnGa₂O₄:Mn

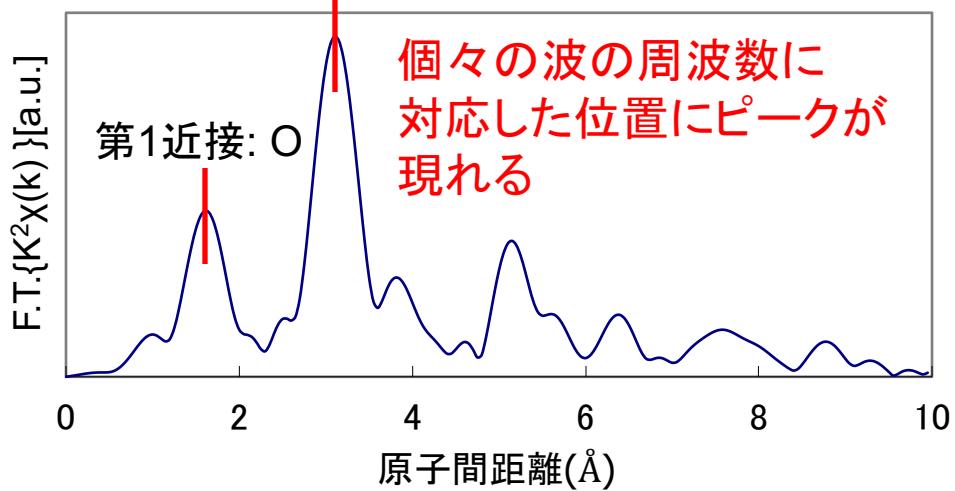
蛍光X線強度



波長～1/R 周波数～R

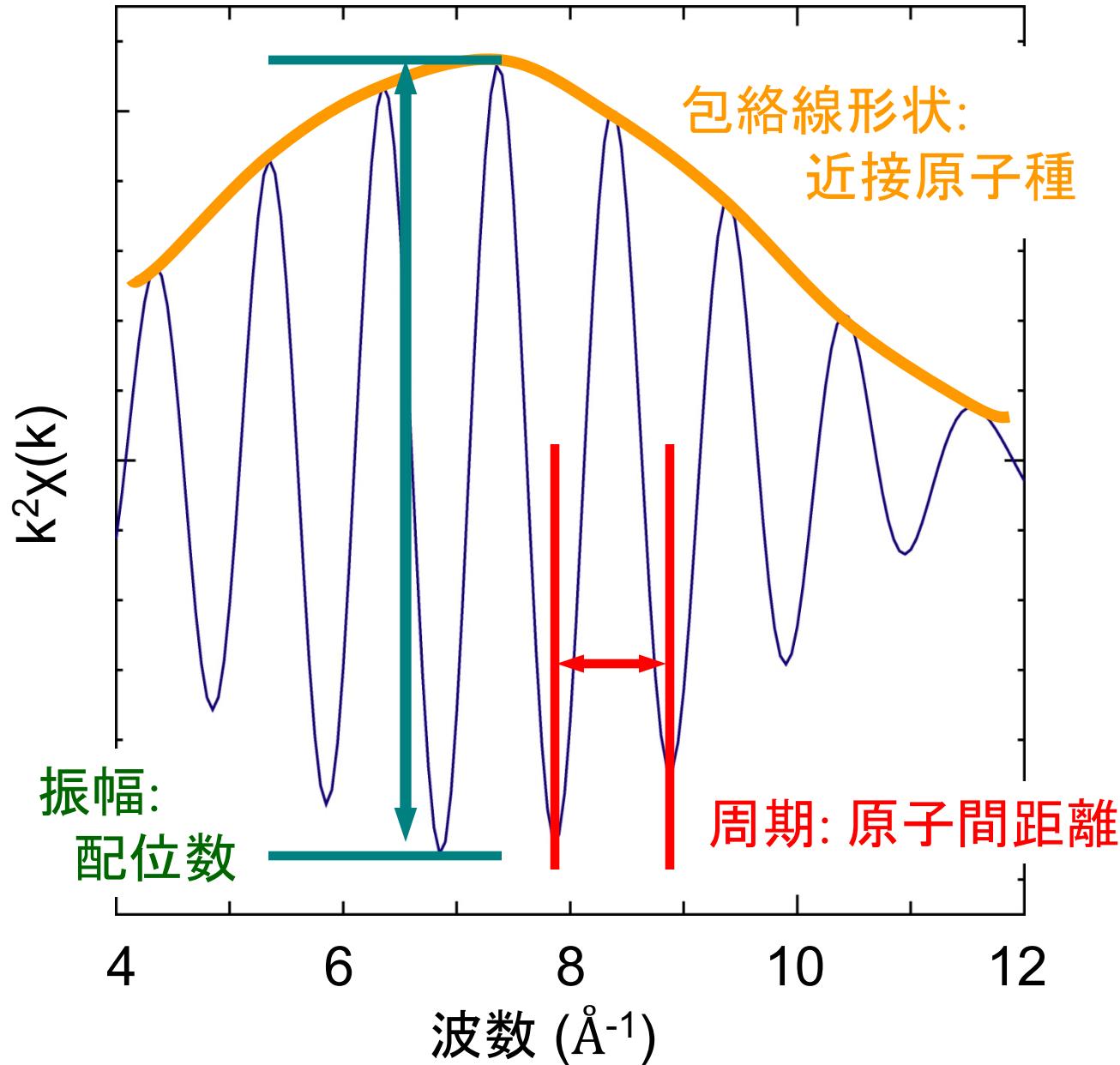


フーリエ変換

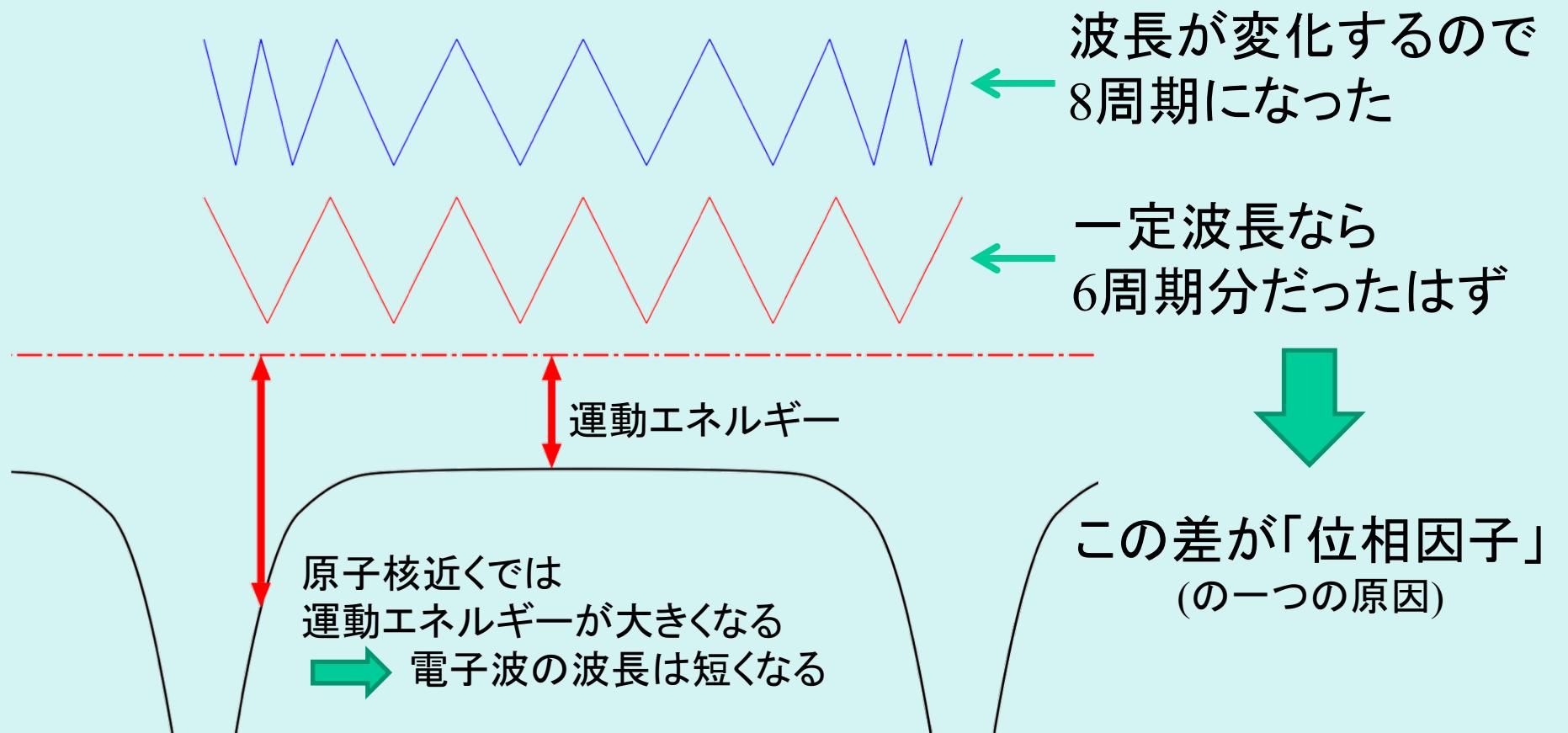


特定原子種の局所構造(配位子の種類、数、距離)がわかる。

EXAFSスペクトルに含まれる情報

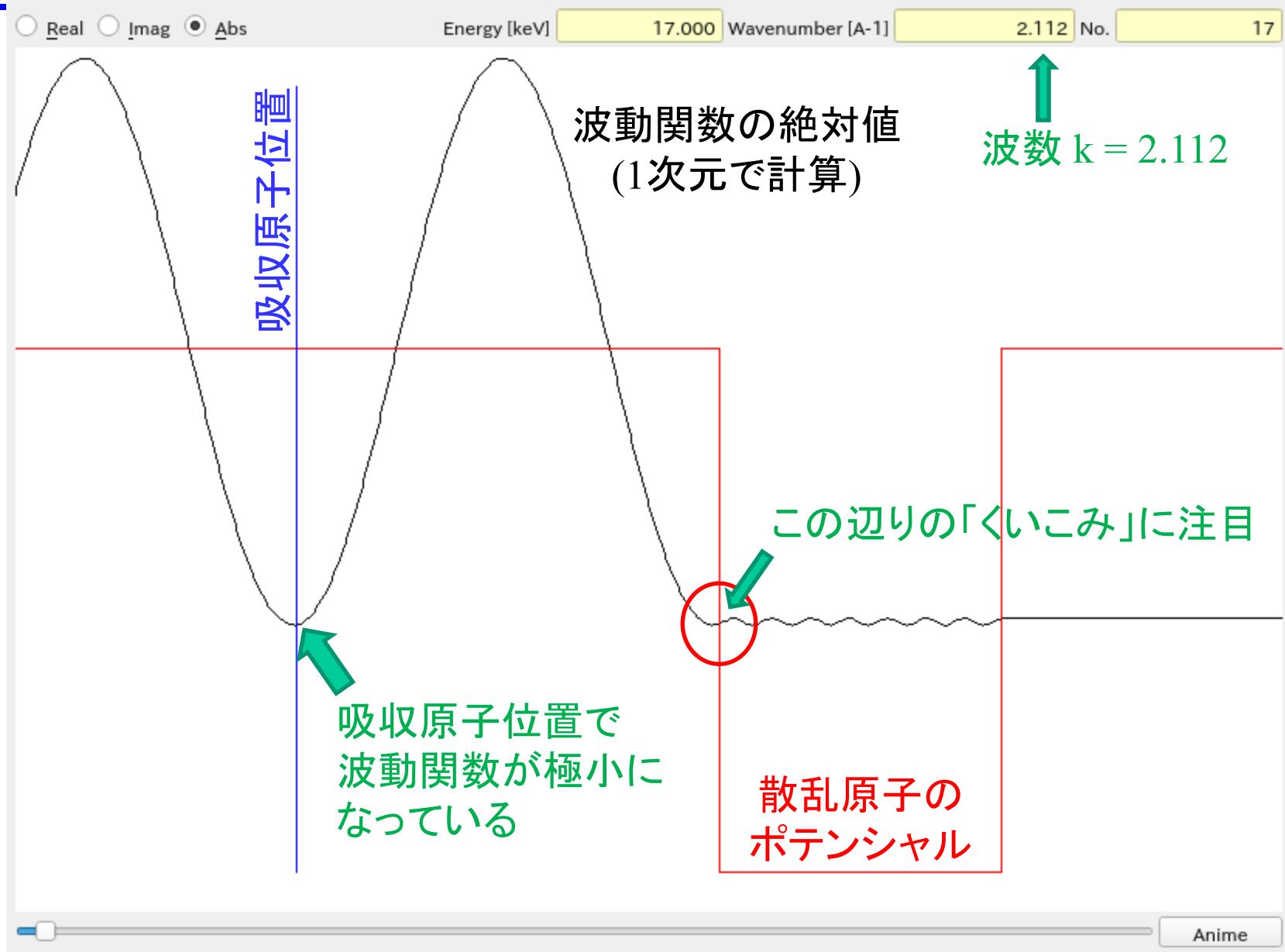


位相因子？

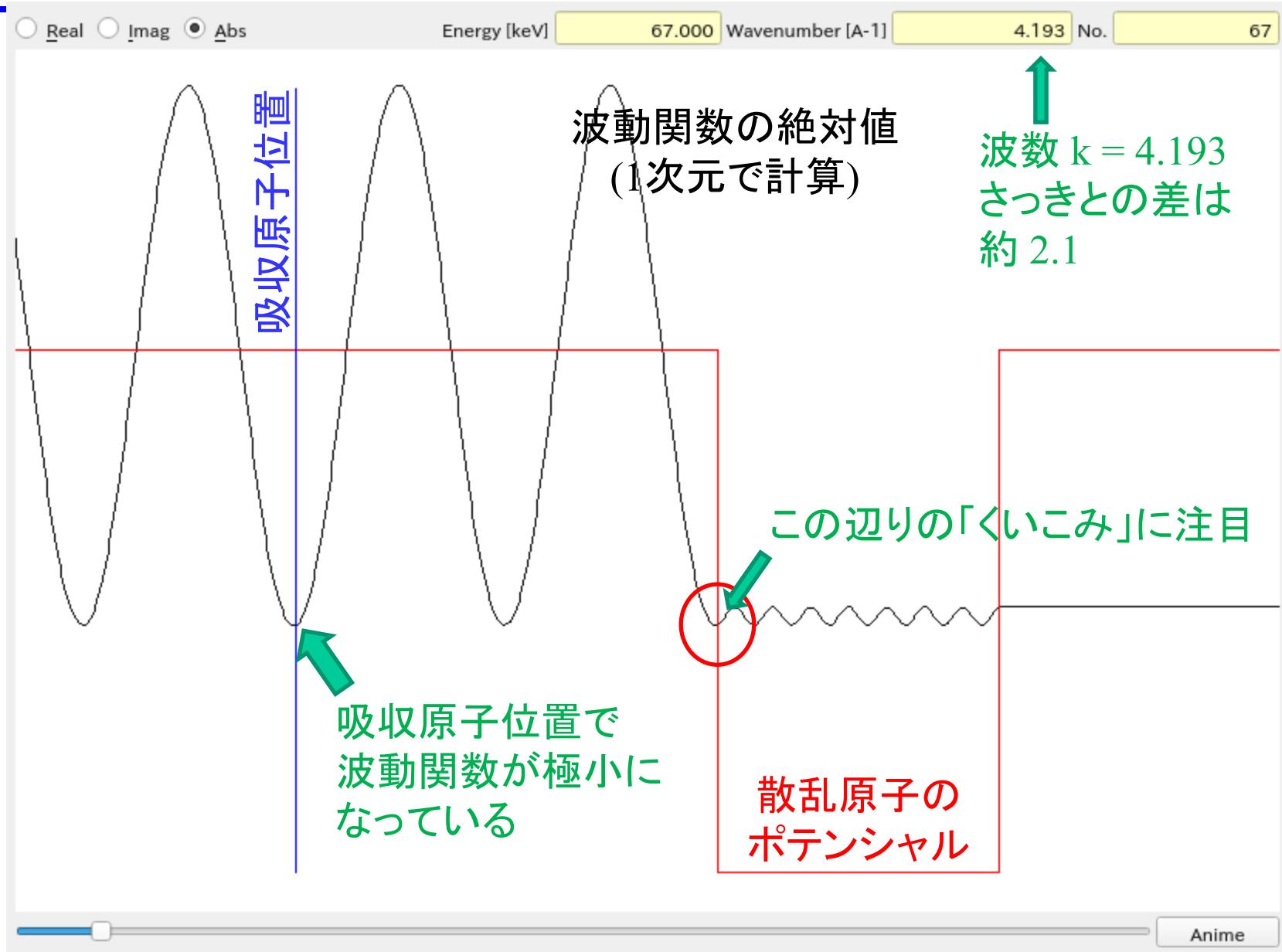


重要!! **中心原子と散乱原子で決まる。**
(原子間距離や配置に依存しない)
反射することそのものによる位相変化もある。
これも原子が決まると決まる。

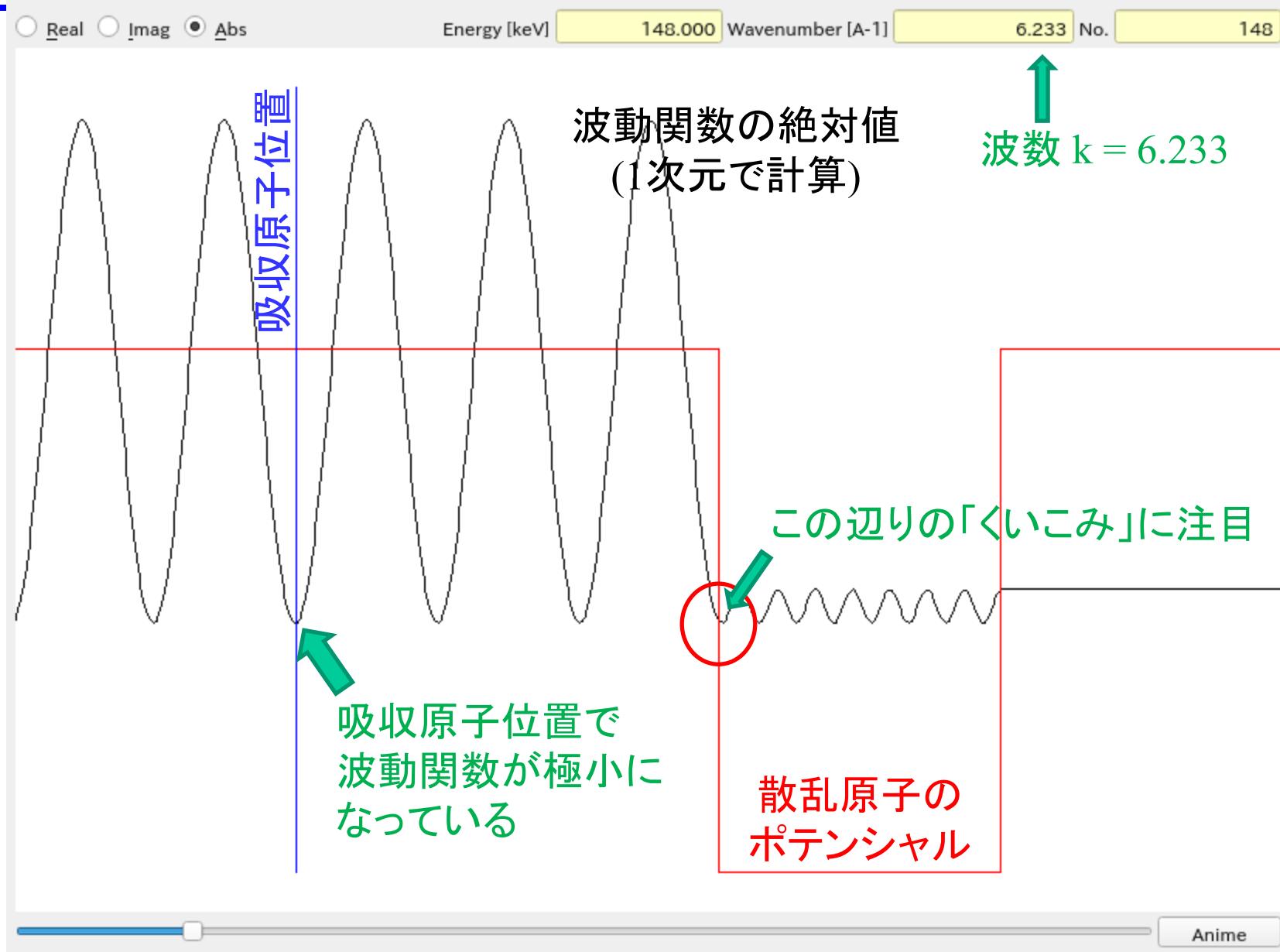
位相因子？



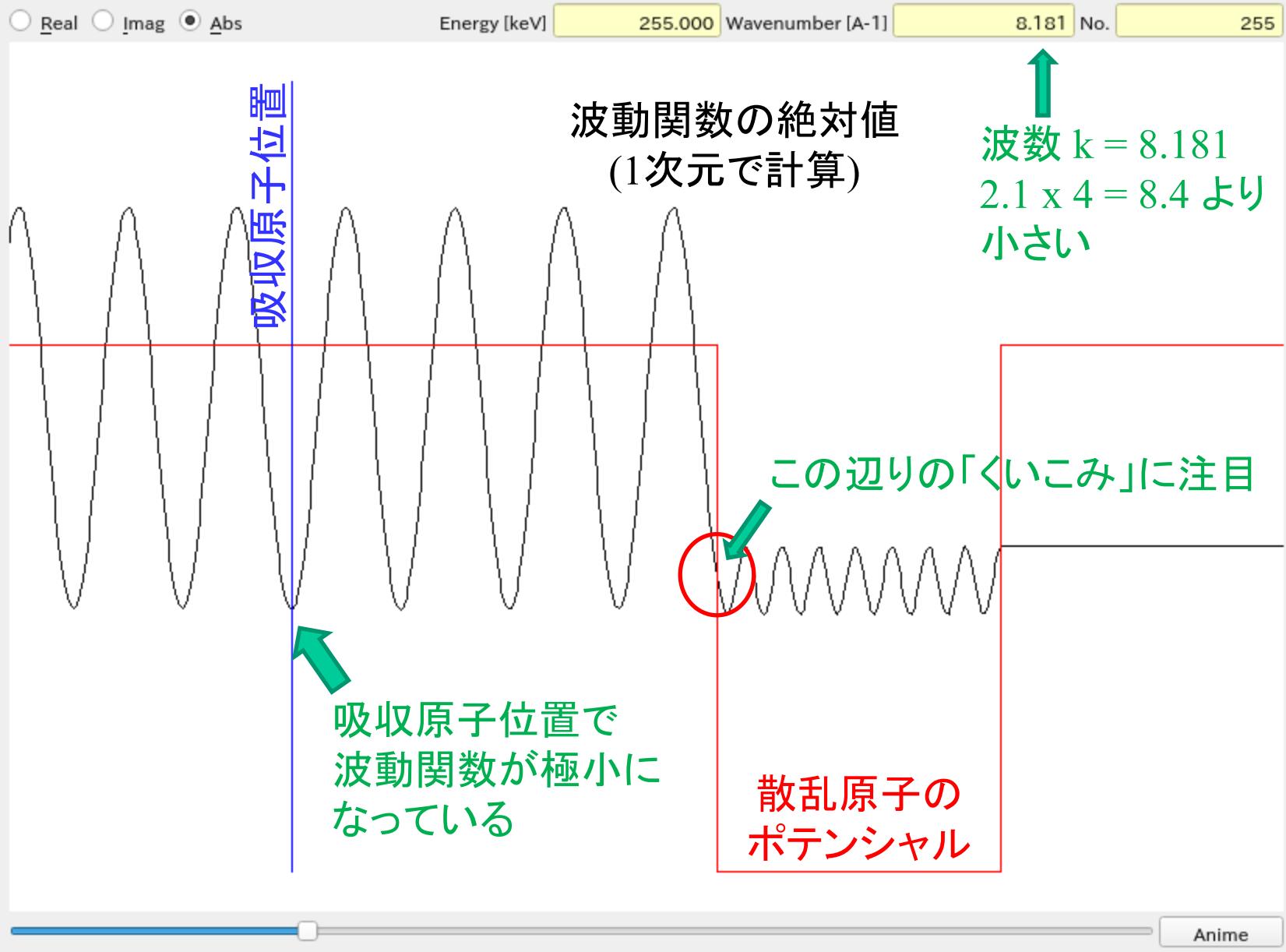
位相因子？



位相因子？

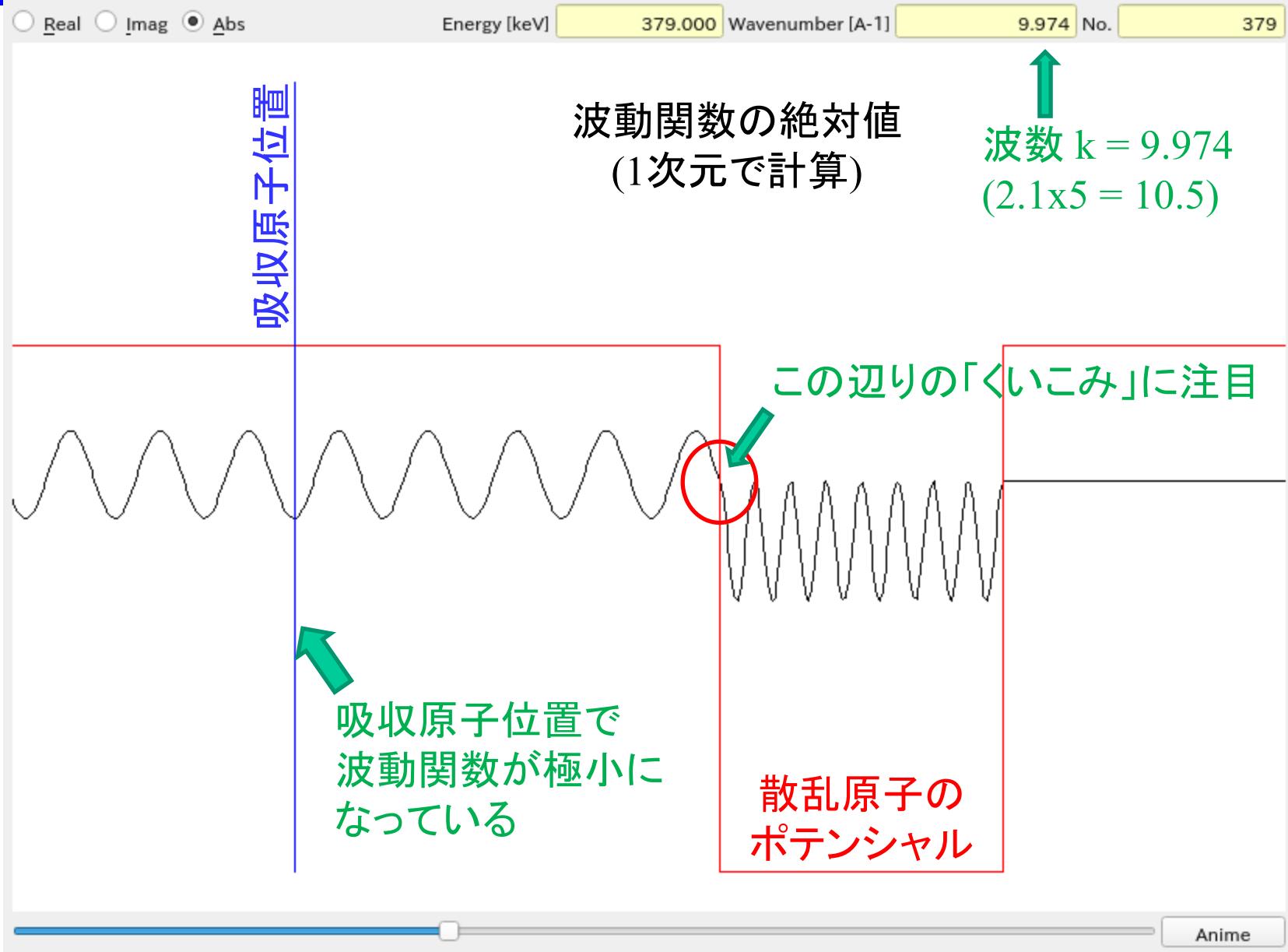


位相因子？



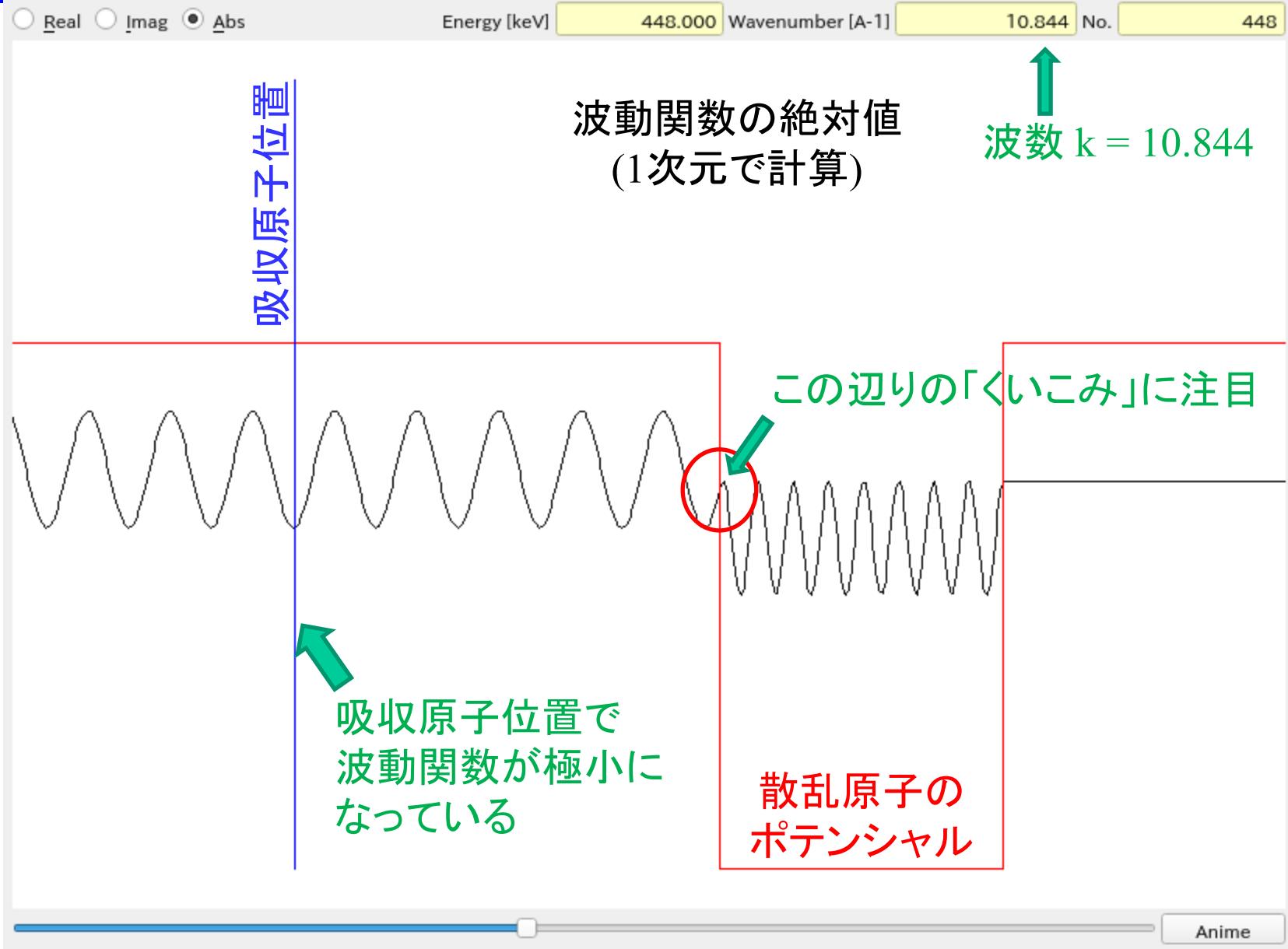
Anime

位相因子？

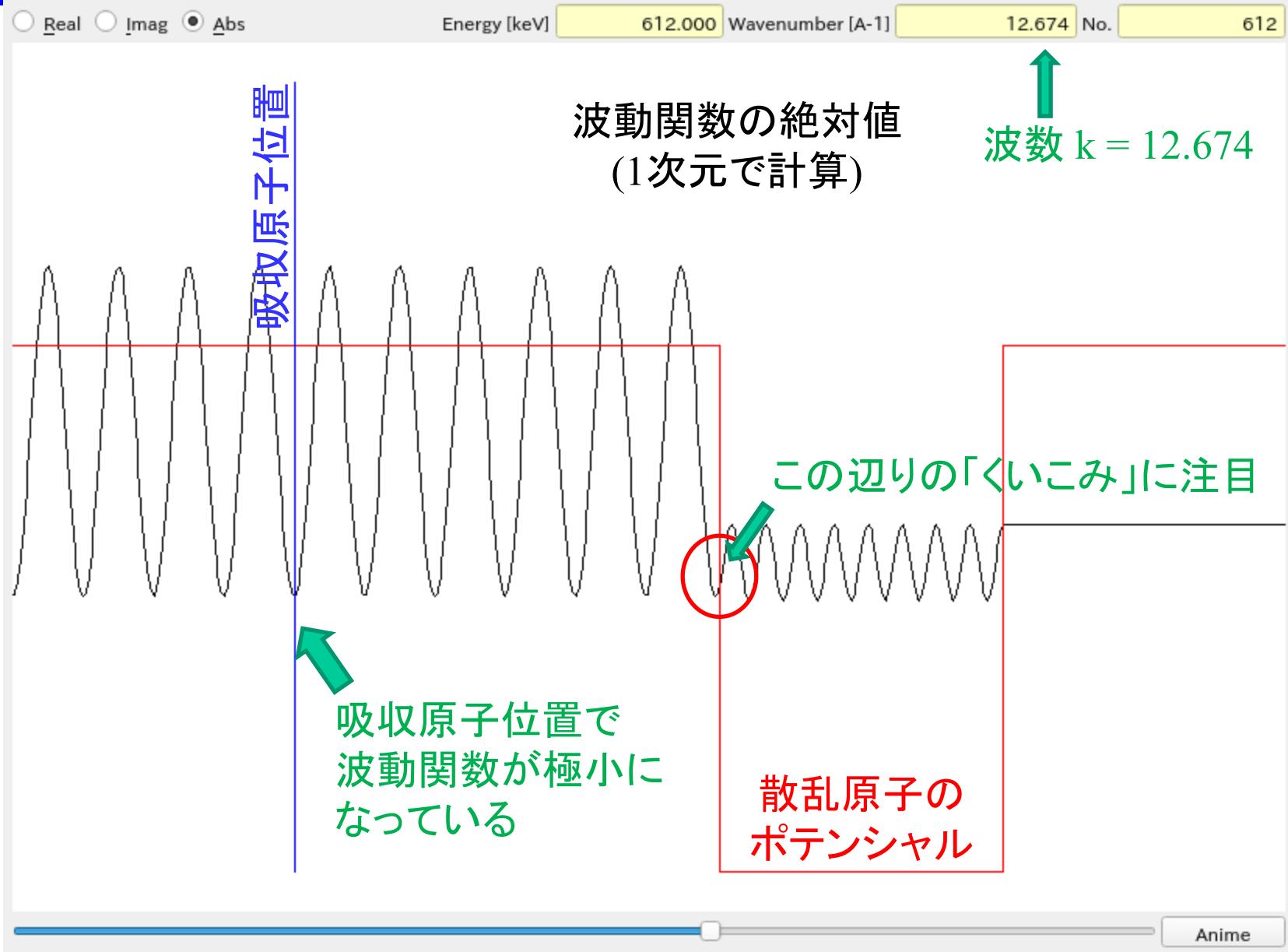


Anime

位相因子？

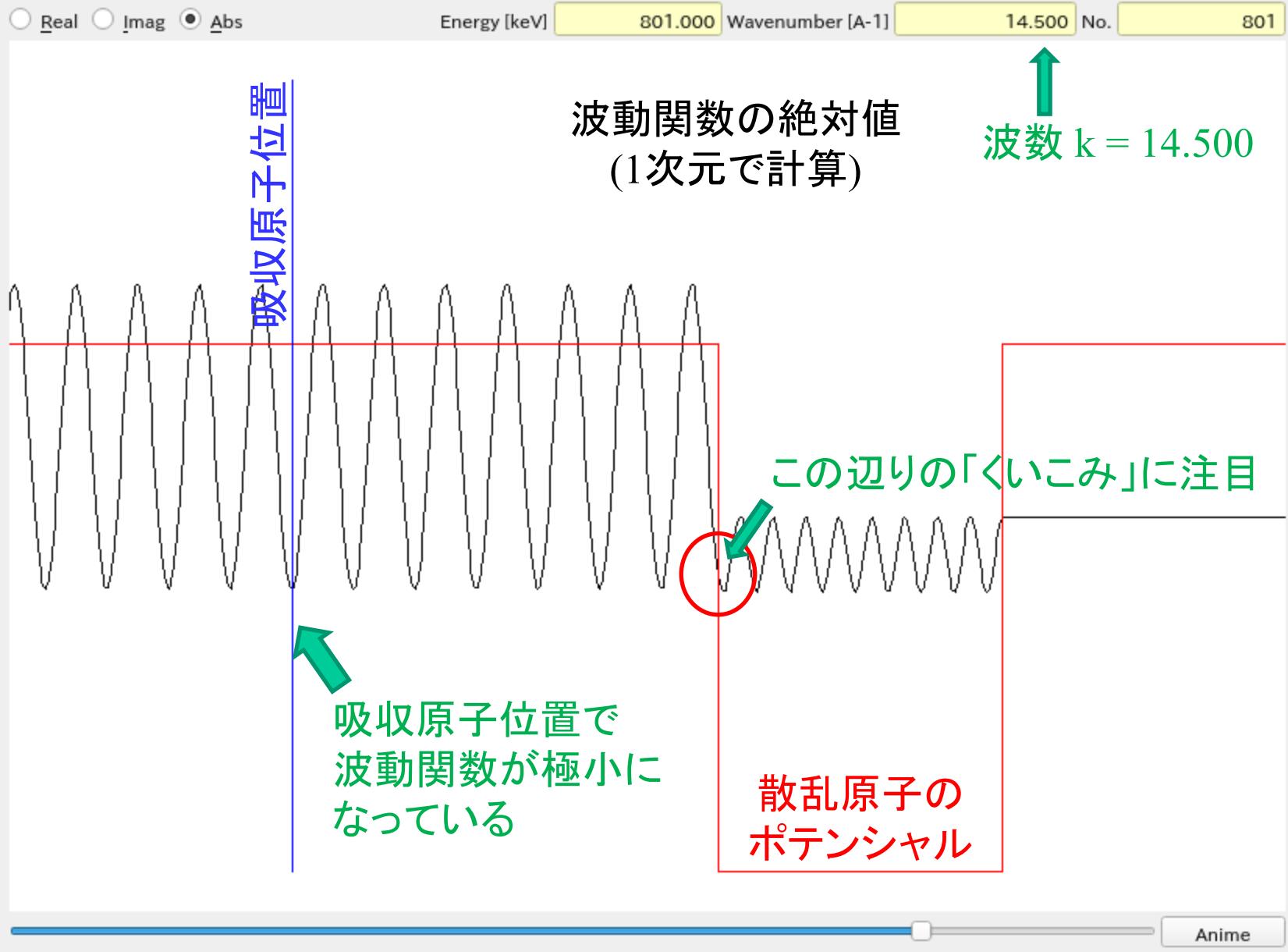


位相因子？

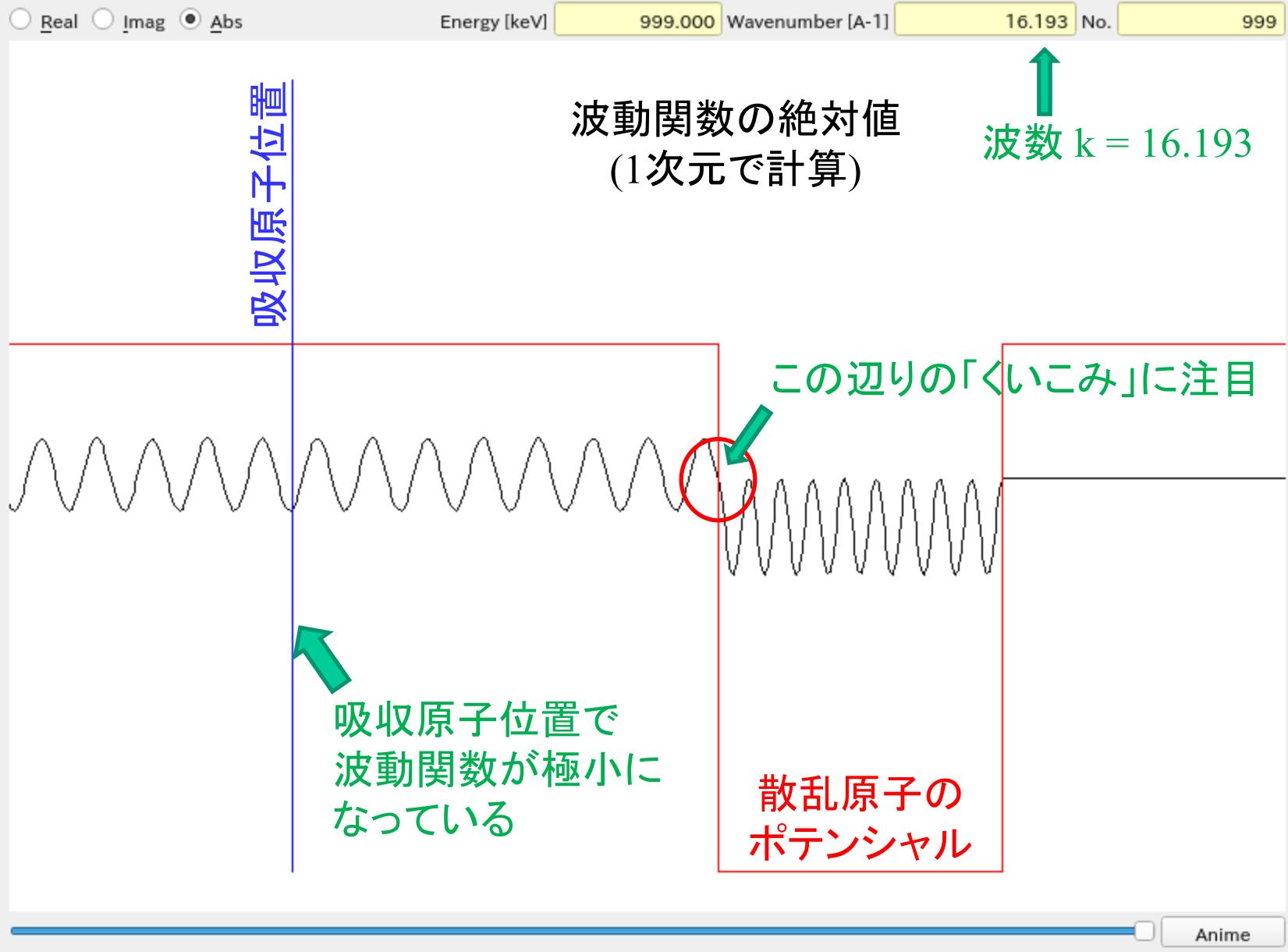


Anime

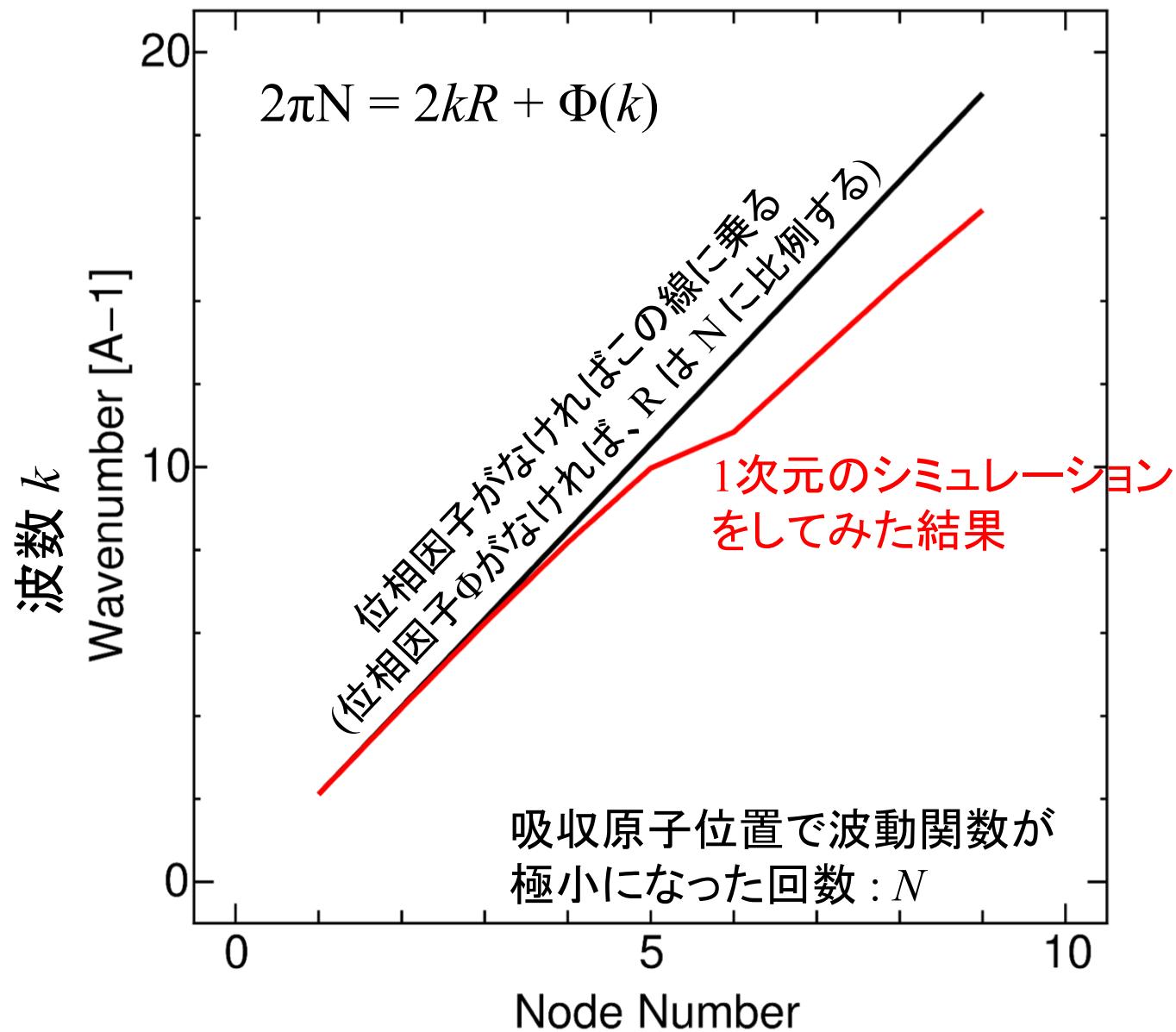
位相因子？



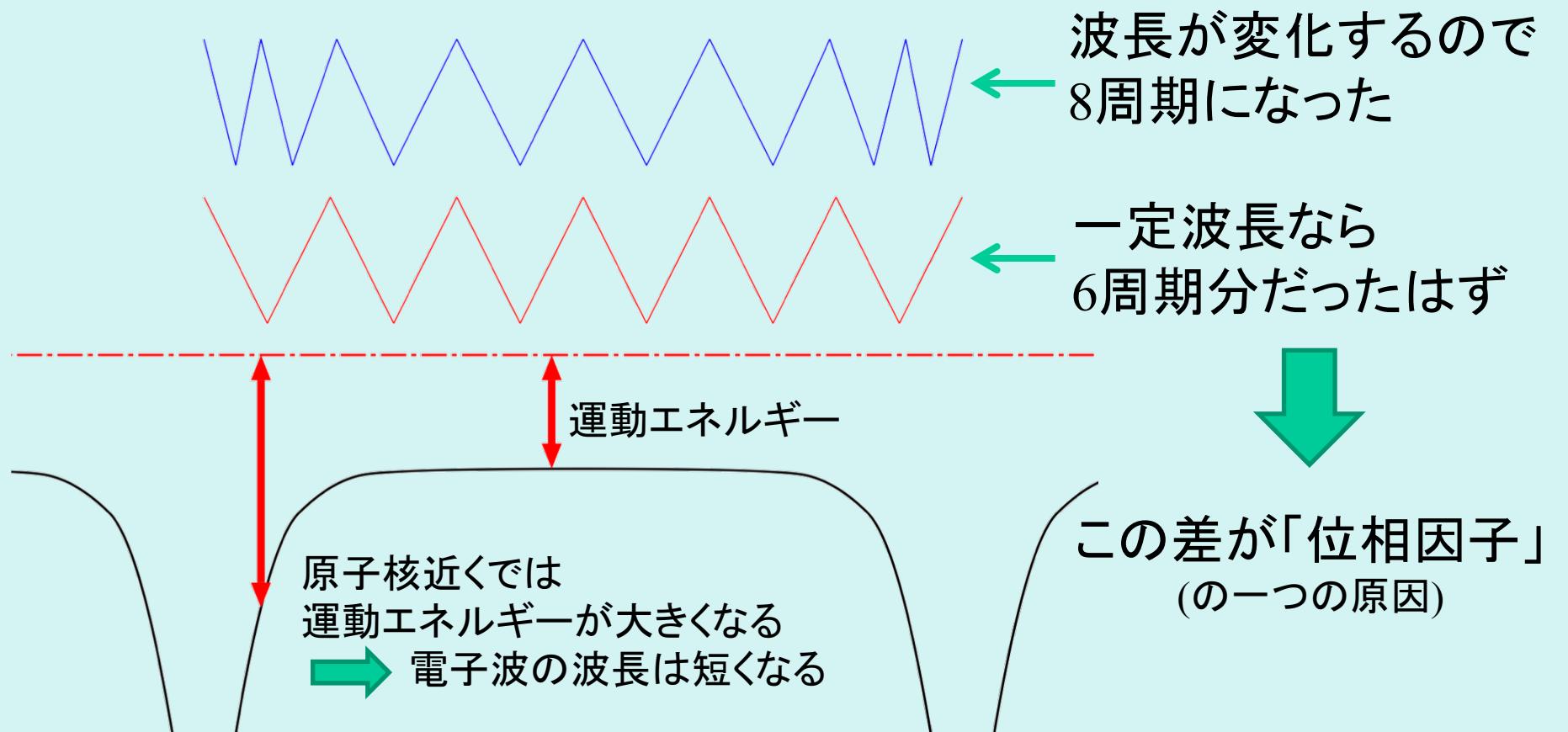
位相因子？



位相因子？



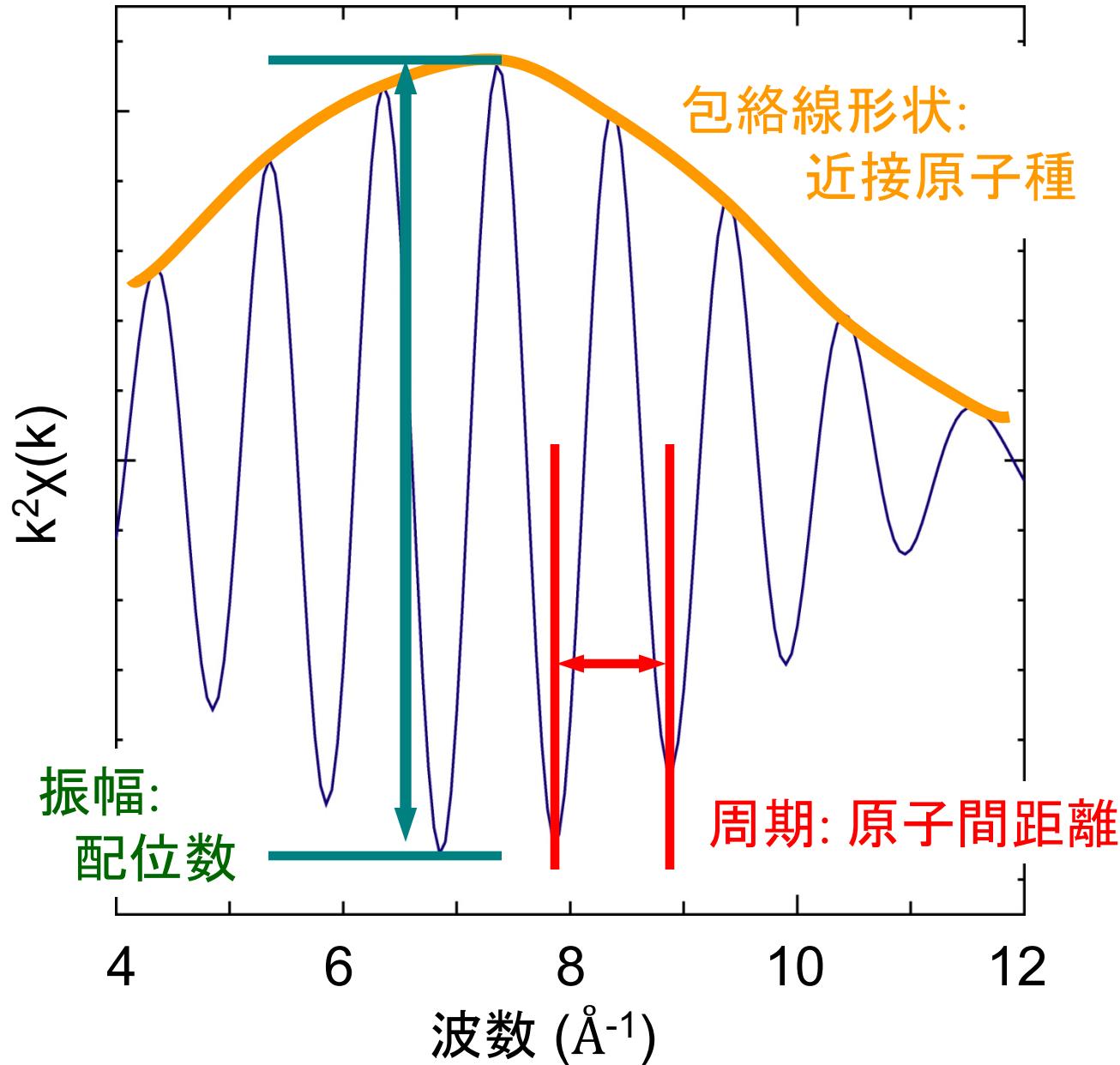
位相因子？



重要!! **中心原子と散乱原子で決まる。**
(原子間距離や配置に依存しない)

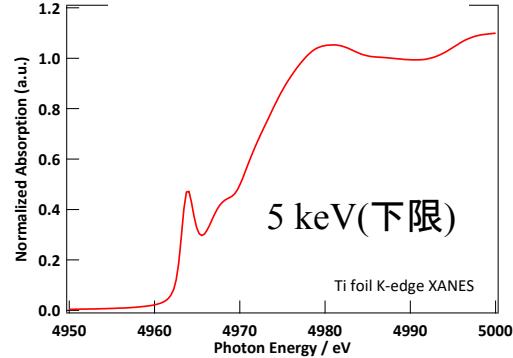
反射することそのものによる位相変化もある。
これも原子が決まると決まる。

EXAFSスペクトルに含まれる情報

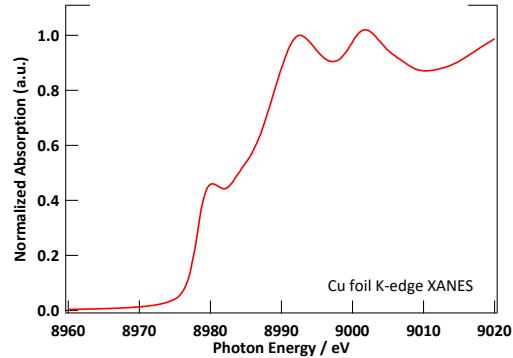


典型的な金属箔のスペクトル

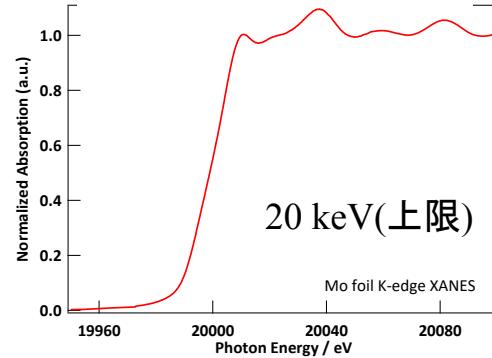
Ti K-edge XAFS



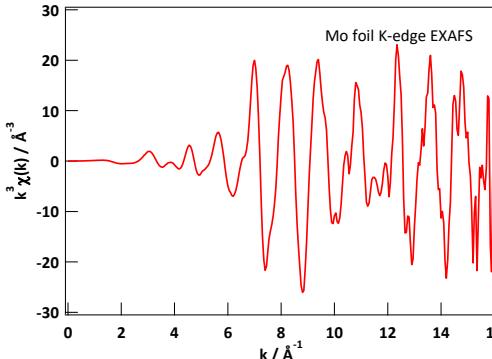
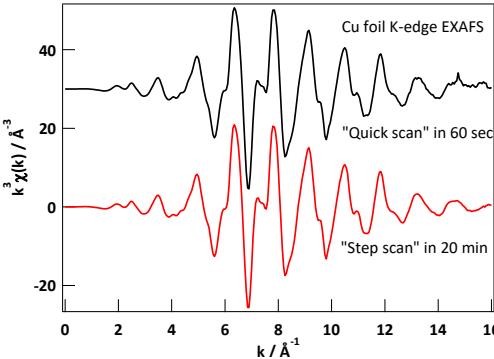
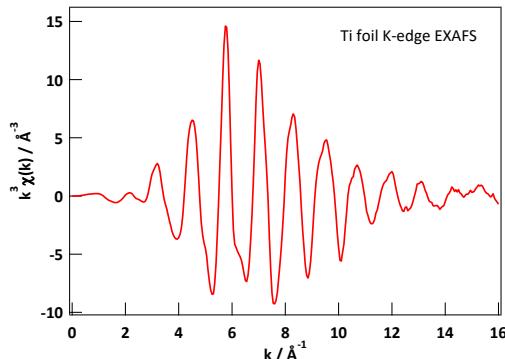
Cu K-edge XAFS



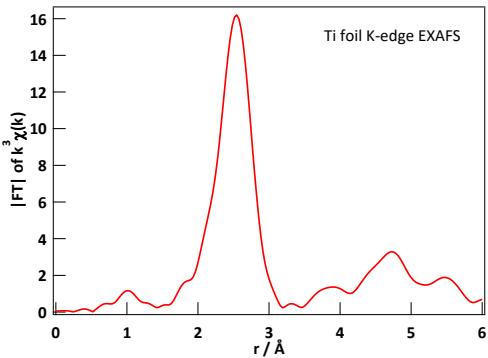
Mo K-edge XAFS



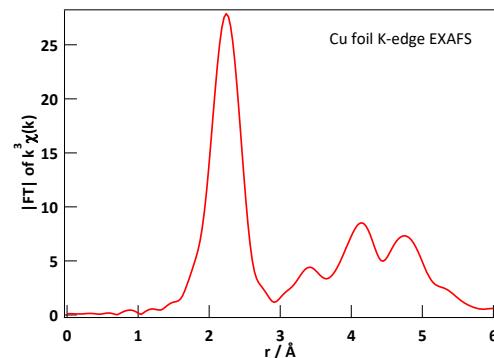
Ti foil K-edge EXAFS



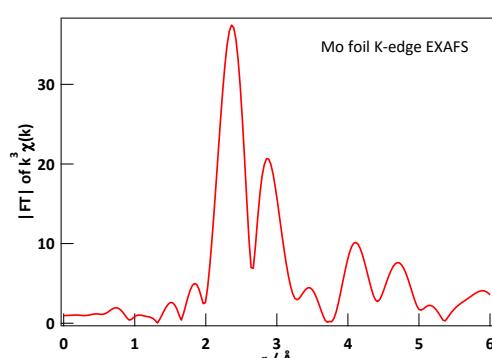
Ti foil K-edge EXAFS



Cu foil K-edge EXAFS



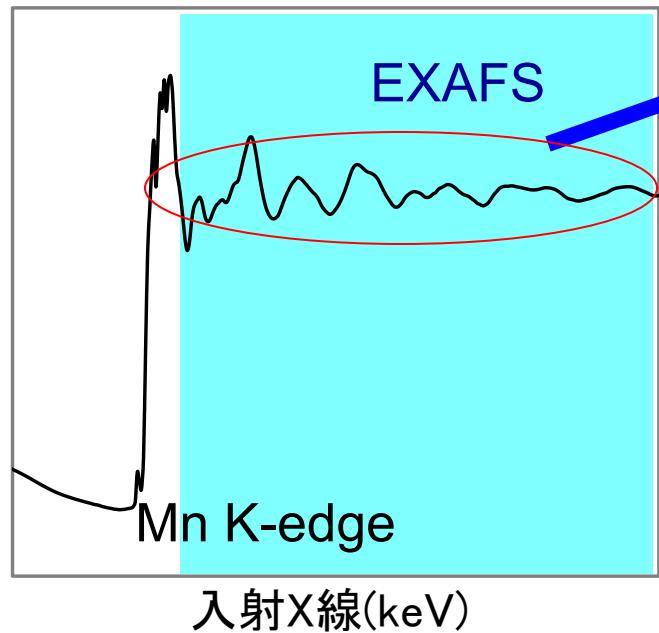
Mo foil K-edge EXAFS



EXAFS(Extended X-ray Absorption Fine Structure)

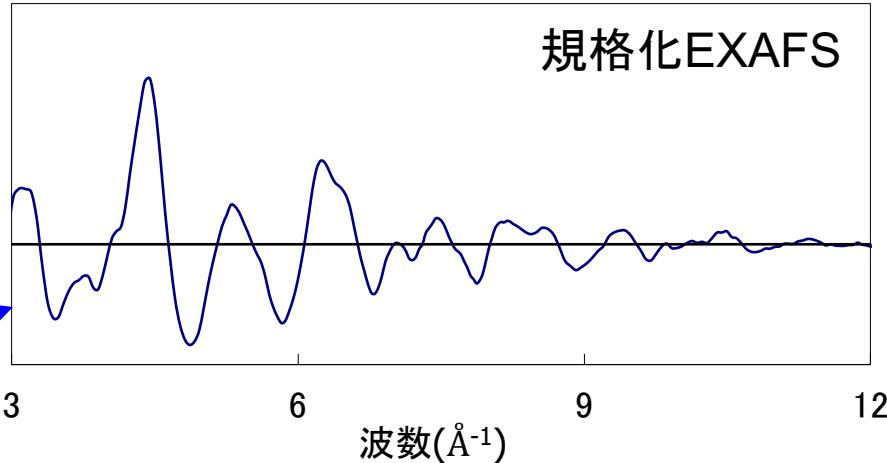
ZnGa₂O₄:Mn

蛍光X線強度



EXAFS

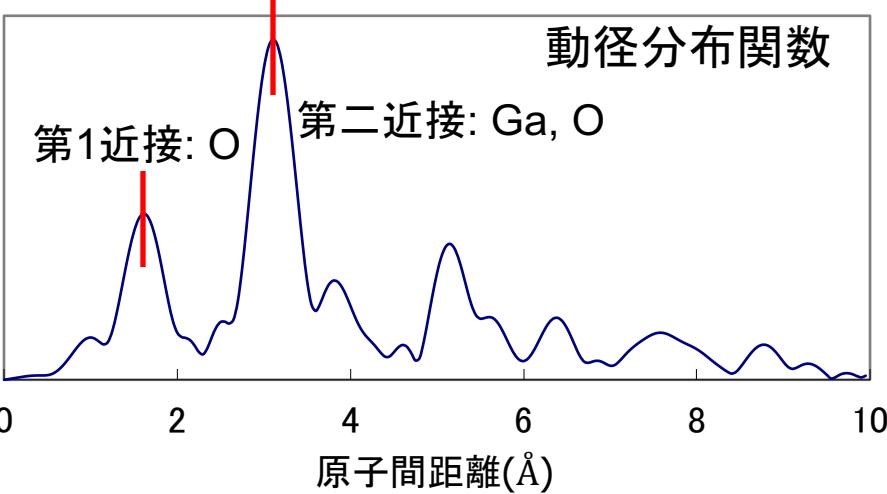
$K_X(k)$ [a.u.]



規格化EXAFS

フーリエ変換

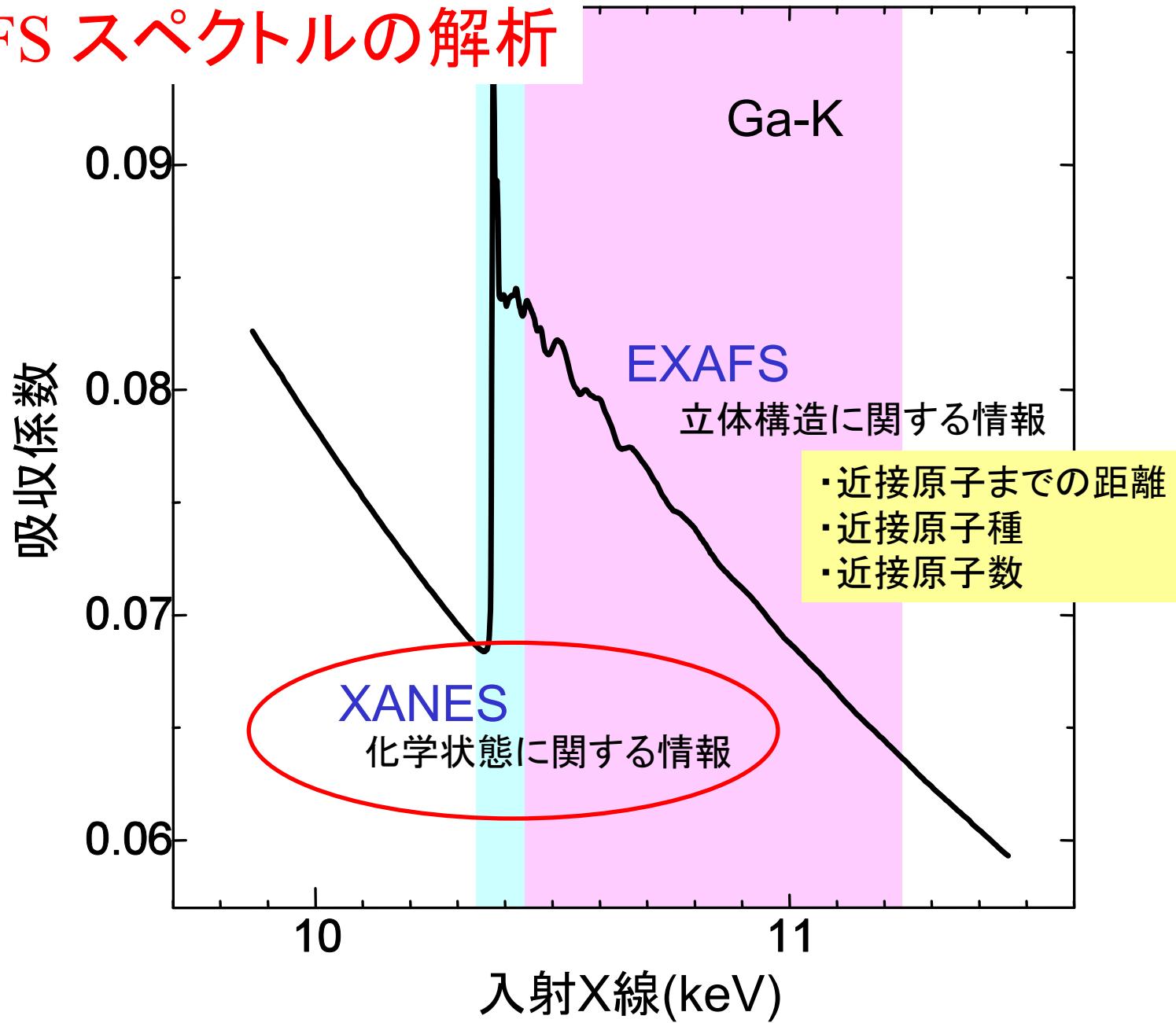
$F.T.\{K^2 X(k)\}$ [a.u.]



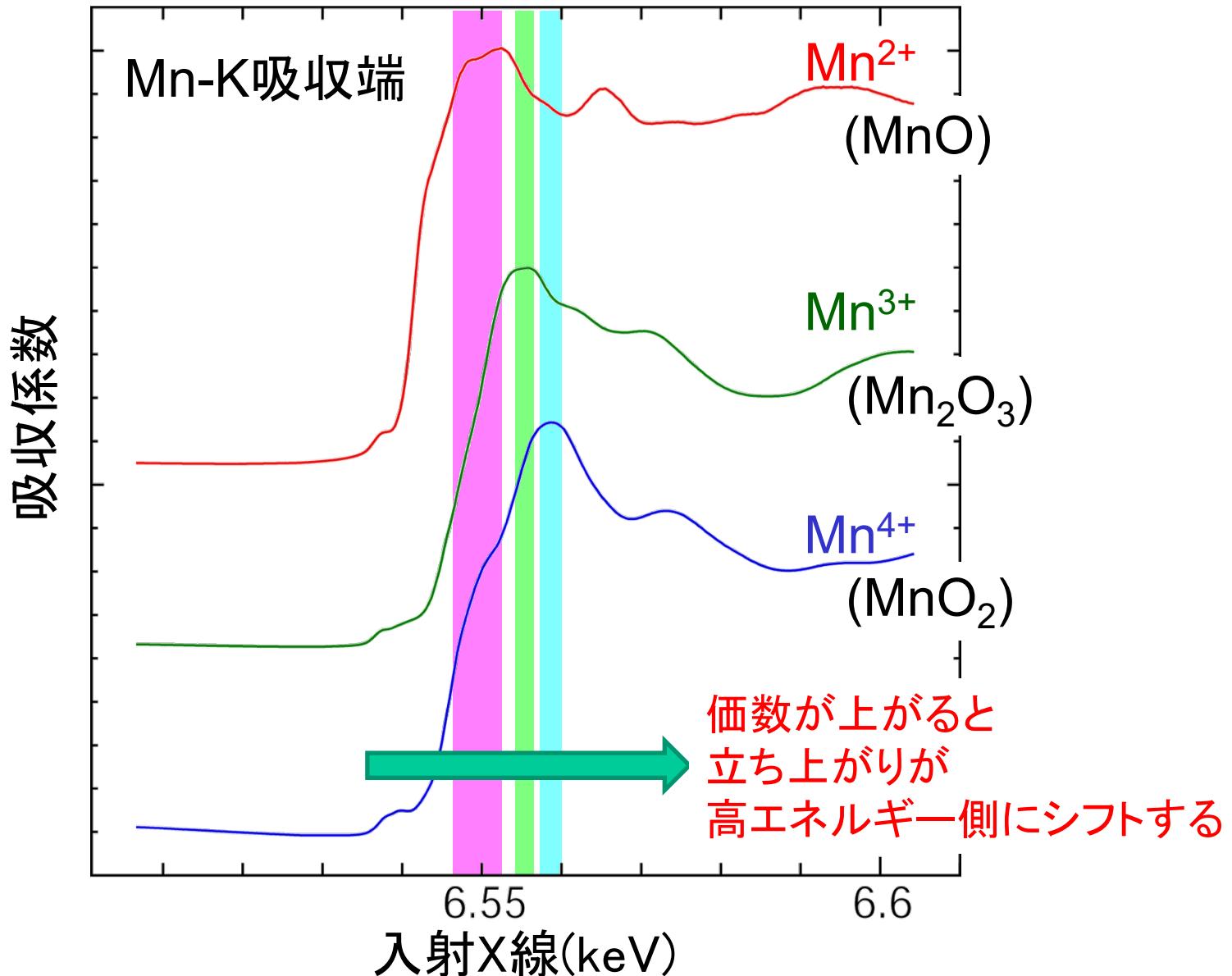
動径分布関数

特定原子種の局所構造(配位子の種類、数、距離)がわかる。

XAFS スペクトルの解析



XANES に見られる変化 (1) : 値数



Study of the Jahn–Teller Distortion in LiNiO_2 , a Cathode Material in a Rechargeable Lithium Battery, by *in Situ* X-Ray Absorption Fine Structure Analysis

Izumi Nakai,¹ Kouta Takahashi, Youhei Shiraishi, Tatsuji Nakagome, and Fumishige Nishikawa*

Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, Science University of Tokyo, Kagurazaka, Shinjuku, Tokyo 162, Japan; and *Battery Development Laboratory, Asahi Chemical Industry, Ltd., Yoko, Kawasaki, Kanagawa 210, Japan

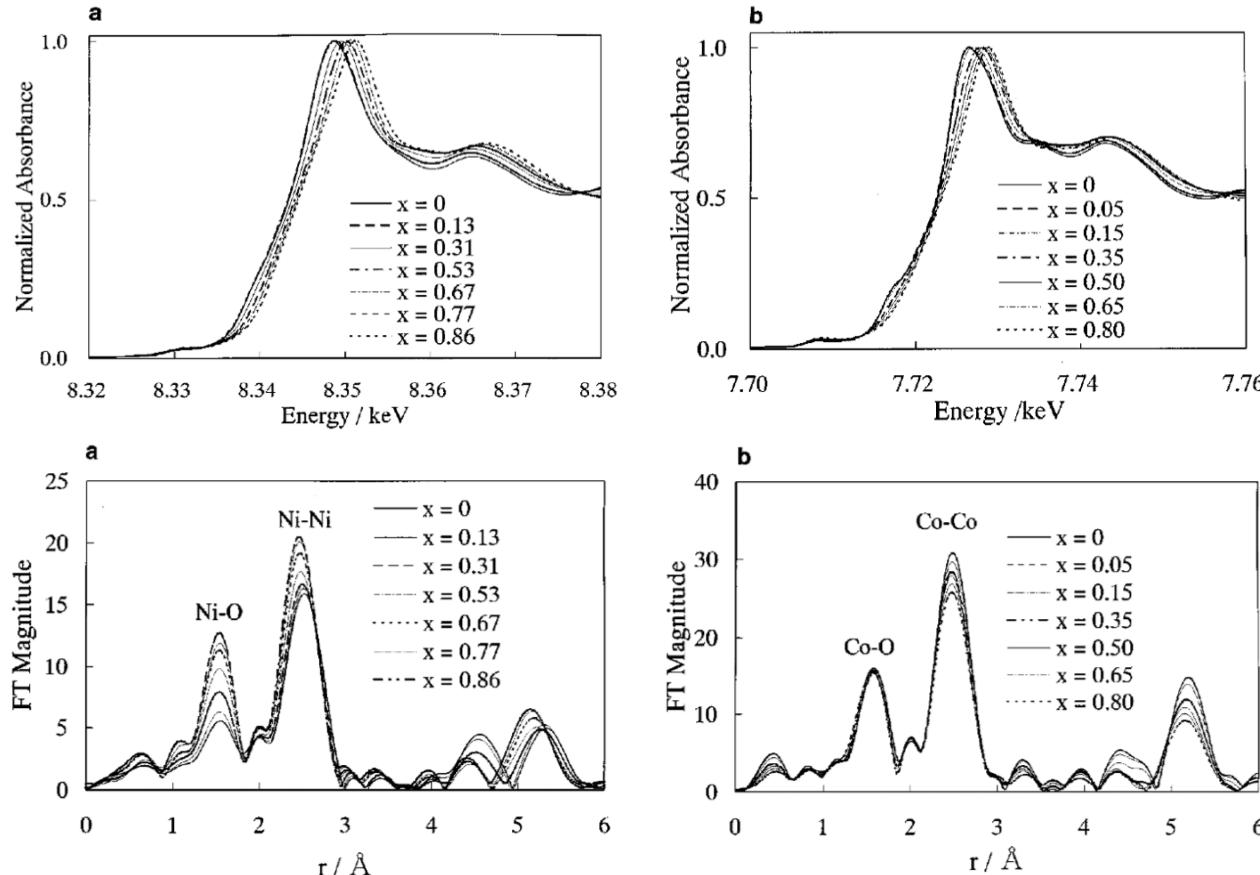
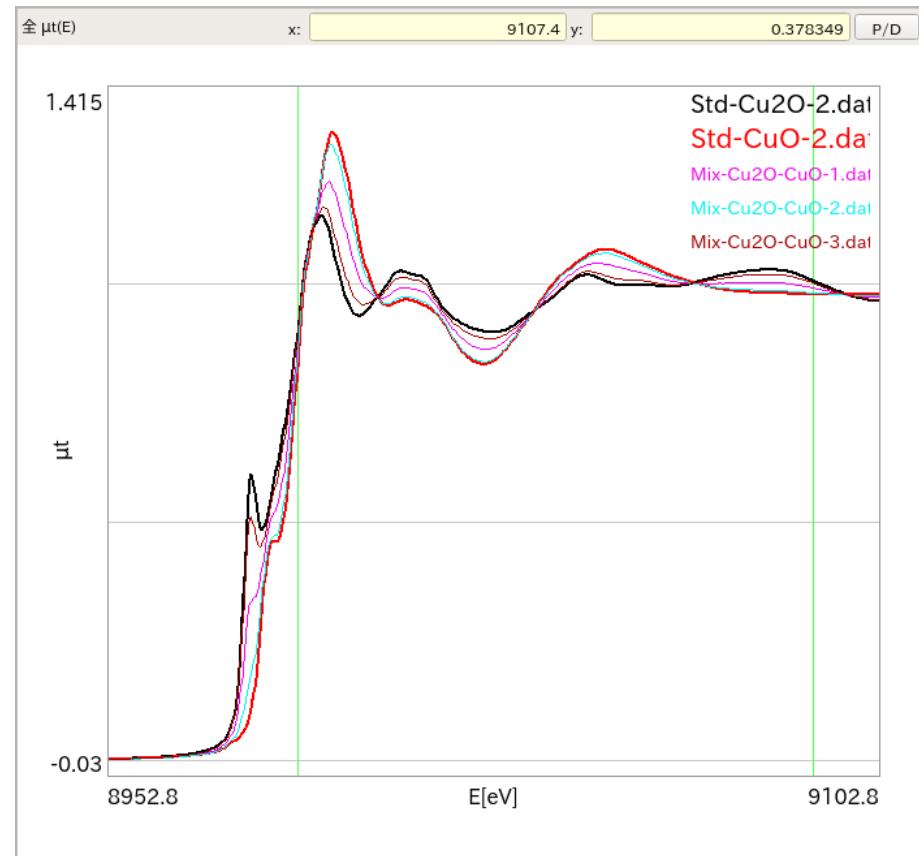
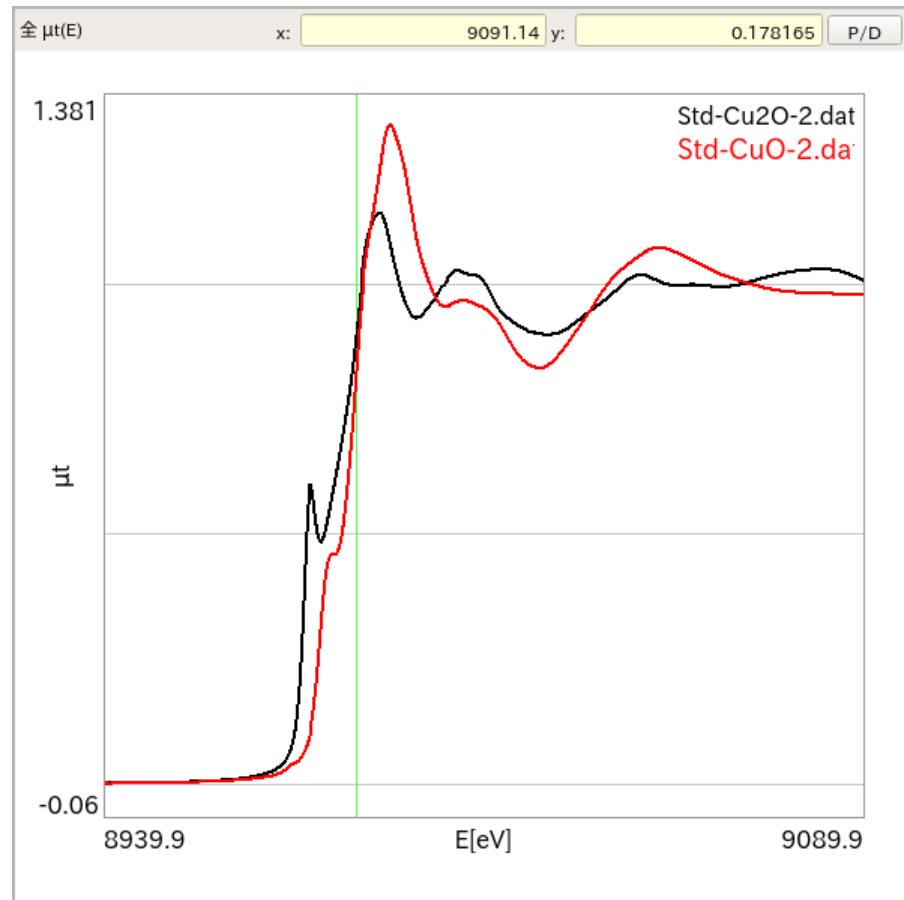


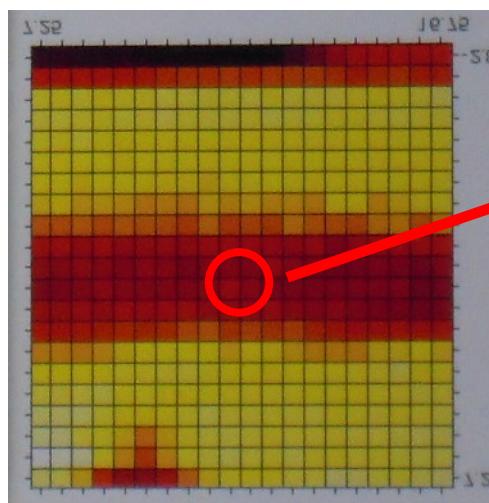
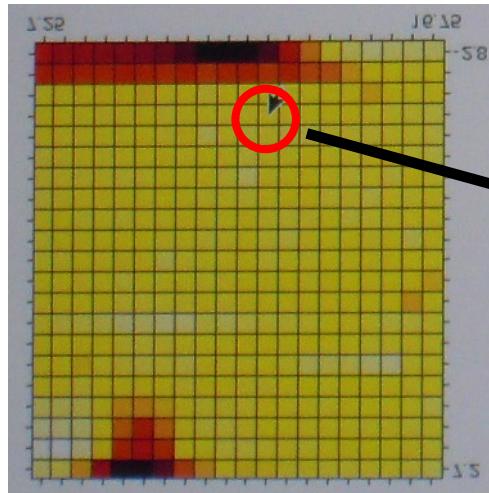
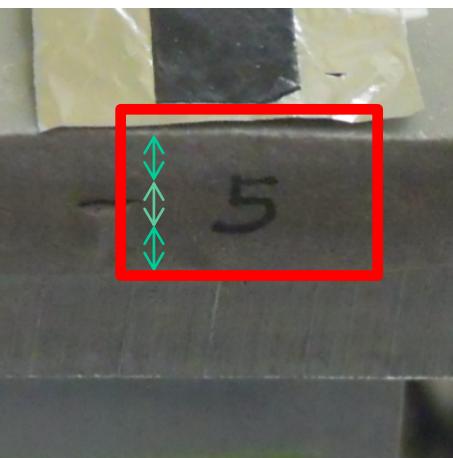
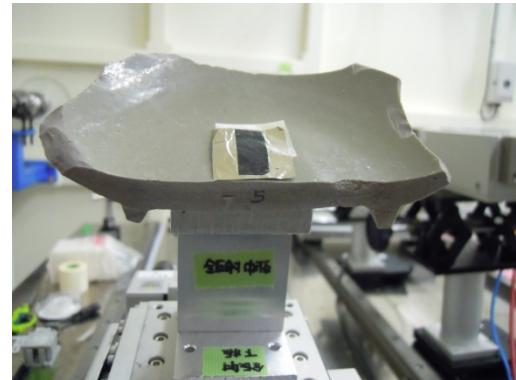
FIG. 2. The Fourier transforms of the Ni K-edge and Co K-edge EXAFS spectra of (a) $\text{Li}_{1-x}\text{NiO}_2$ and (b) $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$ as a function of x . The Fourier transforms are not corrected for the phase shifts.

XANESでは充電に伴うピークシフトが明瞭。

EXAFSスペクトルはNiイオンは初期状態で4+2に歪んだ6配位と考えると説明できる。

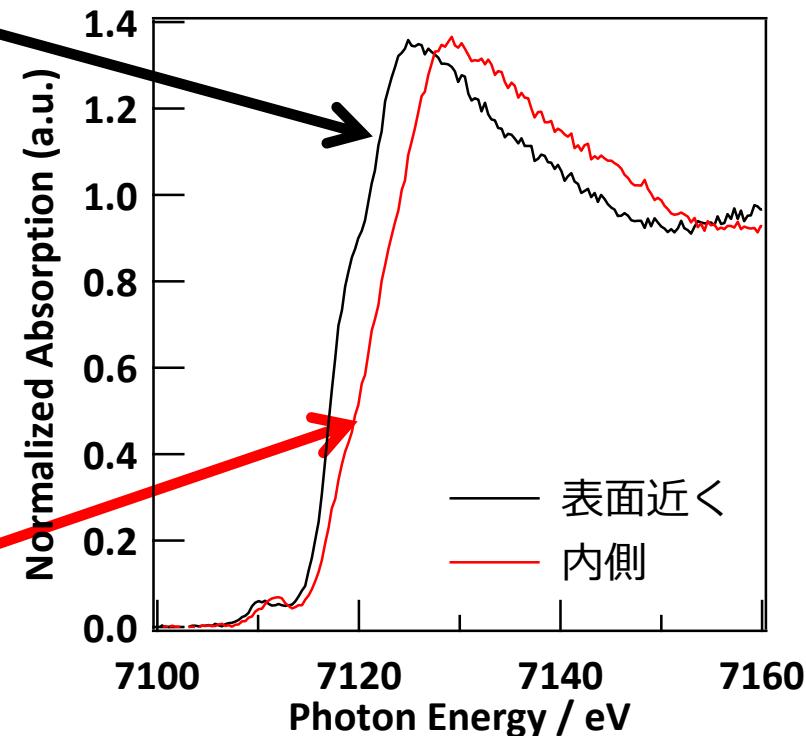


陶磁器に含まれる鉄 価数選別二次元マッピング



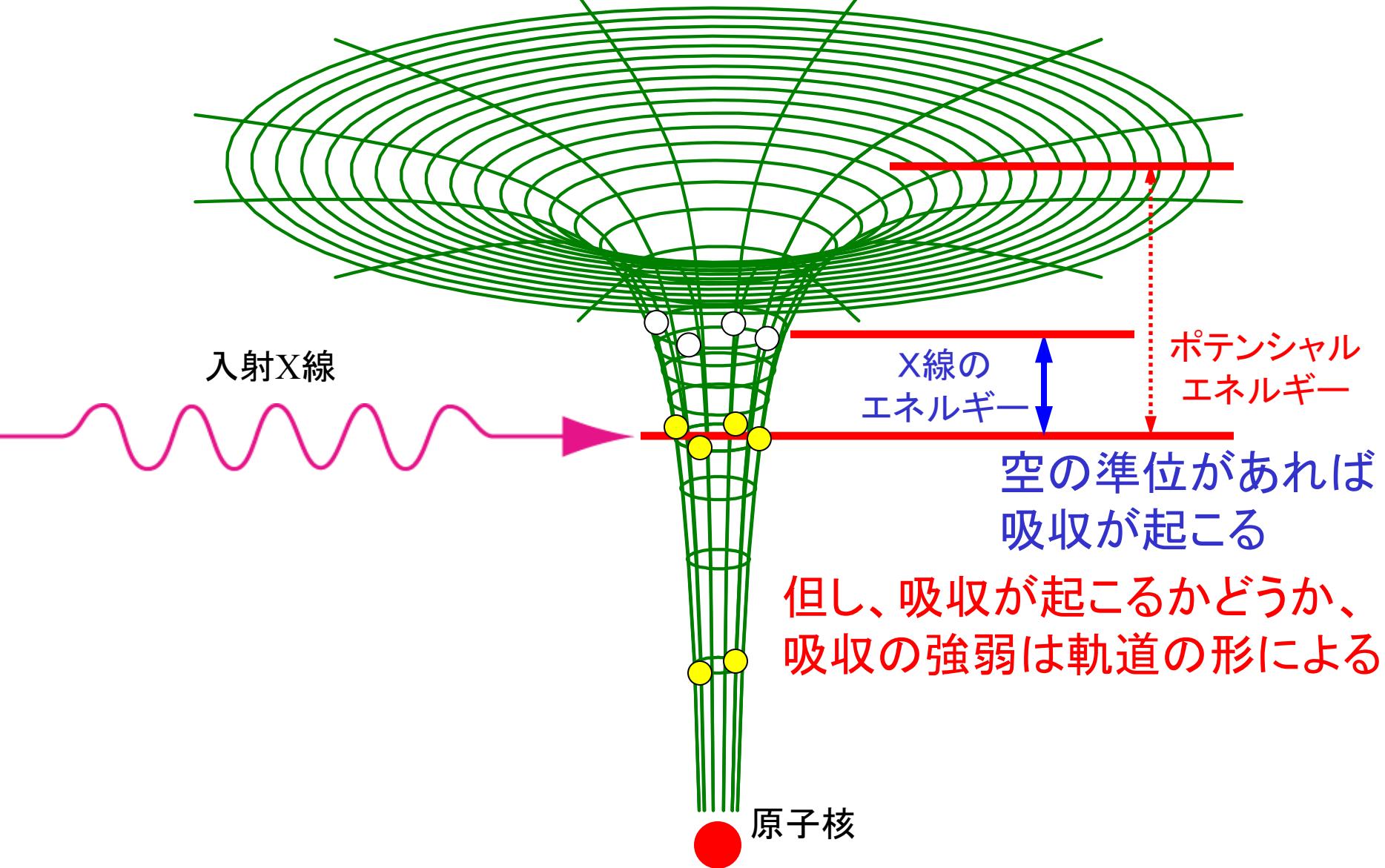
主に Fe^{2+} (7.12keV励起)

全 Fe (8keV励起)



表面から Fe の還元が進行

XANES に見られる変化 (2) : 軌道形状(結合状態)



双極子近似による吸収係数

$$\mu \propto \sum_f |\langle \psi_f | \hat{e} \cdot \mathbf{r} | \psi_i \rangle|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega)$$

$$\langle \psi_f | x | \psi_i \rangle = \int \psi_f^* x \psi_i dx$$

↓
「終」状態の波動関数 「始」状態の波動関数

「始」状態が原子に束縛された状態なら、

1) その波動関数は小さな範囲でだけ値を持つので、

終状態の波動関数の吸収原子の位置での大きさが重要

「始」状態が S 軌道、外乱部分が x (直線偏向の光) なら、

2) 「終」状態の平面波は x 方向に進行する。

3) 「終」状態が、x 方向の奇関数の時、吸収が大きくなる
偶関数の時、小さくなる。

双極子近似による吸収係数

$$\mu \propto \sum_f |\langle \psi_f | \hat{e} \cdot \mathbf{r} | \psi_i \rangle|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega)$$

$$\langle \psi_f | x | \psi_i \rangle = \int \psi_f^* x \psi_i dx$$

↓
「終」状態の波動関数 「始」状態の波動関数

「始」状態が S 軌道、外乱部分が x (直線偏向の光) なら、

- 2) 「終」状態の平面波は x 方向に進行する。
- 3) 「終」状態が、x 方向の奇関数の時、吸収が大きくなる
偶関数の時、小さくなる。

1s(K殻)からの遷移 => 必ず p 軌道

2s(L3)からの遷移 => 必ず p 軌道 2p(L2, L1) => s 又は d

XAFS Study of Ti-Silicalite: Structure of Framework Ti(IV) in the Presence and Absence of Reactive Molecules (H_2O , NH_3) and Comparison with Ultraviolet–Visible and IR Results

S. Bordiga, S. Coluccia, C. Lamberti,[†] L. Marchese, and A. Zecchina*

Dipartimento di Chimica Inorganica, Chimica, Fisica e Chimica dei Materiali,
Via P. Giuria 7, I-10125 Torino, Italy

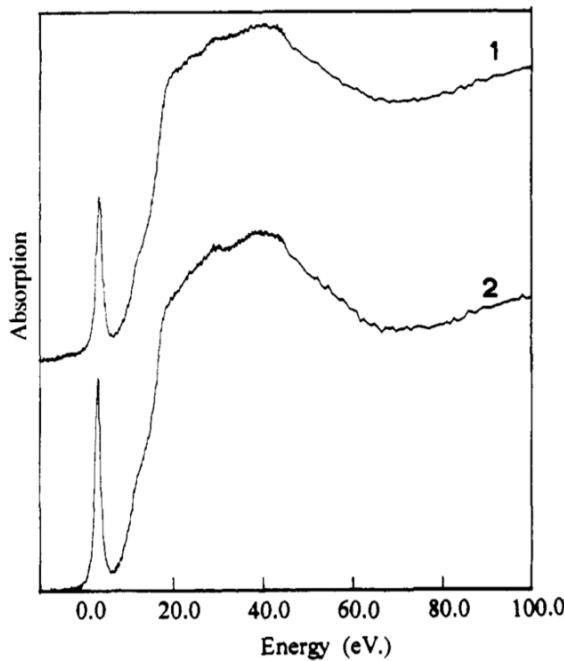


Figure 1. XANES spectra of Ti-silicalite: (1) [TSA] outgassed at 300 K; (2) [TSA] outgassed at 400 K. (The zero of the energy scale was taken at 4964.2 eV, which corresponds to the maximum of the first peak of a titanium foil K edge.)

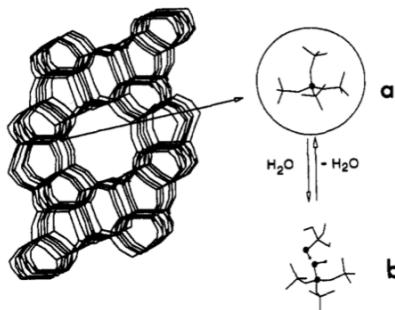


Figure 2. Silicalite framework where $[\text{TiO}_4]$ is substituting for a $[\text{SiO}_4]$ building unit. Inset a: $[\text{TiO}_4]$ unit surrounded by four $[\text{SiO}_4]$ units (the Ti(IV) center is represented by a black ball). Inset b: after water hydrolysis of a Ti–O–Si bridge shown in a inset a (black balls indicate Ti(IV) and hydroxyl groups).

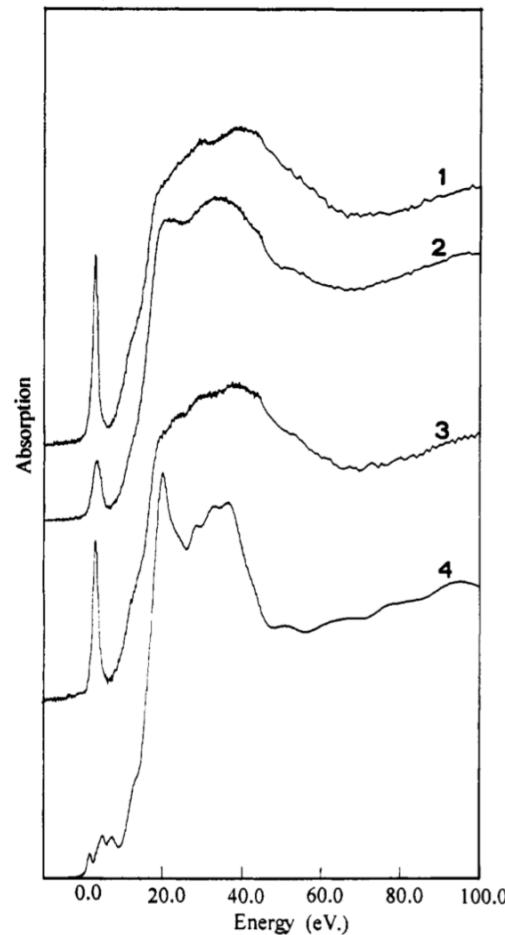
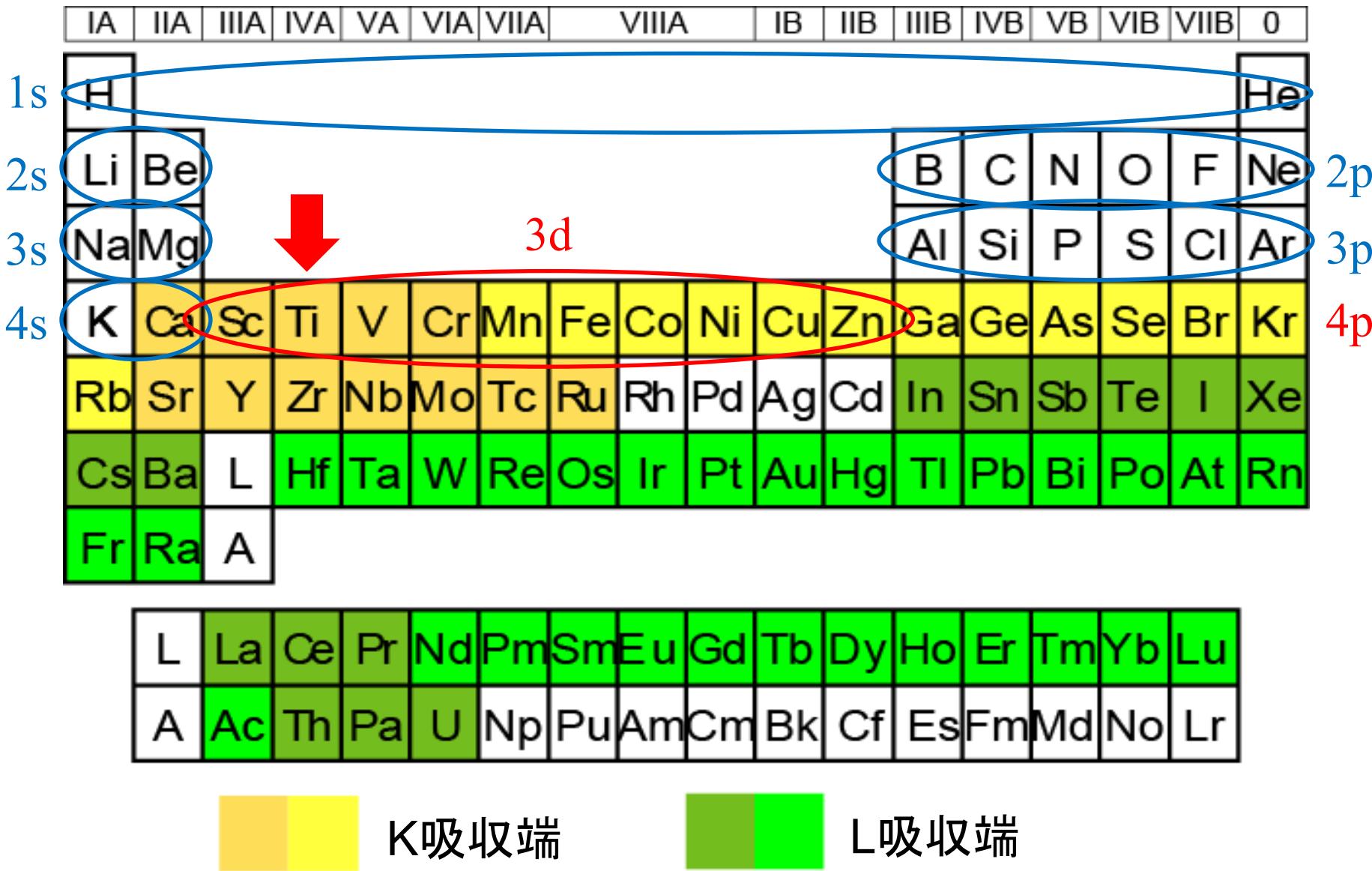


Figure 4. XANES spectra of [TSA] outgassed at 400 K, the effect of NH_3 adsorption and desorption: (1) [TSA] in vacuo; (2) after dosage of NH_3 (equilibrium pressure of 10^4 Pa); (3) effect of pumping at room temperature for 10 min (energy scale as in Figure 1); (4) TiO_2 (anatase).

Tiはシリケートの骨格に入り4配位となる。
その構造は吸湿・脱水で可逆的に変化する。
アンモニアとの反応で可逆的にアナターゼに近い構造を作る。

EXAFS測定可能な元素



XAFS Study of Ti-Silicalite: Structure of Framework Ti(IV) in the Presence and Absence of Reactive Molecules (H_2O , NH_3) and Comparison with Ultraviolet–Visible and IR Results

S. Bordiga, S. Coluccia, C. Lamberti,[†] L. Marchese, and A. Zecchina*

Dipartimento di Chimica Inorganica, Chimica, Fisica e Chimica dei Materiali,
Via P. Giuria 7, I-10125 Torino, Italy

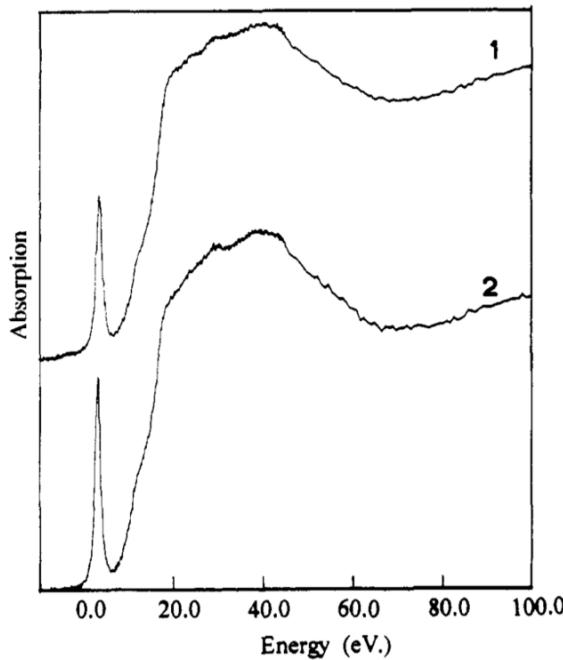


Figure 1. XANES spectra of Ti-silicalite: (1) [TSa] outgassed at 300 K; (2) [TSa] outgassed at 400 K. (The zero of the energy scale was taken at 4964.2 eV, which corresponds to the maximum of the first peak of a titanium foil K edge.)

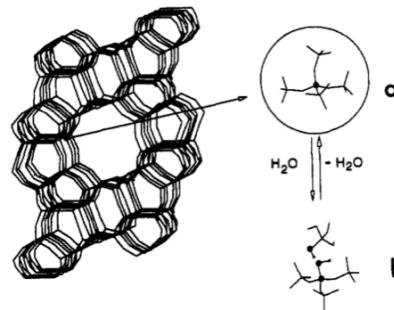


Figure 2. Silicalite framework where $[\text{TiO}_4]$ is substituting for a $[\text{SiO}_4]$ building unit. Inset a: $[\text{TiO}_4]$ unit surrounded by four $[\text{SiO}_4]$ units (the Ti(IV) center is represented by a black ball). Inset b: after water hydrolysis of a Ti–O–Si bridge shown in a inset a (black balls indicate Ti(IV) and hydroxyl groups).

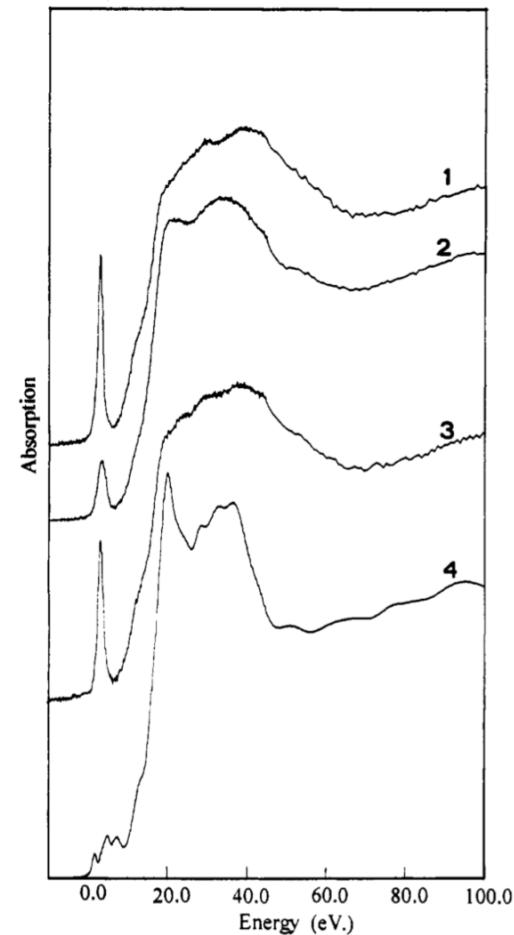
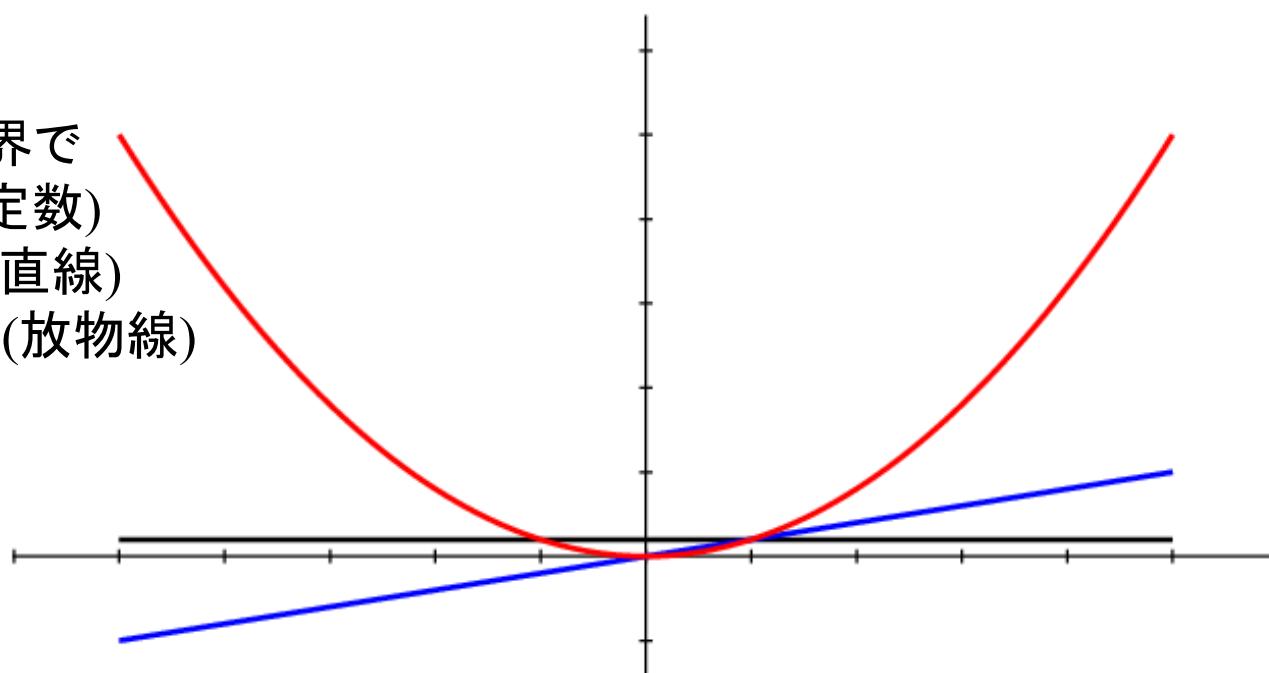


Figure 4. XANES spectra of [TSa] outgassed at 400 K, the effect of NH_3 adsorption and desorption: (1) [TSa] in vacuo; (2) after dosage of NH_3 (equilibrium pressure of 10^4 Pa); (3) effect of pumping at room temperature for 10 min (energy scale as in Figure 1); (4) TiO_2 (anatase).

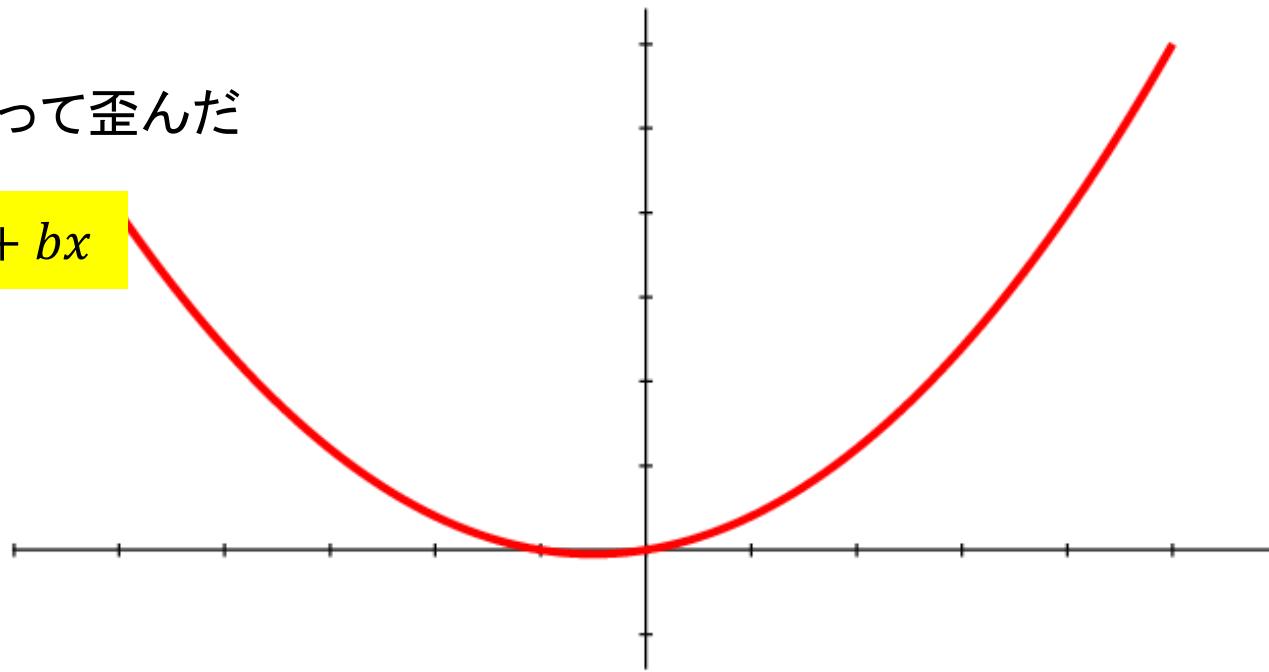
物質中の Ti の 3d 軌道の「形」は、
「理想的な 3d 軌道」の「形」とは異なる。
= 他の軌道の「形」が混ざる。

仮想の1次元世界で
s軌道 : $y = a$ (定数)
p軌道 : $y = bx$ (直線)
d軌道 : $y = cx^2$ (放物線)
だったとする。

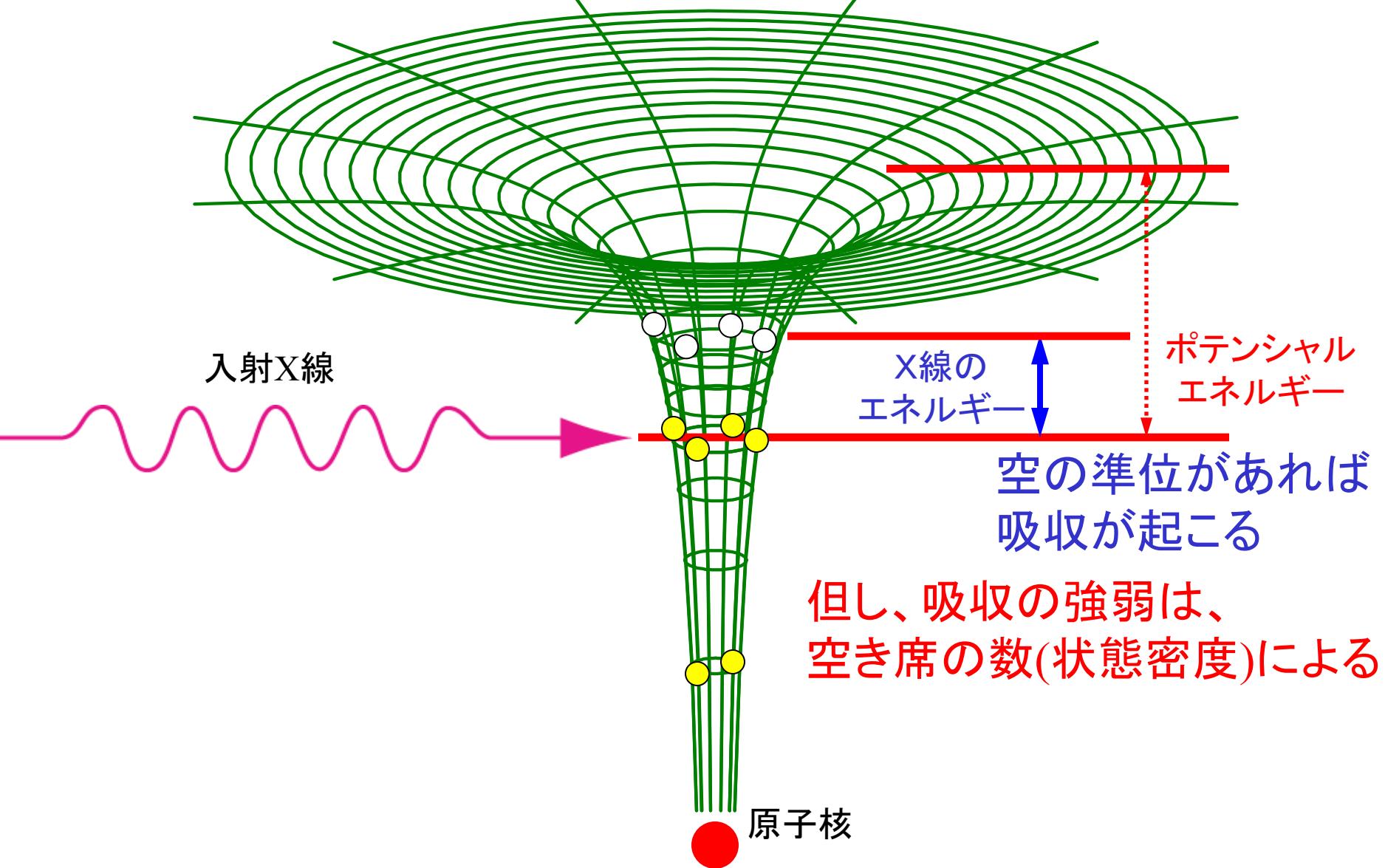


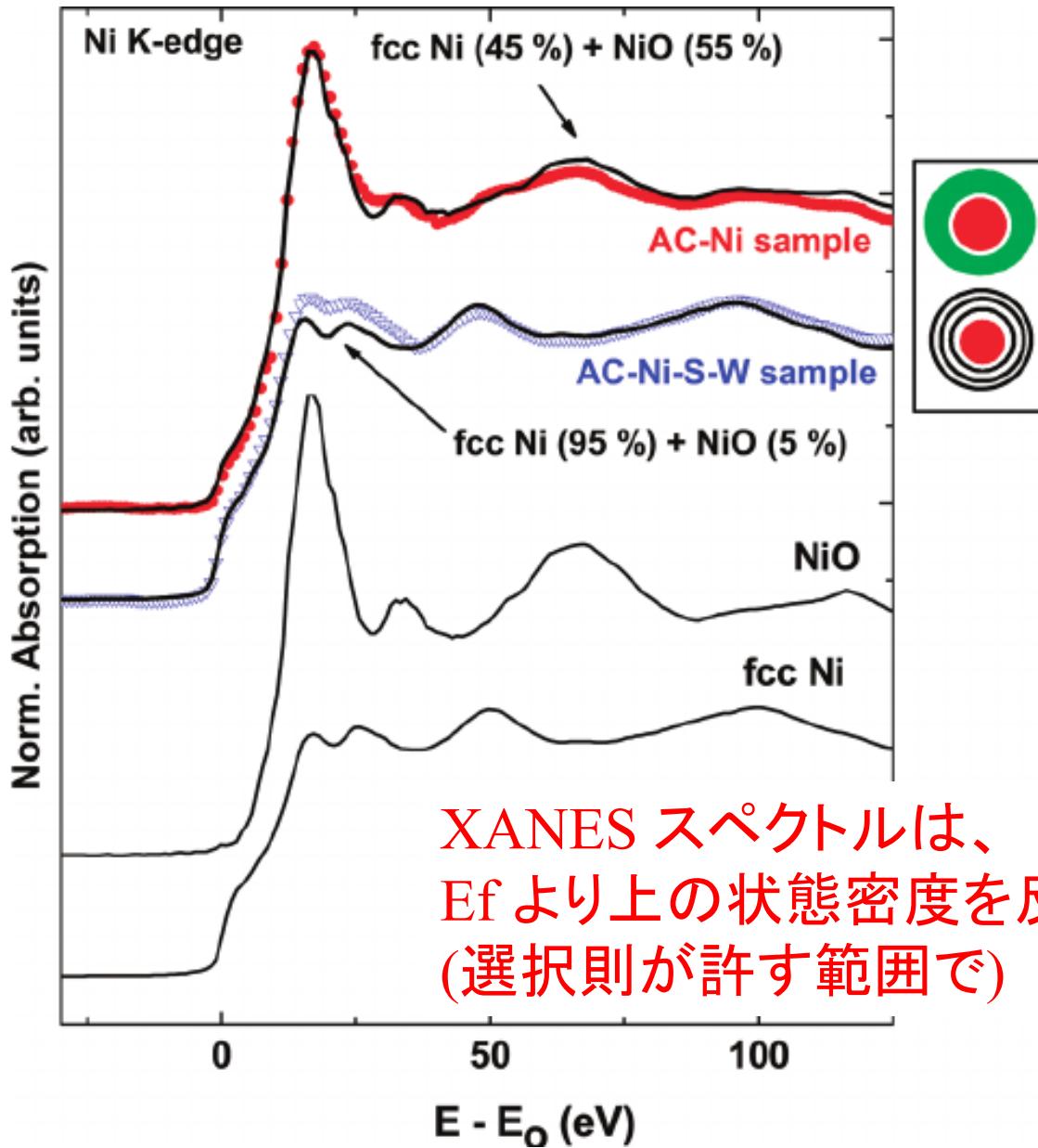
周囲の環境によって歪んだ
d軌道。

$$y = cx^2 + bx$$



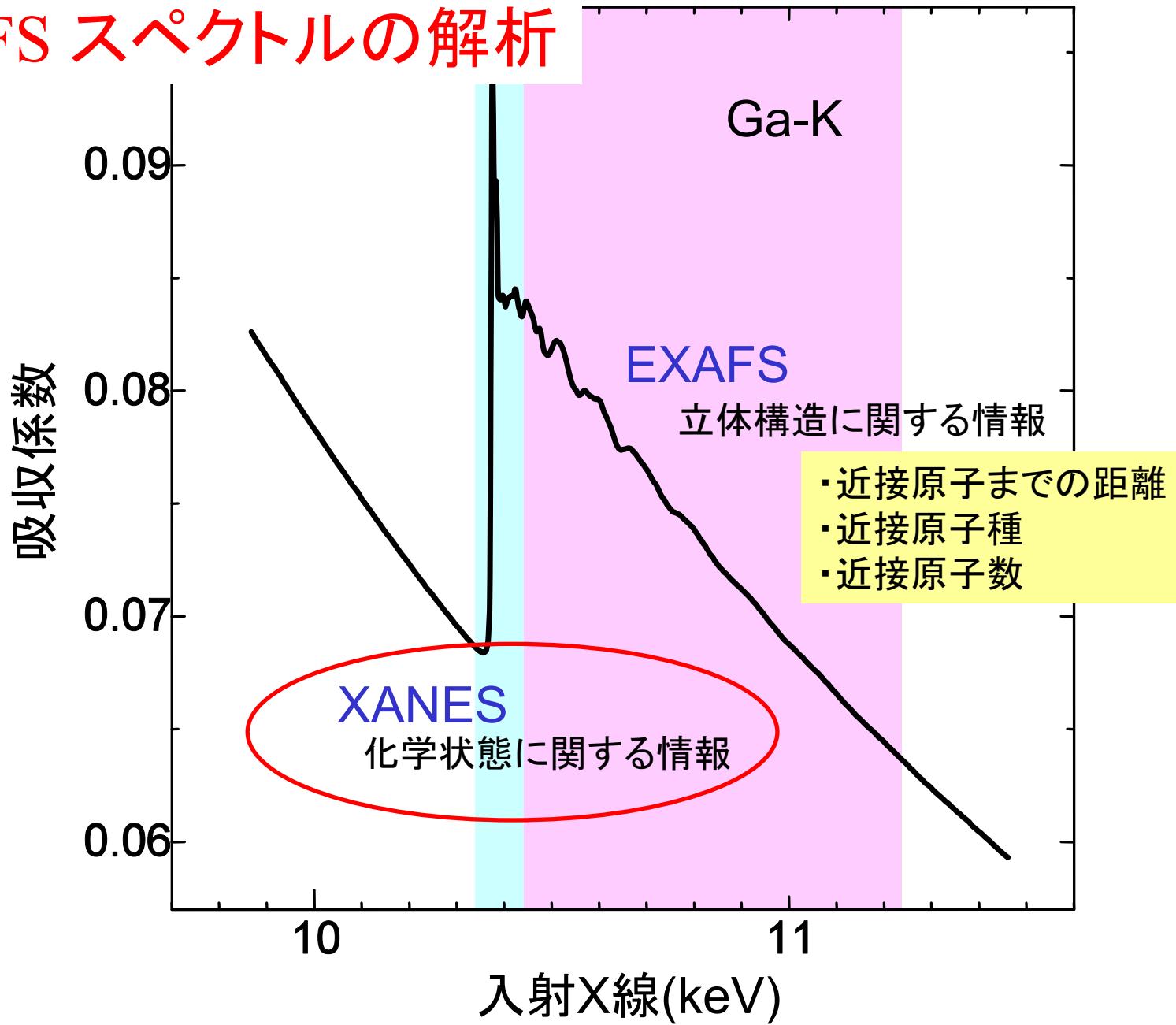
XANES に見られる変化 (3) : 状態密度(電子状態)





Enhanced protection of carbon-encapsulated magnetic nickel nanoparticles through a source-based synthetic strategy,
M.P. Fernandez-Garcia, P. Gorria, M. Sevilla, J.A. Blanco, J. Physical Chemistry C, 2013.

XAFS スペクトルの解析



XAFSスペクトルの解析

XANESスペクトル

原子の「状態」によって変わる。

「状態」 = 価数、軌道、スピン…

原子の「環境」には直接は依存しない。

「環境」 = 原子間距離、配位数、配位種、立体配置

間接的には依存する

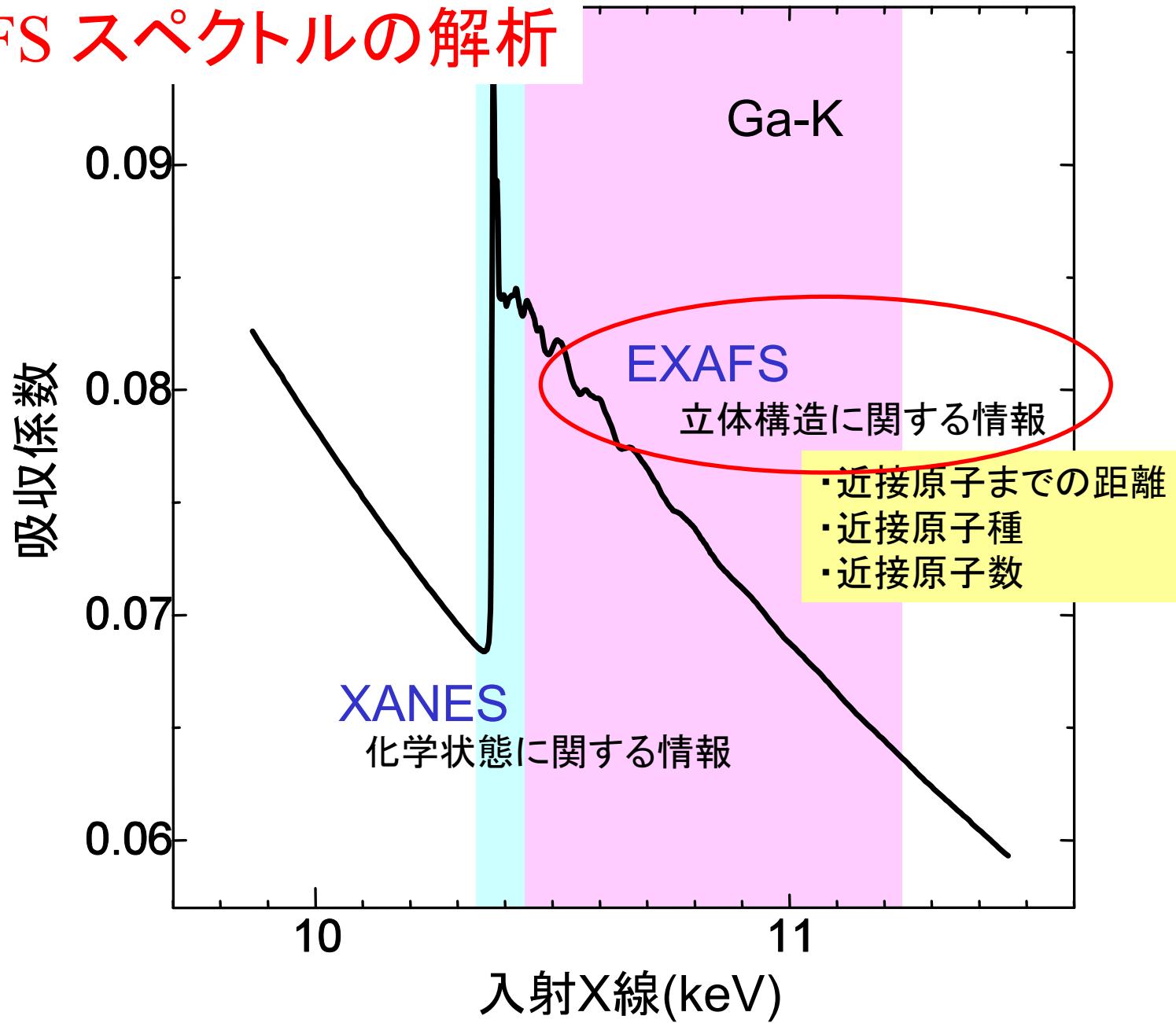
ex. 「原子間距離が変わると価数が変わる」

「配位数が変わると軌道の形が変わる」

ニワトリと卵

従って、パターン認識的に(絵として見て)解析できことが多い。
Athena/Artemis を使うなら、Athena の守備範囲。

XAFS スペクトルの解析



XAFSスペクトルの解析

EXAFSスペクトル

原子の「状態」の影響はほぼない。

「状態」 = 値数、軌道、スピン…

原子の「環境」によって変化する。

「環境」 = 原子間距離、配位数、配位種、立体配置

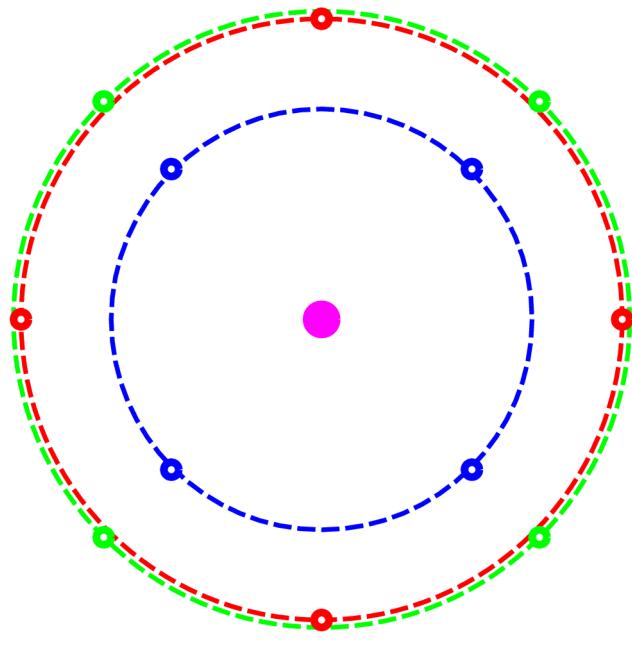
解析を行うには、「原子間距離」、「配位数」などのパラメータを取り込んだ「理論式」を立ててパラメータフィッティングを行う必要がある。

Athena/Artemis を使うなら、Artemis の出番。

シェル (Shell, 殻)

XAFSスペクトルは周辺原子までの
「距離」には依存するが、「方向」には依存しない。

同一種、等距離の原子の集合 = シェル



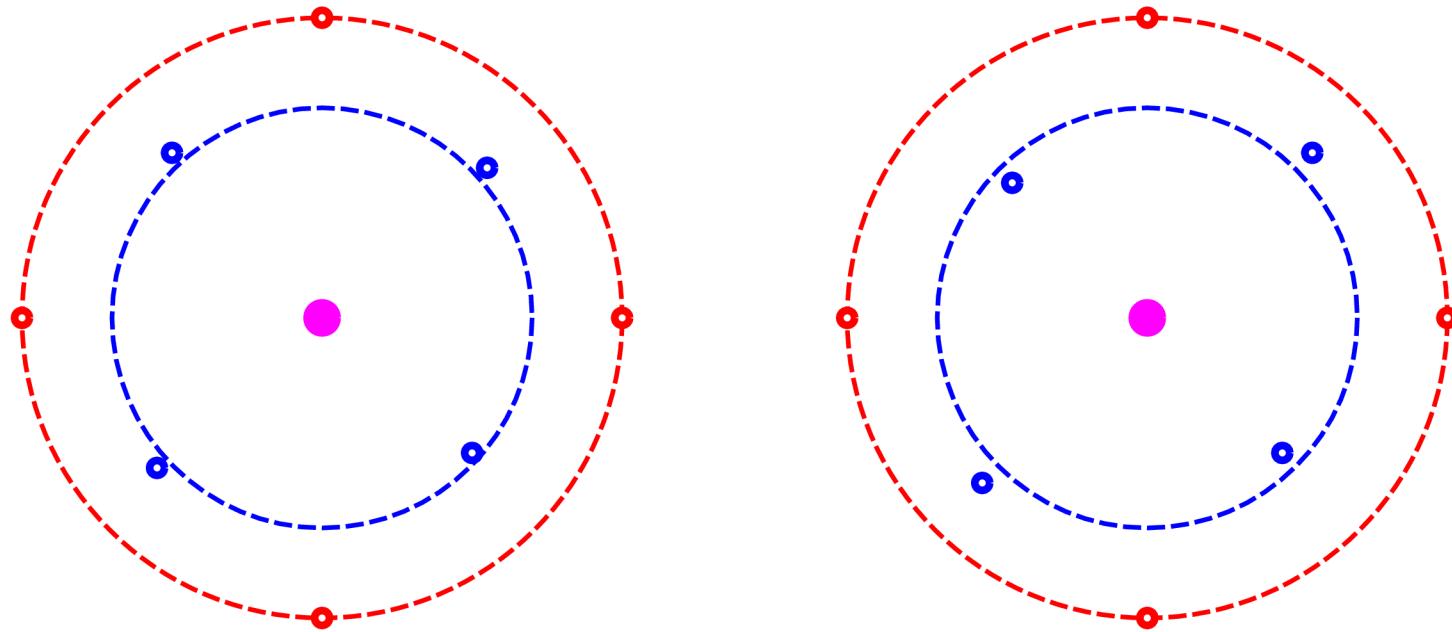
青原子4個が乗る青い丸はシェル
「第1シェル」「最近接シェル」…

赤原子4個が乗る赤い丸もシェル
「第2シェル」「第二近接シェル」…

緑原子は、種類が違うので第2シェル
には入れられない。独立のシェルを
作る。

EXAFS解析を行う際の一つのユニット。

シェル (Shell, 殻)



- ・一つのシェルに属する原子までの距離が多少異なっていても
「構造の乱れ」とられて、一つのシェルだとみなす。
- ・左の例は、原子位置が「ランダム」にズれているので
「乱れ」と捉えるしかない
- ・右の例は、規則的に配置がズれているので、二つのシェルに
分けて考えることも可能。
 - 1) 解析の目的としてこの距離の差を区別して情報を得たいか
 - 2) そのためにはパラメータの数が増えてしまう(解析の精度が下がる)
デメリットを受け入れられるか

一つのシェルに対する EXAFS の理論式 (解析のスタート地点)

振幅: 配位数

包絡線形状:

近接原子種

周期: 原子間距離

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k, \pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

励起効率の様な因子
1以下で、1に近い数字

位相因子

デバイワラ因子: 動的(熱的)、
静的な構造の乱れによる減衰

距離の異なる原子を
一つのシェルに押し込んだ

平均自由行程: 電子の到達
可能範囲に対応
多くの場合無視する
(無限大と考える)

各シェルに対してこの式が書ける

EXAFSスペクトルに含まれる情報

注意: $\chi(R)$ のピーク位置は
原子間距離 R そのものではない。 !!

包絡線形状:

振幅: 配位数

近接原子種

周期: 原子間距離

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k, \pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

位相因子

デバイワラ因子: 動的(熱的)、
静的な構造の乱れによる減衰

平均自由行程: 電子の到達
可能範囲に対応

EXAFSスペクトルに含まれる情報

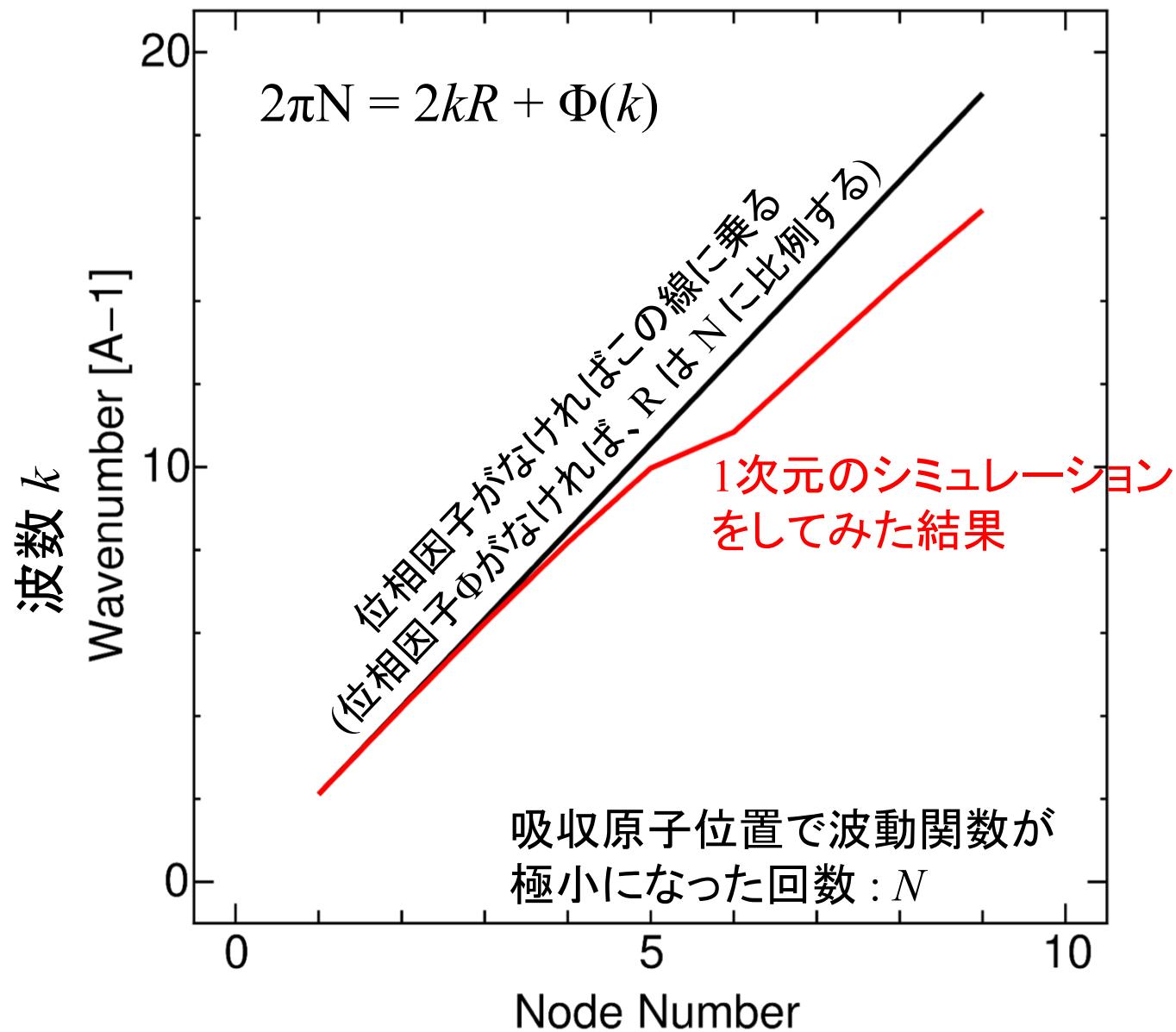
注意: $\chi(R)$ のピーク位置は
原子間距離 R そのものではない。 !!

$\emptyset(k) = C_0 + C_1k + C_2k^2 \dots$ の様に k の1次の項が
 $\emptyset(k)$ に含まれると、 \sin の中身は、
 $\sin\{2k(R + C_1) + C_0 + C_1k + C_2k^2 \dots\}$ となる。

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k, \pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

振動の周波数が $R + C_1$ に変わったことになるので
フーリエ変換したときのピーク位置も $R + C_1$ の位置にズレる。

位相因子？



一つのシェルに対する EXAFS の理論式 (解析のスタート地点)

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k, \pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

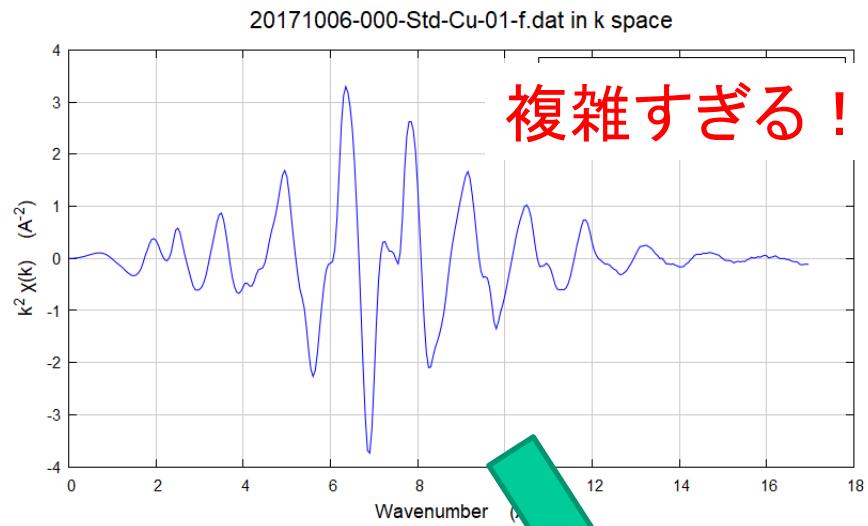
各シェルに対してこの式が書ける

従って全体としては、

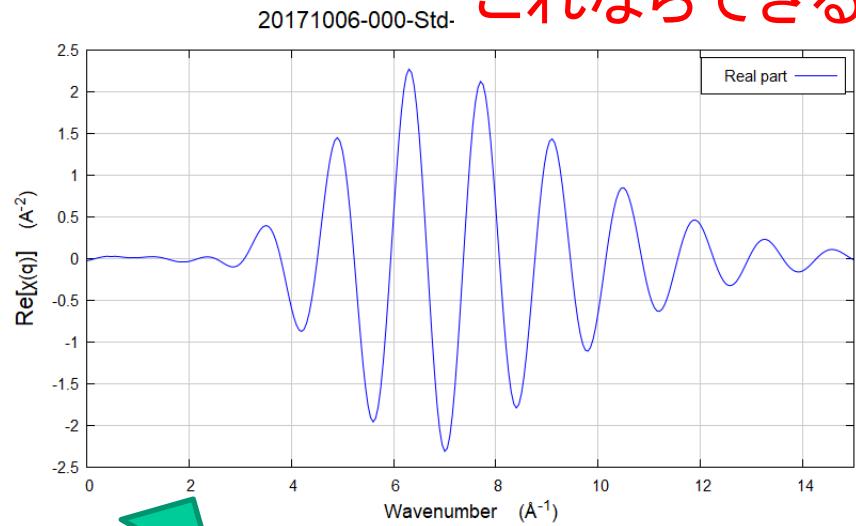
$$\chi(k) = \sum_{R, Element} \chi_{R, Element}(k)$$

多くの場合、複雑になりすぎる！

フーリエフィルタリング (2重フーリエ変換)

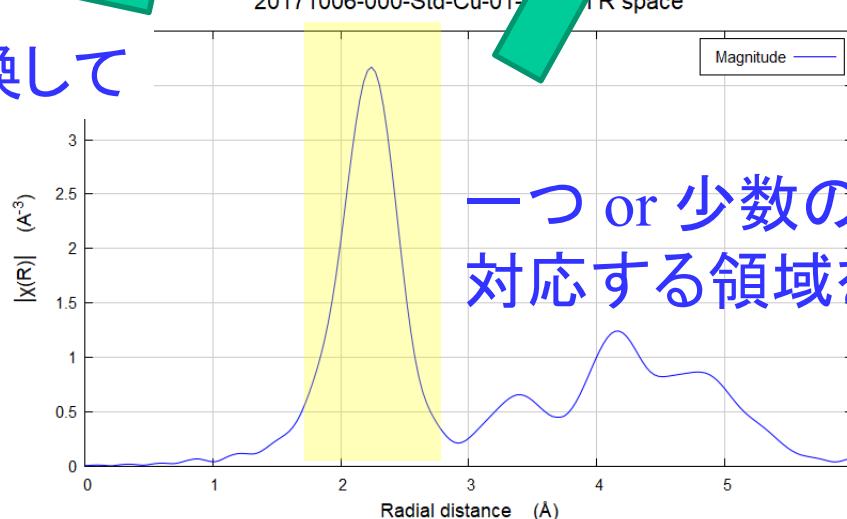


複雑すぎる！



これならできる！

フーリエ変換して



逆変換(再変換)

一つ or 少数のシェルに
対応する領域を選び

一つのシェルに対する EXAFS の理論式 (解析のスタート地点)

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k, \pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

たった一つのシェルに着目しただけで
こんなに多数のパラメータがある式を使って
どうやって解析を行うのか？

EXAFSスペクトルに含まれる情報

「ポータブル」なパラメータ

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k, \pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

包絡線形状:
近接原子種

位相因子

The diagram shows the EXAFS formula $\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k, \pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$. Three annotations are present: a red star above the first two terms pointing to the envelope shape and nearest neighbor atom type; a green arrow pointing to the phase factor $\phi(k)$; and another red star below the phase factor pointing to it.

ポータブルなパラメータは
「中心原子」、「中心原子と散乱原子のペア」の種類だけに依存する。

「中心原子」、「原子ペア」が同じなら他の系でも
同じ値を持つと考えて良い。

最も基本的な未知試料解析

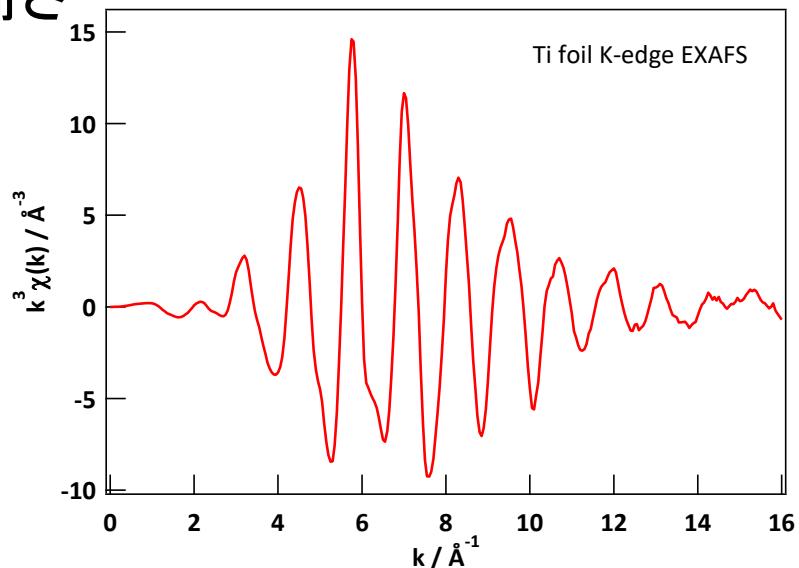
$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k, \pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

XAFSの式に含まれる未知量

S_0 、 N 、 f 、 R 、 Φ 、 σ 、 λ

1回の測定であらわにわかる独立の量は3つ。

- a) 振幅
- b) 振動のピークの位置
- c) 振動の個々のピークの高さ
(包絡線の形状)



最も基本的な未知試料解析

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k, \pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

XAFSの式に含まれる未知量

$$S_0, N, f, R, \Phi, \sigma, \lambda$$

1回の測定であらわにわかる独立の量は3つ。

a) 振幅 ここに数式を入力します。

$$S_0, N, (R)$$

b) 振動のピークの位置

$$R, \Phi$$

c) 振動の個々のピークの高さ

$$f, \sigma, \lambda, (R)$$

最も基本的な未知試料解析

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k, \pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

XAFSの式に含まれる未知量

$$S_0, N, f, R, \Phi, \sigma, \lambda$$

「標準」試料(N, R : 既知、 σ, λ : 適当に仮定)を測定。

a) 振幅

$$S_0, N, (R)$$

b) 振動のピークの位置

$$R, \Phi$$

c) 振動の個々のピークの高さ

$$f, \sigma, \lambda, (R)$$

→ S_0, Φ, f が決まる。

最も基本的な未知試料解析

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k, \pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

XAFSの式に含まれる未知量

$$S_0, N, f, R, \Phi, \sigma, \lambda$$

「未知」試料(N, R : 未知、 σ, λ : 適当に仮定)を測定。
(S_0, Φ, f は「標準」試料で決定済み)

a) 振幅

$$S_0, N, (R)$$

b) 振動のピークの位置

$$R, \Phi$$

c) 振動の個々のピークの高さ

$$f, \sigma, \lambda, (R)$$

→ N, R, f (原子種、組成)が決まる。

最も基本的な未知試料解析

本当の EXAFS スペクトル解析は 2ステップ

第1ステップ

「標準」試料(N 、 R : 既知、 σ 、 λ : 適当に仮定)を測定。

- a) 振幅 S_0 、 N 、(R)
 - b) 振動のピークの位置 R 、 Φ
 - c) 振動の個々のピークの高さ f 、 σ 、 λ 、(R)
- S_0 、 Φ 、 f が決まる。

第2ステップ

「未知」試料(N 、 R : 未知、 σ 、 λ : 適当に仮定)を測定。

- a) 振幅 S_0 、 N 、(R)
 - b) 振動のピークの位置 R 、 Φ
 - c) 振動の個々のピークの高さ f 、 σ 、 λ 、(R)
- N 、 R 、 f (原子種、組成)が決まる。

Artemis を使うと、第1ステップをシミュレーション(FEFF)で済ますことができるので一見、第2ステップしかないよう見える。

Artemis に関するもう一つの注意点

Artemis で標準試料のパラメータを FEFF を使って計算する場合、プログラムの流れに従うと

1. Atoms に構造の情報(cifファイル等)を渡して
FEFF の入力ファイルを作る
2. FEFF で計算を行い、Artemis で使う
後方散乱振幅、位相因子を得る

という手順になる。このため、XAFS解析のためには
あらかじめ「構造情報」を得る必要があるようと思われがち。

ほんとうは、Atoms の使用は必須では無い !!!!!

(EXAFSの理論式には距離は出てくるが立体配置は含まれない)

「吸収原子種」、「散乱原子種」、「2原子間距離(仮の数値)」
だけを書いた FEFF の入力ファイルを準備すれば十分 !!!!

Atoms + FEFF は、むしろ Athena を使ってスペクトルを
絵として眺めるときに使いましょう。

